

นิตยสารวัฒนธรรมและศิลปะไทย

นิตยสารวัฒนธรรมและศิลปะไทย
นิตยสารวัฒนธรรมและศิลปะไทย

นิตยสารวัฒนธรรมและศิลปะไทย จัดทำโดยสถาบันวิจัยศิลปะฯ
สำนักวิชาการศิลปะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นิตยสารวัฒนธรรมและศิลปะไทย
ปีที่ ๒๕๓๙

CONTRIBUTION



ใบรับรองโครงการทางวิศวกรรม สำนักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เรื่อง การออกแบบไมโครสตรีปและการประยุกต์ใช้งาน

โดย นางสาวมนัชพิพัฒนา อินทราวาส

นางสาวเนตรนภา สุขวัจนะ

ได้รับอนุมัติให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

คณบดี
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. ๒๕๔๐

คณะกรรมการสอบ

ประธานกรรมการ
(รศ.ดร. กรรณา ศุจิตร)

กรรมการ
(อ. สมศักดิ์ อาทิตยากร)

กรรมการ
(อ. แสงจันทร์ กำลูนเวสารัช)

กรรมการ
(อ. รังสรรค์ วงศ์สรรค์)

การออกแบบไมโครสเตรปและการประยุกต์ใช้งาน

นางสาวมนต์พิพิยา อินทรaruษ
นางสาวเนตรนภา สุขวัจนี

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม สำนักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีการศึกษา 2539

ชื่อนักศึกษา : นางสาวมนต์กิจพย়ภา อินทรารุษ
 : นางสาวเนตรนภา สุขวัจนะ
 ชื่อโครงการ : การออกแบบไมโครสเตริปและการประยุกต์ใช้งาน
 สาขาวิชา : วิศวกรรมโทรคมนาคม สำนักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ที่ปรึกษาโครงการ : อาจารย์รังสรรค์ วงศ์สรรศ์
 ปีการศึกษา : 2539

บทคัดย่อ

โครงการนี้ได้ทำการศึกษาทฤษฎีพื้นฐานของไมโครสเตริป และ พลักการออกแบบไมโครสเตริป เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานเป็นตัวกรองสัญญาณผ่านแคนบความถี่ต่ำ และ ตัวคัปเพลอร์แบบมีทิศทาง จากนั้นได้นำเอาทฤษฎีที่ได้ศึกษามานั้นไปทำการออกแบบตัวกรองสัญญาณผ่านแคนบความถี่ต่ำย่าน UHF โดยออกแบบให้มีค่าการลดตอนของสัญญาณเท่ากับ 3 dB ที่ความถี่ 500 MHz 600 MHz และ 800 MHz และในส่วนของตัวคัปเพลอร์แบบมีทิศทางนั้นได้ทำการออกแบบโดยการกำหนดค่าสัมประสิทธิ์ของการเชื่อมโยงของสัญญาณให้มีค่าเท่ากับ 15 dB ที่ความถี่ 800 MHz จากนั้นได้ทำการทดลองเพื่อคุณภาพสนองทางความถี่ของตัวกรองสัญญาณผ่านแคนบความถี่ต่ำ และ ผลตอบสนองกำลังงานการคัปปิงของตัวคัปเพลอร์แบบมีทิศทางที่สร้างขึ้น ในขั้นตอนสุดท้ายได้นำผลที่ได้จากการทดลองนั้นไปสรุป และวิเคราะห์เพื่อให้ทราบว่าอุปกรณ์ไมโครสเตริปที่สร้างขึ้นนั้นให้ผลตอบสนองตรงตามทฤษฎีหรือไม่ และ องค์ประกอบใดบ้างที่มีผลต่อผลอุปกรณ์ไมโครสเตริป

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณบิดา และมารดาที่ให้กำเนิด ให้การสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน และให้กำลังใจ
เสมอมา และขอขอบพระคุณท่านอาจารย์รังสรรค์ วงศ์สรรค์ ที่ให้คำปรึกษา และชี้แนวทาง
ในการทำโครงงานครั้งนี้ และที่ขาดเสียไม่ได้คือ ขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ
และให้กำลังใจ ตลอดเวลาที่ทำโครงงาน

ผู้จัดทำ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	๑
คิตติกรรมประกาศ	๒
สารบัญ	๓
สารบัญตาราง	๔
สารบัญรูป	๘
บทที่	
1. บทนำ	
1.1 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ	๑
1.2 ขอบเขตของงาน	๑
1.3 ขั้นตอนการทำงาน	๑
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	๒
2. ทฤษฎีพื้นฐาน	
2.1 กล่าวนำ	๓
2.2 ไมโครสตริป	๓
2.3 โครงสร้างและการส่งผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในไมโครสตริป	๕
2.4 ทฤษฎีพื้นฐานในการออกแบบตัวกรองสัญญาณผ่านแอนด์ความถี่ต่ำ	๑๒
2.5 ทฤษฎีพื้นฐานในการออกแบบตัวคัปเปลอร์แบบมีทิศทาง	๑๖
2.6 สรุป	๒๖
3. การออกแบบไมโครสตริปเพื่อประยุกต์ใช้งานและวิธีการทดลอง	
3.1 กล่าวนำ	๒๗
3.2 ตัวกรองสัญญาณผ่านแอนด์ความถี่ต่ำในย่าน UHF	๒๗
3.3 ตัวคัปเปลอร์แบบมีทิศทาง	๓๖
3.4 สรุป	๔๒
4. ผลการทดลอง	
4.1 กล่าวนำ	๔๓

สารบัญ

	หน้า
4.2 ผลการทดลองหาผลตอบสนองทางความถี่ของตัวรองสัญญาณ ผ่านແກບຄວາມຄືຕໍ່ໃນຍ່ານ UHF	43
4.3 ผลการทดลองหาผลตอบสนองກຳລັງງານກາຮັກປັບປຸງຂອງຕັກປະເປດອົງ ແບນມືທີສຫາງ	49
4.4 ສຽງ	50
5. ສຽງແລະ ວິເຄຣະໜີ້ຜູ້ໄດ້ຈາກກາຮັກ	
5.1 ກລ່າວນໍາ	51
5.2 ສຽງຜູ້ໄດ້ຈາກກາຮັກ	51
5.3 ວິເຄຣະໜີ້ຜູ້ໄດ້ຈາກກາຮັກ	53
5.4 ປະໂຍືນໜີ້ໄດ້ຈາກໂຄຮງການ	54
ເອກສາຮ້າງອີງ	56
ປະວັດຜູ້ເພີ້ນ	57

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2.1 ค่าของชีนส์วนตันแบบความวิธีการของ Butterworth ของตัวกรองสัญญาณผ่าน แอนด์ความถี่ต่ำ	15
ตารางที่ 3.1 แสดงค่านาฬิกาและอินดักแตนซ์ที่ได้จากการคำนวณ	28
ตารางที่ 3.2 แสดงค่าของส่วนประกอบของไมโครสตอริปที่ค่าอิมพีเดนซ์ต่าง ๆ	28
ตารางที่ 4.1 ผลตอบสนองทางความถี่ เมื่อค่าการลดทอนของสัญญาณเท่ากับ 3 dB ที่ความถี่ 800 MHz	43
ตารางที่ 4.2 ผลตอบสนองทางความถี่ เมื่อค่าการลดทอนของสัญญาณเท่ากับ 3 dB ที่ความถี่ 600 MHz	45
ตารางที่ 4.3 ผลตอบสนองทางความถี่ เมื่อค่าการลดทอนของสัญญาณเท่ากับ 3 dB ที่ความถี่ 500 MHz	47

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 2.1 แสดงลักษณะของไมโครสตริปที่มีลักษณะเหมือนเส้นลวดวางอยู่บนแผ่นกราวน์ที่ขาวเป็นอนันต์	4
รูปที่ 2.2 แสดงลักษณะโครงสร้างและส่วนประกอบของไมโครสตริป	5
รูปที่ 2.3 แสดงการแพร่กระจายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเมื่อมีการส่งผ่านคลื่นในไมโครสตริป	5
รูปที่ 2.4 แสดงโครงสร้างของไมโครสตริปที่มีค่า W/h ต่างกัน	9
(ก) $W/h >> 1$ และ (ข) $W/h << 1$	
รูปที่ 2.5 ลักษณะของกระแสและสนามไฟฟ้าในบริเวณที่เกิดสเตป	10
รูปที่ 2.6 วงจรสามัญของรูปลักษณะสเตปซึ่งมีส่วนประกอบของอิมพีเดนซ์แยกเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน	11
รูปที่ 2.7 แสดงถึงไมโครสตริปที่ทำการขาดแซกการเกิดฟริงกิ้งค่าปาชิแทนซ์เนื่องจากการเกิดสเตป	12
รูปที่ 2.8 ต้นแบบ n -section ของตัวกรองสัญญาณผ่านແນບความถี่ต่ำซึ่งมีอินดักเตอร์ k_1 เป็นส่วนแรก	12
รูปที่ 2.9 แสดงผลตอบสนองของตัวกรองสัญญาณผ่านແນບความถี่ต่ำในรูปการลดthon/ความถี่	13
รูปที่ 2.10 ผลตอบสนองของตัวกรองสัญญาณผ่านແນບความถี่ต่ำโดยวิธีการของ Butterworth	15
รูปที่ 2.11 แสดงແນບสตริปที่เกิดการคัปปลิงในตัวคัปปลอร์ແນບมีทิศทาง	16
รูปที่ 2.12 พารามิเตอร์สำหรับແນບไมโครสตริปที่เกิดการคัปปลิง	18
รูปที่ 2.13 สนามไฟฟ้าที่แพร่กระจายไปตามไมโครสตริปที่เกิดการคัปปลิงของสัญญาณในโหนมคู่ และ โหนมคี่	19
รูปที่ 2.14 พารามิเตอร์ที่ขึ้นของสายส่งสัญญาณที่มีค่าลักษณะสมบัติทางอิมพีเดนซ์ Z_0	19
รูปที่ 2.15 แสดงระยะห่างระหว่างແນບไมโครสตริปที่เกิดการเชื่อมต่อและความกว้างของແນບไมโครสตริปที่เกิดการคัปปลิง	25

สารบัญ

	หน้า
รูปที่ 2.16 แสดงค่าสภาระยอมรับพัทธิทางไฟฟ้าประสิทธิ์ผลของโหมดคู่และโหมดคี่ ในการออกแบบคัปเปลอร์แบบมีทิศทาง	26
รูปที่ 3.1 ตัวกรองสัญญาณผ่านແນນຄວາມถີ່ຕໍ່ທີ່ມີຄ່າກາລດທອນເທົ່າກັນ 3 dB ທີ່ຄວາມຖີ່ 800 MHz	32
รูปที่ 3.2 แสดงອຸປະກິດແລະກາຮຕ່ອງອຸປະກິດໃນກາຮດລອງຫາພລຕອບສນອງທາງຄວາມຖີ່ ຂອງຕັກຮອງສັງຄູາຜ່ານແນນຄວາມຖີ່ຕໍ່ໃນຍ່ານ UHF	34
รูปที่ 3.3 ຮູບປ່າງຂອງໄໂຄຣສຕຣີປີທີ່ອຸປະກິດໃຫ້ມີລັກນະເສັ້ນເປັນຕັກຮອງສັງຄູາຜ່ານ ຜ່ານແນນຄວາມຖີ່ຕໍ່ໃນຍ່ານ UHF	35
รูปที่ 3.4 ແສດງກາຮຕ່ອງເຄື່ອງມືອີ່ທີ່ໃຊ້ໃນກາຮດລອງຫາພລຕອບສນອງທາງຄວາມຖີ່ ຂອງຕັກຮອງສັງຄູາຜ່ານແນນຄວາມຖີ່ຕໍ່ໃນຍ່ານ UHF	35
รูปที่ 3.5 ແສດງຮູບປ່າງຂອງຕັກັປັບປຸງແນນມີທີ່ຄວາມຖີ່ 800 MHz ແລະມີຄ່າສັນປະສິບຂອງກາຮເຊື່ອມຕໍ່ເທົ່າກັນ 15 dB	38
รูปที่ 3.6 ແສດງອຸປະກິດແລະກາຮຕ່ອງອຸປະກິດໃນກາຮດລອງຫາພລຕອບສນອງກຳລັງຈານ ກາຮຕ່ອງຕັກັປັງຂອງຕັກັປັບປຸງແນນມີທີ່ຄວາມຖີ່ຕໍ່ໃນຍ່ານ	39
รูปที่ 3.7 ຮູບປ່າງຂອງໄໂຄຣສຕຣີປີທີ່ອຸປະກິດໃຫ້ມີລັກນະເສັ້ນເປັນຕັກັປັບປຸງ ແນນມີທີ່ຄວາມຖີ່ ບໍານາດຕໍ່າງ ฯ ທີ່ໃຊ້ໃນກາຮດລອງ	39
รูปที่ 3.8 ແສດງກາຮຕ່ອງເຄື່ອງມືອີ່ທີ່ໃຊ້ໃນກາຮດລອງຫາພລຕອບສນອງກຳລັງຈານກາຮຕ່ອງຕັກັປັງ ຂອງຕັກັປັບປຸງແນນມີທີ່ຄວາມຖີ່	40
รูปที่ 3.9 ເຄື່ອງ RF Generator 10 kHz-5.4 GHz ຂອງ MARCINI	40
รูปที่ 3.10 ເຄື່ອງ Spectrum Analyzer 9kHz-22 GHz ຂອງ IFR	41
รูปที่ 3.11 ເຄື່ອງ Spectrum Analyzer ຮູນ COM-120B ຂອງ IFR	41
รูปที่ 4.1 ກາຮຟແສດງພລຕອບສນອງທາງຄວາມຖີ່ມີອຸປະກິດໃຫ້ຄ່າກາລດທອນຂອງສັງຄູາຜ່ານ ເທົ່າກັນ 3 dB ທີ່ຄວາມຖີ່ 800 MHz	44
รูปที่ 4.2 ກາຮຟແສດງພລຕອບສນອງທາງຄວາມຖີ່ມີອຸປະກິດໃຫ້ຄ່າກາລດທອນຂອງສັງຄູາຜ່ານ ເທົ່າກັນ 3 dB ທີ່ຄວາມຖີ່ 600 MHz	46
รูปที่ 4.3 ກາຮຟແສດງພລຕອບສນອງທາງຄວາມຖີ່ມີອຸປະກິດໃຫ້ຄ່າກາລດທອນຂອງສັງຄູາຜ່ານ ເທົ່າກັນ 3 dB ທີ່ຄວາມຖີ່ 500 MHz	48

บทที่ 1

บทนำ

ไมโครสตริปเป็นสายนำสัญญาณที่สร้างบนแผ่นวงจรพิมพ์สองหน้า และใช้ในการเชื่อมโยงชิ้นส่วนต่าง ๆ ของวงจรทางความถี่สูง เนื่องจากไมโครสตริปมีน้ำหนักเบา กระหัครัด และไม่สืบเปลืองในการผลิตจึงทำให้ไมโครสตริปถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบัน ในโครงการนี้ได้ทำการศึกษาทฤษฎีพื้นฐาน และ การออกแบบไมโครสตริปเพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวกรองสัญญาณผ่านແคนความถี่ต่ำ และ ตัวคัปเปลอร์แบบมีทิศทาง จากนั้นได้ทำการสร้าง และ ทดสอบผลตอบสนองของอุปกรณ์ดังกล่าว

1.1 วัตถุประสงค์และเนื้อหาของโครงการ

- 1.1.1 เพื่อศึกษาทฤษฎีพื้นฐาน และ โครงสร้างของไมโครสตริป
- 1.1.2 สามารถออกแบบตัวกรองสัญญาณผ่านແคนความถี่ต่ำย่าน UHF และตัวคัปเปลอร์แบบมีทิศทางจากไมโครสตริปได้
- 1.1.3 สามารถสร้างตัวกรองสัญญาณผ่านແคนความถี่ต่ำย่าน UHF และตัวคัปเปลอร์แบบมีทิศทางจากไมโครสตริปได้

1.2 ขอบเขตของโครงการ

- 1.2.1 ศึกษาทฤษฎีพื้นฐาน และ โครงสร้างของไมโครสตริป
- 1.2.2 ทำการออกแบบ และ ทำการสร้างตัวกรองสัญญาณผ่านແคนความถี่ต่ำย่าน UHF และ ตัวคัปเปลอร์แบบมีทิศทาง
- 1.2.3 ทำการทดสอบ และ บันทึกผลที่ได้จากการทดสอบ
- 1.2.4 สรุปผล และวิเคราะห์ผลที่ได้จากการทดสอบ
- 1.2.5 สรุปผลที่ได้จากการออกแบบ

1.3 ขั้นตอนการทำงาน

- 1.3.1 ศึกษาทฤษฎีพื้นฐาน และ โครงสร้างของไมโครสตริป
- 1.3.2 ออกแบบไมโครสตริปให้เป็นตัวกรองสัญญาณผ่านແคนความถี่ต่ำย่าน UHF และ

ตัวคัปเปลอร์แบบมีทิศทาง

- 1.3.3 สร้างตัวกรองสัญญาณผ่านแคนความถี่ต่ำย่าน UHF และตัวคัปเปลอร์แบบมีทิศทางตามที่ได้ออกแบบไว้
- 1.3.4 ทดลองตัวกรองสัญญาณผ่านแคนความถี่ต่ำย่าน UHF และ ตัวคัปเปลอร์แบบมีทิศทางที่ได้สร้างไว้ และบันทึกผลที่ได้จากการทดลอง
- 1.3.5 สรุปผล และ วิเคราะห์ผลที่ได้จากการทดลอง

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

มีความรู้พื้นฐานของไมโครสตริปโดยสามารถนำไปประยุกต์ทำเป็นตัวกรองสัญญาณผ่านแคนความถี่ต่ำย่าน UHF และ ตัวคัปเปลอร์แบบมีทิศทางได้ รวมทั้งเทคนิคการปรับแต่งเพื่อให้ไมโครสตริปมีคุณสมบัติตามที่ต้องการ

บทที่ 2

ทฤษฎีพื้นฐาน

2.1 กล่าวนำ

ในปัจจุบันสัญญาณความถี่สูงถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายมาก เช่นสัญญาณไมโครเวฟเนื่องจากสัญญาณความถี่สูงมีข้อดีอยู่หลายประการ เช่นกำลังของสัญญาณสูงทำให้เดินทางได้ไกล สัญญาณมีภูมิต้านทานการรบกวนของสัญญาณรบกวน (Noise) สูง และ สายอากาศที่ใช้มีขนาดสั้นเป็นต้น ดังนั้นในโครงงานนี้จึงทำการศึกษาและสร้างอุปกรณ์ทางความถี่สูงโดยเลือกศึกษาและสร้างอุปกรณ์ทางความถี่สูงโดยใช้ไมโครสตริป ในการวิเคราะห์คุณสมบัติของอุปกรณ์ทางความถี่สูงจำเป็นต้องวิเคราะห์คุณสมบัติแบบกระจาย(Distributed) ซึ่งสามารถที่จะนำเอาคุณสมบัติแบบล้มปี้ (Lumped) ที่ใช้วิเคราะห์ห่วงจรไฟฟ้าทางความถี่ต่ำมาวิเคราะห์ได้ ในบทนี้ก่อนอื่นจะกล่าวถึงลักษณะทั่วไปของไมโครสตริป และ โครงสร้างของไมโครสตริปรวมทั้งการส่งผ่านของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในไมโครสตริป จากนั้นได้ทำการศึกษาถึงทฤษฎีในการออกแบบไมโครสตริปเพื่อนำไปประยุกต์สร้างเป็นคัวกรองสัญญาณผ่านแต่ความถี่ต่ำ และ ตัวคัปเปลอร์แบบมีทิศทางต่อไป

2.2 ไมโครสตริป

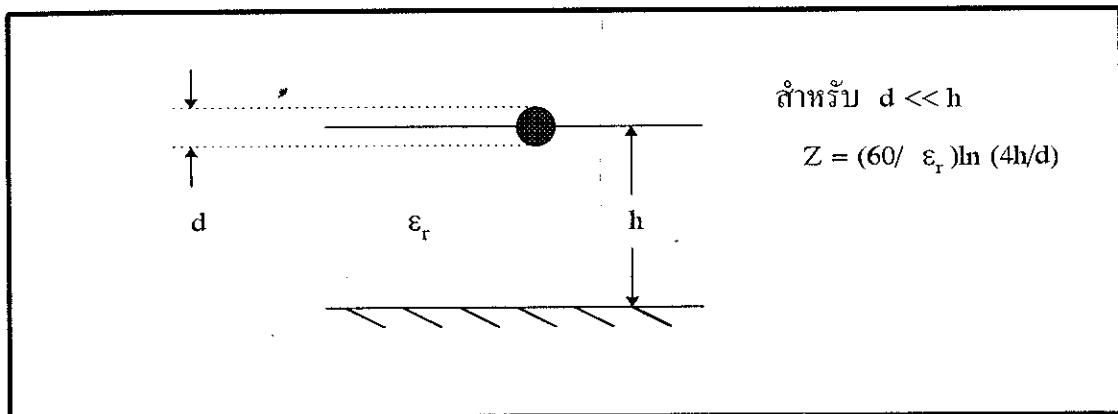
ไมโครสตริปเป็นประเภทหนึ่งของสายนำสัญญาณเช่นเดียวกับสายโคแอกเชียลและท่อนำคลื่น แต่ไมโครสตริปมีข้อแตกต่างจากสายโคแอกเชียลและท่อนำคลื่นคือ ไมโครสตริปไม่ได้สร้างมาจากลวดหรือท่อนำคลื่นแต่ย่างได แต่ไมโครสตริปสร้างมาจากแผ่นวงจรพิมพ์สองหน้า ในการออกแบบให้แบบไมโครสตริปมีค่าลักษณะสมบัติทางอิมพีเดนซ์ที่ต่างกัน ทำให้สามารถสร้างแทนไมโครสตริปให้เสมีອนเป็นคากาชิตเตอร์ อินดักเตอร์ ตัวแม่ตัวซ์ของหม้อแปลง ตัวเข็ม โยงกำลังงาน ตัวขับ และ อื่น ๆ อีกมากmany

ลักษณะของไมโครสตริปจะคล้ายกับลวดที่วางอยู่เหนือนอแพ่นกราวน์ ดังที่ได้แสดงไว้ในรูปที่ 2.1 ซึ่ง d คือ ความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของลวด ความยาวของลวดดังกล่าวมีผลต่อค่าอินดักเตนซ์ ค่า h คือ ความสูงจากจุดศูนย์กลางของลวดถึงแพ่นกราวน์ และ e คือค่าสภาพของทางไฟฟ้าของสารที่อยู่ระหว่างลวดกับแพ่นกราวน์ ค่าสภาพยอนลัมพัทธ์ทางไฟฟ้านี้มีผลต่อค่าคากาชิตเตนซ์ของแทนไมโครสตริปมาก ในกรณีที่ลวดนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กมากเมื่อเทียบ

กับระยะความสูงจากจุดศูนย์กลางของลวดถึงแผ่นกราวน์ ($d \ll h$) คลื่นจะมีการแพร่กระจายในโหมด TEM ซึ่งเหมือนคลื่นที่แพร่กระจายในสายโ Cooke 例外 ที่มีค่าสัญญาณบวกติดต่ออยู่ในพื้นที่ด้านนี้

$$Z = 60/\epsilon \ln(B/A) \quad (2.1)$$

เมื่อ A คือความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวนำด้านใน และ B คือความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวนำด้านนอก



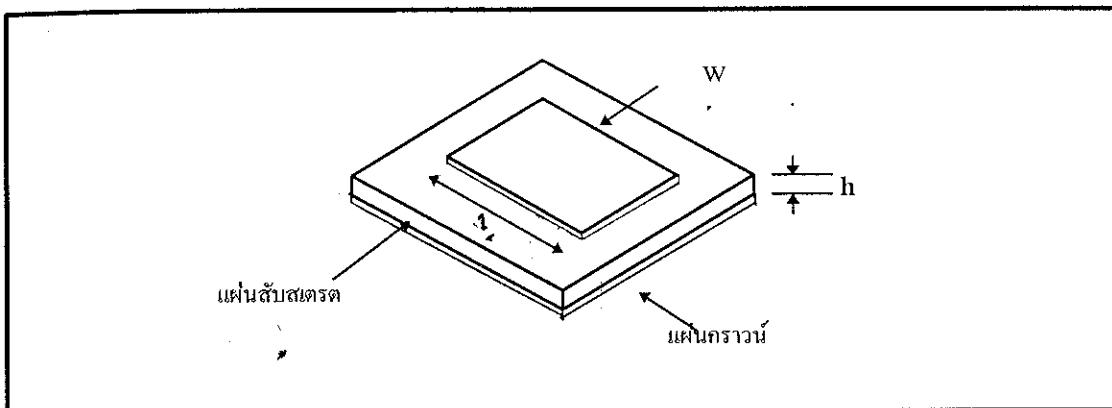
รูปที่ 2.1 แสดงลักษณะของไมโครสตริปที่มีลักษณะเหมือนเส้นลวดวางอยู่บนแผ่นกราวน์ที่ยาวเป็นอนันต์

ดังนั้นจากรูปที่ 2.1 เราสามารถเขียนสมการของค่าลักษณะสมบัติทางอิมพีเดนซ์ โดยมีความสัมพันธ์กับสมการ (2.1) ได้ดังนี้

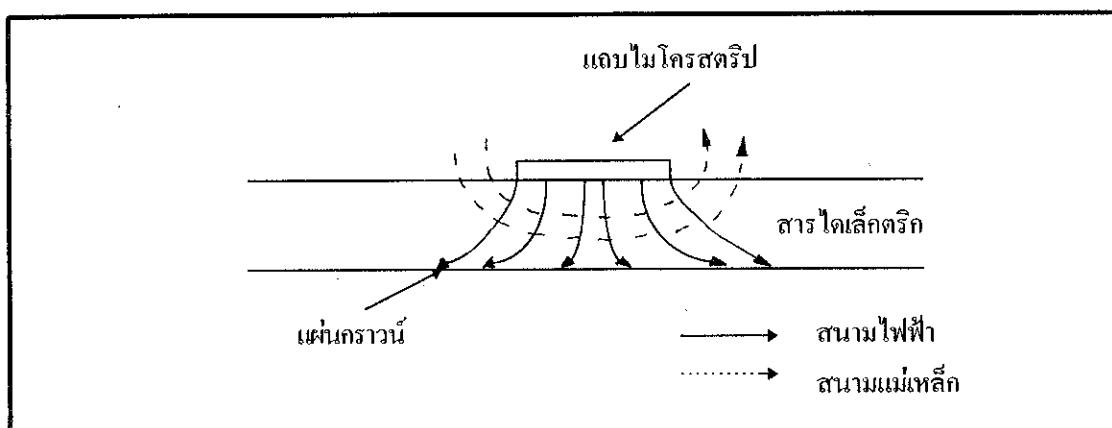
$$Z = (60/\epsilon) \ln(4h/d) \quad (2.2)$$

แต่ในความเป็นจริงแล้ว ค่าลักษณะสมบัติทางอิมพีเดนซ์ของแบบไมโครสตริปนี้ขึ้นชื่องกว่าค่าลักษณะสมบัติทางอิมพีเดนซ์ในสมการ (2.2) เนื่องจากไมโครสตริปที่ใช้ในความเป็นจริงนี้เป็นดังรูปที่ 2.2 ซึ่งทำได้โดยการนำแผ่นวงจรพิมพ์สองหน้านำมากัดลายออกเพียงด้านเดียว ส่วนอีกด้านหนึ่งนั้นยังคงเหลือไว้ให้เป็นตัวนำซึ่งเปรียบเสมือนแผ่นกราวน์ ดังนั้นแบบไมโครสตริปและแผ่นกราวน์จึงเป็นตัวนำที่ถูกขันด้วยสารไดเล็กทริกนี้เอง แบบไมโครสตริปหนึ่งๆ จะมีพฤติกรรมเหมือน capacitor ขนาดใหญ่ ในการเดียวกันเมื่อคลื่นแพร่กระจายไปตามแบบ

ไมโครสเตรปจะเกิดการการลดลงของสนามแม่เหล็กrom ๆ แทนไมโครสเตรปนั้น ดังนั้นแทนไมโครสเตรปนั้นจึงมีพฤติกรรมที่คล้ายกับอินดักเตอร์อนุกรมด้วยในเวลาเดียวกัน ซึ่งลักษณะของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่แพร่กระจายไปตามแนวนี้ไมโครสเตรปแสดงไว้ในรูปที่ 2.3



รูปที่ 2.2 แสดงลักษณะโครงสร้างและส่วนประกอบของไมโครสเตรป



รูปที่ 2.3 แสดงการแพร่กระจายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเมื่อมีการส่งผ่านคลื่นนั้นในไมโครสเตรป

2.3 โครงสร้างและการส่งผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในไมโครสเตรป

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงโครงสร้างและการส่งผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปตามไมโครสเตรป ตามลำดับซึ่งเป็นทฤษฎีพื้นฐานที่จำเป็นต้องศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการออกแบบคุปกรณ์ที่สร้างจากไมโครสเตรป

2.3.1 โครงสร้างของไมโครสเตรป

ไมโครสเตรปที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันนี้มีโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยแทนไมโครสเตรป หรือแทนทองแดงซึ่งตั้งบนลับสเตรต (Substrate) ที่เป็นสารไดเล็กทริกส่วนด้านล่างของสับสเตรต

เป็นค่าวิโละชนิดเดียวกับแบบไม่โครงสร้างปัจจุบันว่าแผ่นกราวน์นั่นเอง ซึ่งได้แสดงไว้ในรูปที่ 2.2 [6] ความกว้างของแบบไม่โครงสร้างปัจจุบันนี้อยู่กับค่าลักษณะสมบัติทางอิมพีเดนซ์ของแบบไม่โครงสร้างปัจจุบันนี้ซึ่งสัมบูรณ์ที่ใช้ทำแผ่นวงจรพิมพ์สองหน้านั้นมีด้วยกันหลายขนาด หนึ่งอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ ส่วนสารไดเล็กตริกที่นำมาใช้ทำเป็นสัมบูรณ์นี้มีอยู่หลายชนิด และแต่ละชนิดก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป ส่วนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นจะถูกส่งผ่านอยู่ภายในสัมบูรณ์ดังที่ได้แสดงไว้ในรูปที่ 2.3 นั่นเอง ซึ่งจะกล่าวถึงการส่งผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในไม่โครงสร้างโดยละเอียดในหัวข้อต่อไป

2.3.2 การส่งผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในไม่โครงสร้าง

ได้มีผู้ทำการศึกษาทางทฤษฎีแล้วพบว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ส่งผ่านไปตามไม่โครงสร้างนั้น ใกล้เคียงกับโหมด TEM มากแต่จะไม่ใช่โหมด TEM เสียที่เดียว เพราะมีสนามในแนวแกนอยู่ด้วย จึงนิยมเรียกโหมดดังกล่าวว่าโหมดกึ่ง TEM (Quasi-TEM) [1] จากรูปที่ 2.3 แสดงให้เห็นถึงเดินเรียงไฟฟ้าในระนาบตามขวางของไม่โครงสร้าง การที่มีสนามในแนวแกนอยู่บ้างนั้นเป็นเพราะไม่โครงสร้างมีโครงสร้างที่สารไดเล็กตริกและอากาศอยู่ในระนาบเดียวกันนั่นเอง

การที่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แพร่กระจายไปตามไม่โครงสร้างเป็นโหมดกึ่ง TEM นั้น พ่อนุ่มนิ่วเคราะห์ในโหมด TEM ได้ [1] ทำให้สามารถนำเอาหลักการของวงจรกระจายมาวิเคราะห์หากุณสมบัติของไม่โครงสร้างได้ กล่าวคือ ถ้าเราสามารถหาค่าอินดักเต้นซ์และค่าความต้านทานที่ต่อหนึ่งหน่วยความยาวได้ก็สามารถที่จะนำค่าทั้งสองนี้ไปคำนวณหาค่าลักษณะสมบัติทางอิมพีเดนซ์ของแบบไม่โครงสร้างได้ อาย่างไรก็ตามในการหาค่าความต้านทานที่ต่อหนึ่งหน่วยความยาวของไม่โครงสร้างจะยุ่งยากกว่าของสายคู่บานานหรือสายโทรศัพท์มาก เนื่องจากบริเวณที่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าส่งผ่านไปตามไม่โครงสร้างนั้นเป็นบริเวณที่มีห้องสารไดเล็กตริกและอากาศอยู่ แต่สำหรับในการหาค่าอินดักเต้นซ์ที่ต่อหนึ่งหน่วยความยาวนั้นจะไม่มีผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวแม้แต่อย่างใด ถึงแม้การหาค่าความต้านทานที่จะยุ่งยากกว่าปกติ แต่ก็มีวิธีการทำให้ง่ายขึ้นโดยการใช้วิธีการหาค่าคงตัวไดเล็กตริกสัมพัทธ์ประจำสิทธิ์ผล หรือ ค่าสภาพอนสัมพัทธ์ทางไฟฟ้าประจำสิทธิ์ผล (Effective Dielectric Constant ย่อว่า ϵ_{eff}) ของระบบซึ่งจะรวมผลของสารไดเล็กตริก และ อากาศเข้าด้วยกัน และ เนื่องจากสารไดเล็กตริกทั้งหลายมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปตามความถี่หรือมีดิสเพอร์ชันเชิงวัสดุ ดังนั้น ϵ_{eff} ที่หาได้ก็จะมีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามความถี่ด้วยเช่นกัน

เมื่อคลื่นถูกอนุโลมให้ส่งผ่านไปตามไม่โครงสร้างได้ในโหมด TEM ค่าลักษณะสมบัติทางอิมพีเดนซ์ Z_0 ของแบบไม่โครงสร้างสามารถเดินในรูปของผลหารระหว่างค่าอินดักเต้นซ์ต่อหนึ่งหน่วยความยาว (L) และ ค่าความต้านทานซึ่งจะคำนวณได้โดยใช้สูตร $Z_0 = \sqrt{\frac{L}{\epsilon_{eff}}}$

$$Z_o = \sqrt{L/C} \quad (2.3)$$

ในขณะเดียวกันความเร็วเฟส v_p ของไมโครสตริปสามารถเขียนได้ดังนี้

$$v_p = 1/\sqrt{LC} \quad (2.4)$$

จากสมการ (2.3) และ (2.4) นั้น สามารถเขียน Z_o ในรูปของ v_p กับ L หรือ C ดังนี้

$$Z_o = v_p L = 1/v_p C \quad (2.5)$$

ในขั้นต่อไปจะพิจารณาขณะที่สับสเตรตหรือสารไคลีคทริกนั้นอยู่ในกรณีที่ถูกดึงออกไปเหลือแต่อากาศเพียงอย่างเดียวที่โอบล้อมไมโครสตริปอยู่ กรณีที่อยู่ในสภาพเช่นนี้ความเร็วเฟสของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ส่งผ่านในสับสเตรตของไมโครสตริปนั้นจะมีค่าเท่ากับความเร็วแสงและค่าค่าปานิชณ์ต่อหนึ่งหน่วยความยาวจะเปลี่ยนไป โดยที่ค่าอินดักแทนซ์ต่อหน่วยความยาวจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ เมื่อให้ค่าค่าปานิชณ์ที่เปลี่ยนไปนี้มีค่าเป็น C_o จะได้ความสัมพันธ์ระหว่าง C_o กับความเร็วเฟสเป็นดังนี้

$$c = 1/\sqrt{LC_o} \quad (2.6)$$

ในขณะเดียวกันค่าลักษณะสมบัติทางอิมพีเดนซ์ของไมโครสตริปจะเขียนได้ดังนี้

$$Z_o = \sqrt{L/C_o} \quad (2.7)$$

เมื่อนำสมการ (2.6) หารด้วยสมการ (2.7) จะได้ผลดังนี้

$$C/C_o = (c/v_p)^2 \quad (2.8)$$

ในกรณีที่กำลังพิจารณาอยู่นี้ ค่าของ C/C_o นี้จะเปรียบเสมือนค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ทางไฟฟ้าประสิทธิผลของไมโครสตริปซึ่งสับสเตรตเป็นสารไคลีคทริกและมีด้านบนเป็นอากาศอยู่

$$\varepsilon_{\text{eff}} = (c/v_p)^2 \quad (2.9)$$

จากสมการข้างต้นสามารถเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง Z_0, Z_o และ ε_{eff} ได้ดังนี้

$$Z_o = Z_0 / \sqrt{\varepsilon_{\text{eff}}} \quad \text{หรือ} \quad Z_0 = Z_o \sqrt{\varepsilon_{\text{eff}}} \quad \text{หรือ} \quad \varepsilon_{\text{eff}} = (Z_o/Z_0)^2 \quad (2.10)$$

จากสมการ (2.10) จะเห็นได้ว่าเมื่อทราบค่า ε_{eff} ก็จะสามารถคำนวณหาค่าพารามิเตอร์อื่น ๆ ได้อย่างไรก็ตามค่า ε_{eff} จะเปลี่ยนแปลงไปตามความกว้างของແตนไมโครสตรีปเมื่อเปรียบเทียบกับความหนาของสับสเตรต (W/h) ซึ่งพิจารณาได้สองกรณีดังต่อไปนี้ กรณีแรกคือกรณีที่ $W/h >> 1$ ตามที่แสดงไว้ในรูปที่ 2.4 (ก) ในกรณีนี้เนื่องจากเส้นแรงไฟฟ้าส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณที่มีແตนไมโครสตรีป หรือ กล่าวได้ว่าพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะถูกส่งผ่านในบริเวณดังกล่าวเกือบทั้งหมด ซึ่งทำให้ค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ทางไฟฟ้าประสิทธิผลมีค่าเข้าใกล้ค่า ε_r ของสับสเตรต สำหรับกรณีที่สองคือกรณีที่ $W/h << 1$ ตามที่แสดงไว้ในรูปที่ 2.4 (ง) ในกรณีนี้เส้นแรงไฟฟ้าถูกส่งผ่านสับสเตรตและผ่านอากาศอย่างละครึ่ง ซึ่งทำให้ค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ทางไฟฟ้าประสิทธิผลมีค่าเข้าใกล้ $(\varepsilon_r + 1)/2$ จากที่ได้อธิบายมาแล้วเห็นได้ว่าค่า ε_{eff} จะเปลี่ยนแปลงตามค่า W/h และ กล่าวได้ว่า ε_{eff} มีข้อมูลและขอบล่างเป็นไปตามกรณีที่กล่าวข้างต้นดังนี้

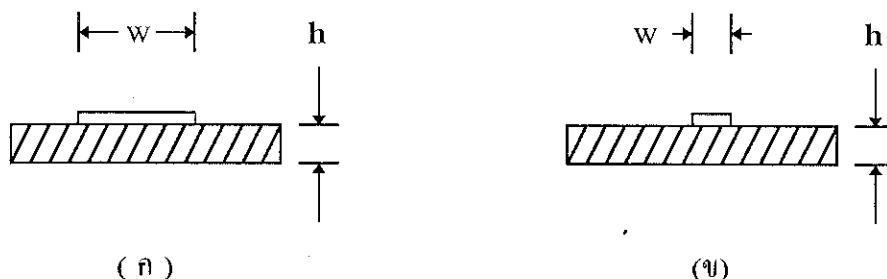
$$(\varepsilon_r + 1)/2 < \varepsilon_{\text{eff}} < \varepsilon_r \quad (2.11)$$

ในการหาค่า W/h นั้นโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่คำนึงถึงความหนาของແตนไมโครสตรีปเนื่องจากมีค่าน้อยมาก ($t/h \leq 0.005$) ดังนั้นในการหาค่า W/h นั้นสามารถหาได้โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณีดังนี้ [7]

กรณีที่ 1 เมื่อ $W/h \leq 2$

$$W/h = 8 e^A / (e^{2A} - 2) \quad (2.12)$$

$$\text{และ} \quad A = (Z_0/60) \sqrt{(\varepsilon_r + 1)/2} + [(\varepsilon_r - 1)/(\varepsilon_r + 1)] (0.23 + 0.11/\varepsilon_r)$$



รูปที่ 2.4 แสดงโครงสร้างของไมโครสตริปที่มีค่า W/h ต่างกัน

(a) $W/h >> 1$

(b) $W/h \ll 1$

กรณีที่ 2 เมื่อ $W/h \geq 2$

$$W/h = (2/\pi)(B - 1 - \ln(2B - 1) + [(\varepsilon_r - 1)/2\varepsilon_r] [\ln(B - 1) + 0.39 - 0.61/\varepsilon_r]) \quad (2.13)$$

และ $B = 592.2/(Z_0 \sqrt{\varepsilon_r})$

ส่วนในการคำนวณหาค่าสภาระยอมสมมัติว่าไฟฟ้าประสีทชิดผลนั้น โดยส่วนใหญ่แล้ว จะไม่พิจารณาถึงความหนาของแผ่นไมโครสตริป ($t/h < 0.005$) เช่นกัน และสามารถแบ่งออก เป็น 2 กรณีดังนี้

กรณีที่ 1 เมื่อ $W/h \leq 1$

$$\varepsilon_{\text{eff}} = (\varepsilon_r + 1)/2 + [(\varepsilon_r - 1)/2] [(1 + 12h/W)^{-1/2} + (1 - W/h)^2/25] \quad (2.14)$$

กรณีที่ 2 เมื่อ $W/h \geq 1$

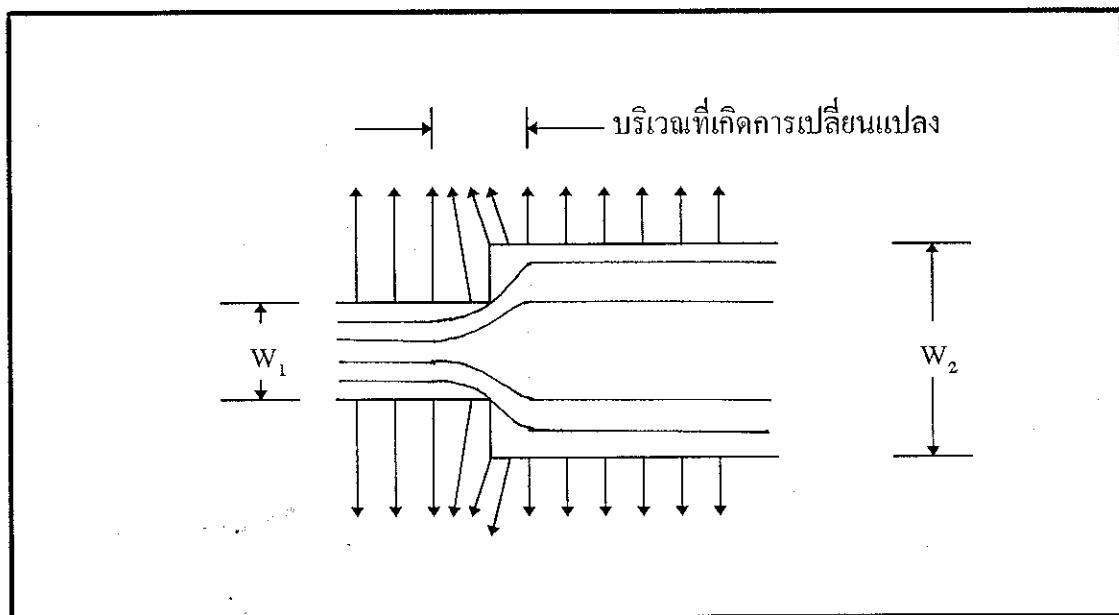
$$\varepsilon_{\text{eff}} = 0.5[(\varepsilon_r + 1) + (\varepsilon_r - 1)(1 + 12h/W)^{-1/2}] \quad (2.15)$$

ดังนั้นความยาวคลื่นในการแพร่กระจายเป็นดังนี้

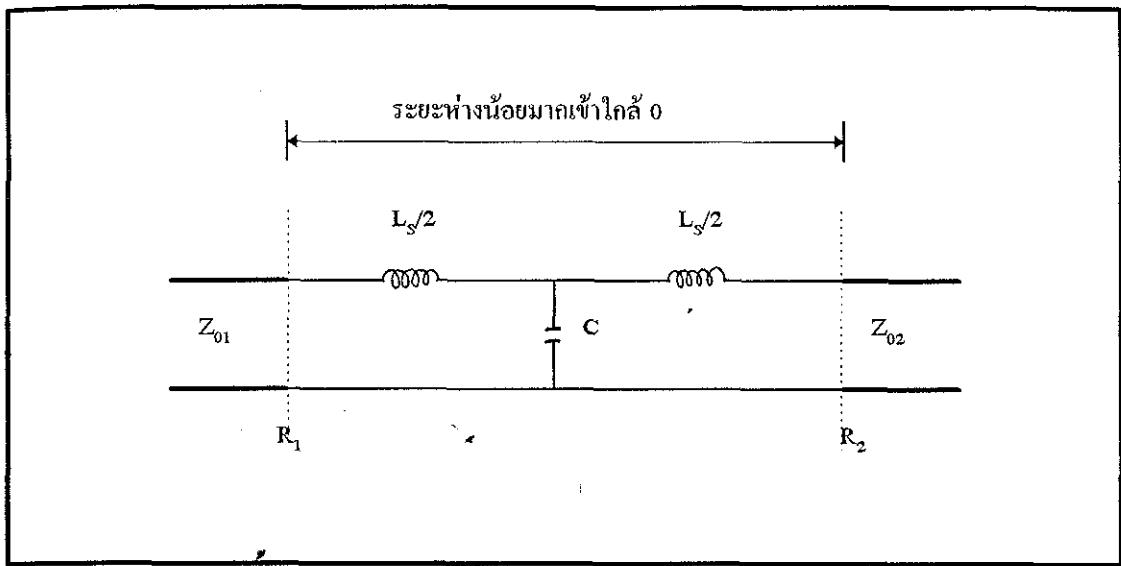
$$\lambda_s = c/f \sqrt{\varepsilon_{\text{eff}}} \quad (2.16)$$

เนื่องจากแทนในโครสติปแต่ละແນບมีค่าลักษณะสมบัติทางอิมพິແດນซ์เป็นตัวกำหนดความกว้าง ดังนั้นกรณีที่มีการต่อ กันของແນບในโครสติปที่มีค่าลักษณะสมบัติทางอิมพິແດນซ์ต่างกันบนสันสเตรตตัวเดียวกันจะเกิดบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงจากແນບในโครสติปที่มีความกว้างค่าหนึ่งไปยังແນບในโครสติปที่มีความกว้างอีกค่าหนึ่งทันทีทันใดดังรูปที่ 2.5 ซึ่งเรียกจุดต่อบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเช่นนี้ว่าสเตป (Step) ตัวอย่างอุปกรณ์ในโครสติปที่มักจะเกิดสเตปขึ้นได้แก่ การแมตช์ของโครงข่ายต่าง ๆ ในการออกแบบตัวกรองสัญญาณนั้นเอง

ในรูปที่ 2.5 แสดงถึงลักษณะการเกิดสเตปและในบริเวณใกล้ ๆ สเตปนั้นเป็นบริเวณที่ปลดออกพาราห์ และ เป็นบริเวณที่มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับความยาวคลื่นที่ใช้งาน เมื่อกระแสไฟหลักจากແນบความกว้างขนาดหนึ่งไปสู่ความกว้างอีกขนาดหนึ่งจะเกิดค่าอินดักเต้นซ์อนุกรมตรงบริเวณสเตป (L_s) ขึ้นและจากรูปที่ 2.5 จะเห็นได้ว่าสำนวนไฟฟ้าที่บริเวณสเตปจะเกิดความผิดเพี้ยนไปจากเดิม กล่าวคือรอบ ๆ บริเวณที่เกิดสเตปนั้นจะเกิดสนามฟริงกิ้ง (Fringing Electric Field) ขึ้น ซึ่งหมายความว่ามีประจุภานามาบที่สะสมอยู่ในบริเวณนี้จนทำให้เกิดค่าค่าปาราเซตันซ์ (C_s) ขึ้น ซึ่งสามารถเขียนวงจรสมมูลย์ทางไฟฟ้าของ การเกิดสเตปได้ดังที่แสดงไว้ในรูปที่ 2.6 ซึ่งมีส่วนประกอบของค่าอินดักเต้นซ์แยกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน เมื่อ Z_{01} คือสายที่มีค่าลักษณะสมบัติทางอิมพິແດນซ์ที่มีค่าสูง และ Z_{02} คือสายที่มีค่าลักษณะสมบัติทางอิมพິແດນซ์ที่มีค่าต่ำ



รูปที่ 2.5 ลักษณะของกระแสและสำนวนไฟฟ้าในบริเวณที่เกิดสเตป



รูปที่ 2.6 วงจรสมมูลของรูปลักษณะสเตปซึ่งมีส่วนประกอบของอิมพีเดนซ์แยกเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน

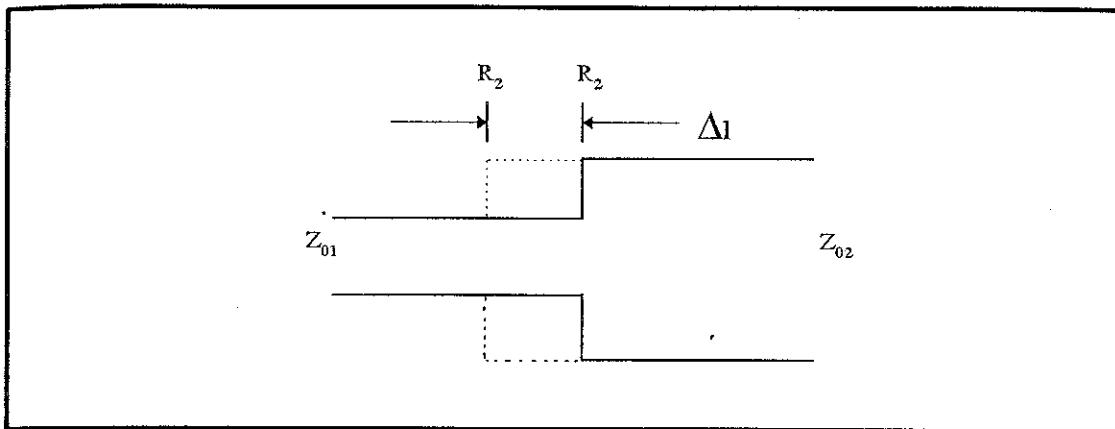
สำหรับการชดเชยฟริงกิ้งค่าปาร์ซิเคนซ์ (Fringing Capacitance) ต้องทำการชดเชยไกส์ ๆ กับจุดที่เกิดสเตป จากรูปที่ 2.7 ถ้าไม่โครงสร้างปีพกุติกรรมแบบอุดมคติแล้ว จากการคำนวณตามทฤษฎีบริเวณที่ควรเกิดสเตปคือตำแหน่งที่ระยะ R_2 และในความเป็นจริงแล้วเมื่อส่งผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าไปตามไม่โครงสร้างปีพกุติกรรมฟริงกิ้งค่าปาร์ซิเคนซ์ขึ้น ซึ่งต้องทำการชดเชยในสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ ฟริงกิ้งค่าปาร์ซิเคนซ์ที่เกิดขึ้นจากสเตปในกรณีที่แสดงไว้ในรูปที่ 2.7 นั้นจะสมมูลกับและไม่โครงสร้างที่มีความยาวเท่ากับ Δl ซึ่งเป็นระยะที่เกินมาจากการคำนวณในตอนต้น และเกินเข้าไปในด้านของถนนไม่โครงสร้างที่มีลักษณะสมบูติทางอิมพีเดนซ์ต่ำ หรือ ถนนที่กว้างกว่า ดังนั้นการชดเชยค่าฟริงกิ้งค่าปาร์ซิเคนซ์ที่เกิดขึ้นทำได้โดยการเลื่อนตำแหน่งที่เกิดสเตปจากระยะ R_2 ไปยังตำแหน่งระยะ R_1 ซึ่งได้แสดงไว้ในรูปที่ 2.7 เมื่อทำเช่นนี้แล้วที่ระยะ R_1 นั้นยังคงรักษาค่าลักษณะสมบูติทางอิมพีเดนซ์ที่ R_2 ไว้ได้ เช่นเดิม

Hammerstad และ Bekkadal ได้เสนอการคำนวณค่า Δl ไว้ดังสมการต่อไปนี้ [3]

$$\Delta l = (1 - W_1 / W_2) \Delta l_{oc} \quad ; \quad W_2 > W_1 \quad (2.17)$$

เมื่อ Δl_{oc} คือแฟล็กเตอร์ (factor) ที่แก้การเปิดวงจรที่ส่วนปลายของถนนสร้าง ซึ่งหาได้จากสมการต่อไปนี้ [3]

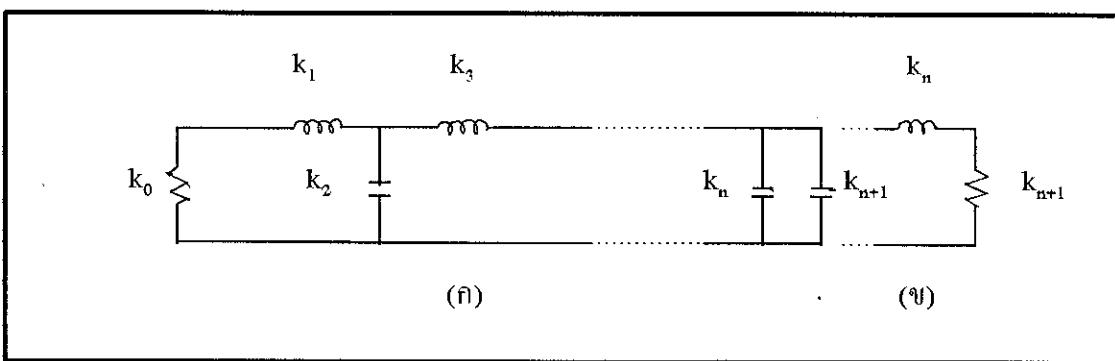
$$\Delta l / h = 0.412 [(\epsilon_{eff} + 0.3) / (\epsilon_{eff} - 0.258)] [(W/h + 0.262) / (W/h + 0.813)] \quad (2.18)$$



รูปที่ 2.7 แสดงถึงไมโครสตริปที่ทำการขัดขยายการเกิดฟริงกิ้งค่าปัจจัยแทนซ์เนื่องจากการเกิดสะเต�

2.4 ทฤษฎีพื้นฐานในการออกแบบตัวกรองสัญญาณผ่านແນບຄວາມຄືຕໍ່າ

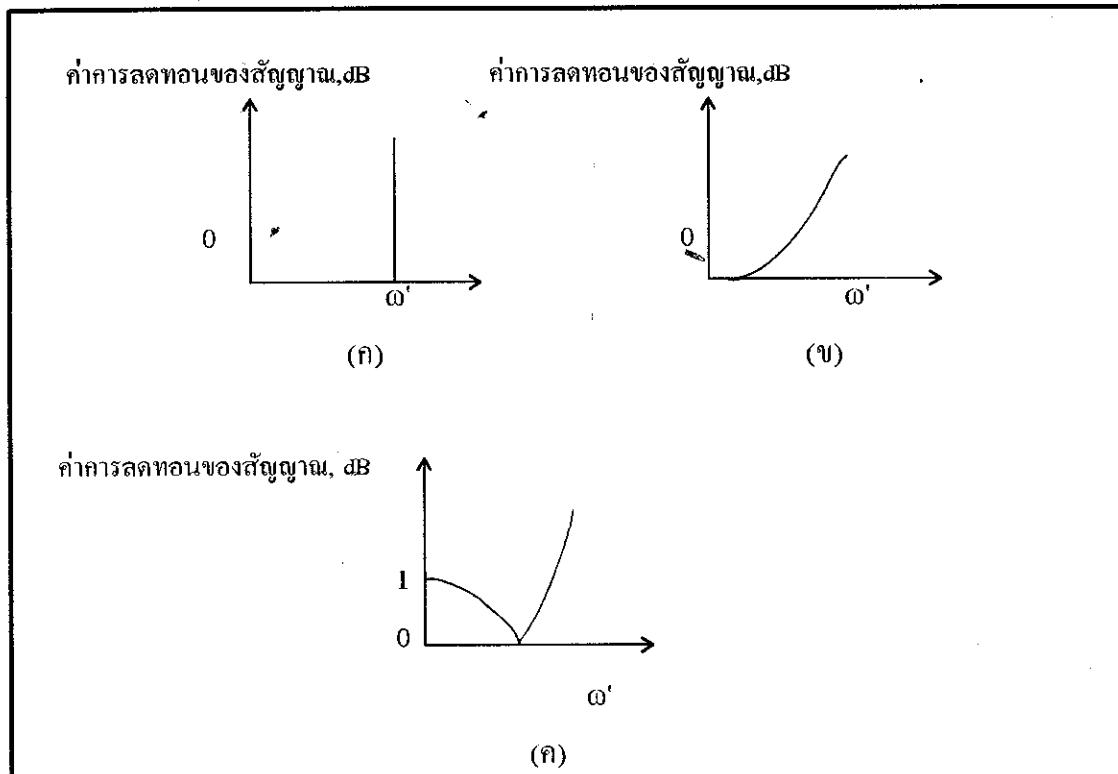
เมื่อพิจารณาในส่วนต้นแบบของตัวกรองสัญญาณผ่านແນບຄວາມຄືຕໍ່າในส่วนประกอบแบบล้มปี n - section ดังที่ได้แสดงไว้ในรูปที่ 2.8 ซึ่งมีค่า k ສลับกันระหว่างอินດักແຕນซ์ซึ่งต่ออนุกรมกับค่าปัจจัยแทนซ์ที่ต่อขนาดจาก 1 ถึง n ส่วนในเทอมของ k_0 และ k_{n+1} เมื่อพิจารณาในส่วนที่ต่อเรียงติดกันไปทั้งแบบอนุกรมและขนาดแล้วถ้า k_0 หรือ k_{n+1} อยู่ติดกับค่าปัจจัยแทนซ์แล้วค่าดังกล่าวจะเป็นเรซิสແຕນซ์ แต่ถ้า k_0 หรือ k_{n+1} อยู่ติดกับอินດักແຕນซ์ค่าดังกล่าวจะเป็นกอนດักແຕນซ์ ส่วนค่า k อื่น ๆ จะอยู่ในรูปของเซนรี หรือ ฟาร์ดแล้วแต่กรณีไป ส่วนผลตอบสนองทางความຄືของ การลดTHONของสัญญาณในตัวกรองสัญญาณผ่านແນບຄວາມຄືຕໍ່າ โดยทั่วไปนั้นค่าอิมິຕແຕນซ์ของแหล่งจ่ายและໂຫລດจะมีค่าเป็น 1 ซึ่งแสดงไว้ในรูปที่ 2.9



รูปที่ 2.8 ต้นแบบ n-section ของตัวกรองสัญญาณผ่านແນບຄວາມຄືຕໍ່າ ซึ่งมีอินດักເຕຣ້ k_1 เป็นส່ວນແຮກ

- (ก) กรณีที่ค่า n เป็นเลขคู่ ซึ่งมี k_{n+1} เป็นเรซิสແຕນซ์
- (ข) กรณีที่ค่า n เป็นเลขคี่ ซึ่งมี k_{n+1} เป็นกอนດักແຕນซ์

การลดทอนของสัญญาณที่ออกจากแคนบีโนโกรสติปีที่เกิดขึ้นระหว่างแหล่งจ่ายกับโหลดนั้นเกิดขึ้นจากการสะท้อนกลับของสัญญาณขาเข้ากลับมาซึ่งแหล่งจ่าย ตัวกรองสัญญาณผ่านແນບความถี่ที่มีอินดักแตนซ์เป็นรีแอคตีฟอันดับแรกนั้นแสดงว่ามีอินพีಡนซ์ขาเข้าสูงพืนไปจากແນບผ่าน ซึ่งถูกต้องนานกับสายหลักและในทางกลับกันถ้ามีค่าปานิชແຕนซ์เป็นรีแอคตีฟอันดับแรกแล้ว ตัวกรองสัญญาณจะมีอินพีಡนซ์ขาเข้าต่ำจนพื้นจากແນບผ่านແທนกรณีของวงจรที่มีอินดักแตนซ์เป็นรีแอคตีฟอันดับแรก



รูปที่ 2.9 แสดงผลตอบสนองทางความถี่ของตัวกรองสัญญาณผ่านແນບความถี่ต่อในรูปการลดทอน/ความถี่

- (ก) ลักษณะสมบัติของตัวกรองสัญญาณผ่านແນບความถี่ต่ำในอุดมคติ
- (ข) ผลตอบสนองของ Maximally-flat หรือ Butterworth ด้วย 2 section
- (ก) ผลตอบสนองของ 1.0 dB Equiripple หรือ Chebyshev ด้วย 2 section

สำหรับผลตอบสนองทางความถี่ของตัวกรองสัญญาณผ่านແນບความถี่ต่ำในอุดมคติ ซึ่งแสดงให้เห็นในรูปที่ 2.9 (ก) นั้นจะเห็นได้ว่าไม่มีการลดทอนของสัญญาณเลย ณ ที่ความถี่ใด ๆ ที่ต่ำกว่าความถี่ ω_1 แต่ที่ความถี่ที่สูงขึ้นไปจากความถี่ดังกล่าวจะมีค่าการลดทอนของสัญญาณเป็นอนันต์ ส่วนผลตอบสนองทางความถี่ของตัวกรองสัญญาณผ่านແນບความถี่ต่ำที่ออกแบบโดยใช้วิธี

ของ Maximally-flat หรือ Butterworth นั้นได้แสดงให้เห็นในรูปที่ 2.9 (b) จะเห็นได้ว่าค่าการลดทอนของสัญญาณมีค่าเท่ากับ 3 dB ที่ความถี่ ω_1' เท่านั้น และ สำหรับผลตอบสนองทางความถี่ของการออกแบบโดยใช้ Equi-ripple ซึ่งแสดงให้เห็นในรูปที่ 2.9 (c) จะเห็นได้ว่าไม่เกิดการลดทอนของสัญญาณ ณ ที่ความถี่เดียวก็อที่ความถี่ ω_1' เท่านั้น

คุณสมบัติการส่งผ่านของคลื่นในตัวกรองสัญญาณนี้สามารถอธิบายได้ด้วยค่า P_{out} / P_{av} เมื่อ P_{out} คือค่ากำลังข้ออกรของตัวกรองสัญญาณไปสู่โหลด และ P_{av} คือค่ากำลังที่นำมาใช้ซึ่งได้จากแหล่งจ่าย P_{out} / P_{av} คือรูปแบบที่รู้จักในความหมายของค่ากำลังขยายของทรานซิเซอร์ (G_t Transducer Power Gain) ของอุปกรณ์ 2 พร้อม ซึ่ง G_t เป็นฟังก์ชันของอัมพ์เดนซ์แหล่งจ่าย Z_s และอัมพ์เดนซ์ของโหลดแทนด้วย Z_L โดยทั่วไปในทางปฏิบัติจะทำให้ $Z_s = Z_L = Z_0$ และสำหรับตัวกรองสัญญาณด้านบนนี้ $Z_0 = 1$ ในการกล่าวถึงค่าการลดทอนของสัญญาณ หรือ การสูญเสียในการส่งสัญญาณนี้จะนิยามด้วยค่า $10\log(P_{av} / P_{out})$

2.4.1 ผลตอบสนองตามวิธีการของ Maximally-flat

ในโครงงานนี้ได้ทำการอกรูปแบบตัวกรองสัญญาณผ่านແຕບความถี่ต่ำโดยใช้วิธีการของ Maximally-flat ซึ่งกำลังงานข้ออกรของตัวกรองสัญญาณผ่านແຕບความถี่ต่ำ n-section ตามวิธีของ Maximally-flat นี้จะให้ผลตอบสนองทางความถี่โดยกำลังงานข้ออกรจะมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของกำลังงานทางด้านขาเข้าที่ $\omega' = \omega_1'$ เมื่อ ω_1' คือความถี่ที่ค่าการลดทอนของสัญญาณมีค่าเท่ากับ 3 dB ซึ่งค่าการลดทอนของสัญญาณของตัวกรองสัญญาณสามารถหาได้จากสมการต่อไปนี้

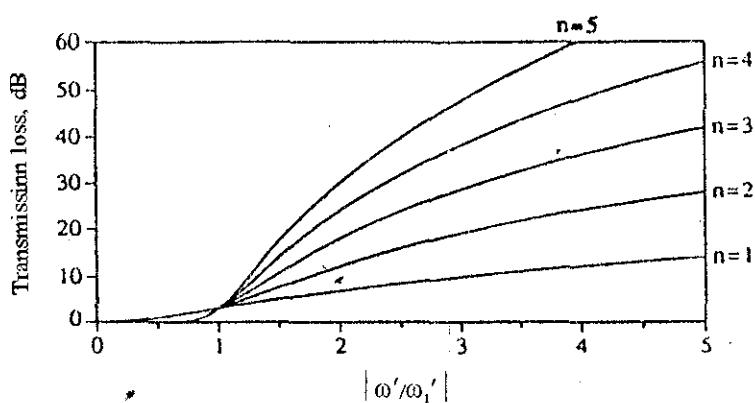
$$L = 10 \log_{10} [1 + (\omega' / \omega_1')^{2n}] \quad \text{dB} \quad (2.19)$$

ค่าที่หาได้จากสมการ (2.19) สามารถนำไปเป็นกราฟเพื่อแสดงถึงผลตอบสนองทางความถี่ของตัวกรองสัญญาณผ่านແຕບความถี่ต่ำโดยวิธีของ Butterworth หรือ Maximally-flat ดังที่ได้แสดงไว้ในรูปที่ 2.10

ในการหาค่า k_k ที่ต้องการเพื่อนำไปใช้ในการอกรูปแบบตัวกรองสัญญาณผ่านແຕບความถี่ต่ำแบบ Butterworth นี้สามารถคำนวณได้จากสมการดังต่อไปนี้ โดยให้ $k_0 = k_{n+1} = 1$

$$k_k = 2 \sin [\pi (2k-1) / 2n] \quad k = 1, \dots, n \quad (2.20)$$

จากสมการ (2.20) เมื่อแทนค่า $n = 0, 1, \dots, 6$ จะได้ค่าของชิ้นส่วนด้านบนตามวิธีการของ Butterworth ของตัวกรองสัญญาณผ่านແຕບความถี่ดังตารางที่ 2.1

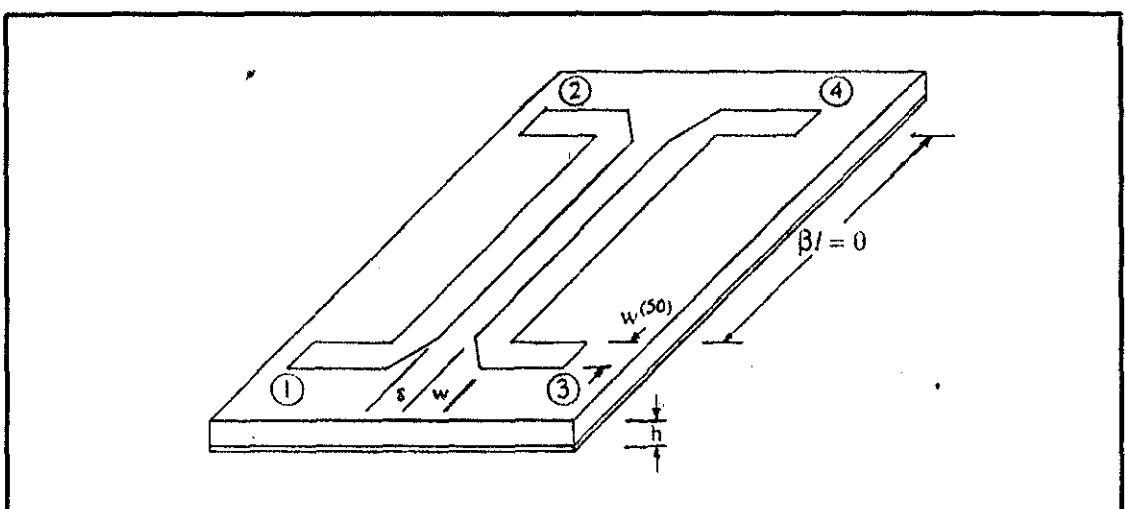


รูปที่ 2.10 ผลตอบสนองของตัวกรองสัญญาณผ่านเกบความถี่สำหรับวิธีการของ Butterworth

ตารางที่ 2.1 ค่าของชิ้นส่วนต้นแบบตามวิธีการของ Butterworth ของตัวกรองสัญญาณผ่าน
ແບນความถี่ต่ำ

2.5 ทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในการออกแบบตัวคัปเปลอร์แบบมีทิศทาง

ตัวคัปเปลอร์แบบมีทิศทางซึ่งแสดงไว้ในรูปที่ 2.11 ประกอบไปด้วยແตนไมโครสตริป ส่องແตนที่วางขนานกัน ซึ่งสัญญาณจะเกิดการคัปปิงที่บริเวณดังกล่าว โดยที่ระยะห่างระหว่าง ແຕນไมโครสตริปที่เกิดการเชื่อมต่อให้ແທນด้วย S และความกว้างของແຕນไมโครสตริปที่เกิด การคัปปิงนี้ให้ແທນด้วย W ซึ่งความกว้างของແຕນไมโครสตริปช่วงที่เกิดการคัปปิงต่อนี้ มากกว่ากับความกว้างของปลายตัวคัปเปลอร์ที่จำเป็นต้องให้ແຕນไมโครสตริปที่มีค่าลักษณะสมบัติทางอินพีಡenซ์มีค่าเท่ากับ 50Ω โดยใช้สัญลักษณ์ແທນด้วย $W^{(50)}$ การวิเคราะห์การคัปปิงของ สัญญาณในตัวคัปเปลอร์แบบมีทิศทางนี้จำเป็นต้องวิเคราะห์ในเหตุของโหนดคู่ และ โหนดคี่ ซึ่ง จะกล่าวโดยละเอียดในหัวข้อต่อไป



รูปที่ 2.11 แสดงແຕນไมโครสตริปที่เกิดการคัปปิงในตัวคัปเปลอร์แบบมีทิศทาง

จากรูปที่ 2.11 โดยปกติทั่วไปแล้วเป็นที่เข้าใจกันว่า พอร์ตที่ 1. คือพอร์ตทำการป้อน กำลังงานเข้า (Input Port) พอร์ตที่ 2 คือพอร์ตไดเรก (Direct Port) พอร์ตที่ 3 คือพอร์ตที่เกิด คัปปิงของสัญญาณ (Coupled Port) และ พอร์ตที่ 4 คือพอร์ตที่ไม่มีการนำเอาสัญญาณไปใช้งาน ใดๆ (Isolate Port) สำหรับการวิเคราะห์ตามทฤษฎีพื้นฐานของการเชื่อมต่อนี้จำเป็นต้องดึงอยู่ บนสมมุติฐาน 3 ข้อคือ

1. การแพร่กระจายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะถือว่าเป็นโหนดกึ่ง TEM สถิตย์
2. ในทางทฤษฎีแล้วสายนำสัญญาณดังกล่าวจะมีค่า ϵ_{eff} และ ความเร็วเฟสที่เพิ่มขึ้น กันทึ้งในโหนดคู่และโหนดคี่ แต่ในทางปฏิบัติแล้วความเร็วเฟสในทึ้ง 2 นี้จะมีค่าต่างกันเล็กน้อย ดังนั้นในการสร้างตัวคัปเปลอร์นี้จะได้ผลผลิตที่มีความคลาดเคลื่อนอยู่ด้วย
3. สายส่งจะต้องมีระนาบสมมาตรที่เหมาะสม

2.5.1 การวิเคราะห์ในโหนมคู่ และ โหนมคี่

เมื่อมีเดนไมโครสตริปวงวนกันสองແນນ ทำให้เกิดอุปกรณ์ 4 พอร์ตขึ้น ดังที่กล่าวไปแล้วในข้างต้นนี้ เมื่อป้อนสัญญาณเข้าที่พอร์ตที่ 1 สัญญาณที่แพร่กระจายไปตามตัวคัปเปลอร์นี้จะมีการแพร่กระจายในโหนมคู่ และ คี่สลับกันไป ผลกระทบของแรงดันที่เกิดขึ้นที่พอร์ต 2,3 และ 4 ได้แสดงไว้ในรูปที่ 2.12 (ก) ถ้าที่พอร์ตสองพอร์ตที่ปลายของอุปกรณ์ 4 พอร์ตนี้มีแรงดันที่มีเฟสเดียวกัน และ มีขนาดเท่ากัน นั้นแสดงว่าอุปกรณ์ 4 พอร์ตนี้ทำงานอยู่ในโหนมคู่ ซึ่งได้แสดงไว้ในรูปที่ 2.12 (ข) และ ในทางกลับกันถ้าที่พอร์ตสองพอร์ตที่ปลายของอุปกรณ์ 4 พอร์ตนี้มีแรงดันที่กลับเฟสกัน นั้นแสดงว่าอุปกรณ์ 4 พอร์ตนี้ทำงานอยู่ในโหนมคี่ ซึ่งแสดงไว้ในรูปที่ 2.12 (ค) ค่าแรงดัน และ กระแสในแต่ละพอร์ตเมื่อทำงานอยู่ในโหนมคู่จะใช้สัญลักษณ์ที่เขียนห้อยไว้ข้างบนดังนี้ “(e)” และ เมื่อค่าแรงดัน และ กระแสในแต่ละพอร์ตทำงานอยู่ในโหนมคี่ จะใช้สัญลักษณ์ที่เขียนห้อยไว้ข้างบนดังนี้“(o)” ผลกระทบของแรงดันในแต่ละพอร์ตเมื่อพิจารณาแบบบูร์โพชิชัน (Superposition) ของโหนมคู่ และ โหนมคี่ จะเป็นดังต่อไปนี้

$$V_1 = V_i^{(e)} + V_i^{(o)}$$

$$V_3 = V_i^{(e)} - V_i^{(o)}$$

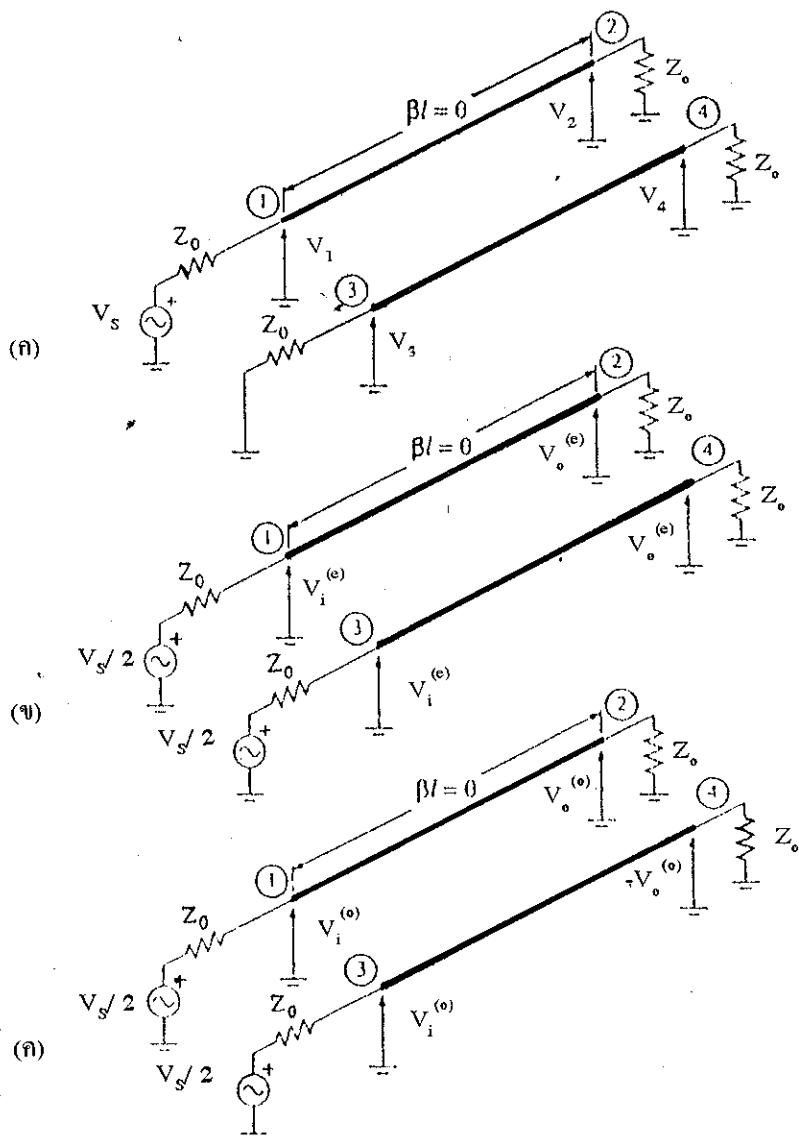
$$V_2 = V_o^{(e)} + V_o^{(o)}$$

$$V_4 = V_o^{(e)} - V_o^{(o)}$$

รูปแบบของสถานไฟฟ้าตามขวางที่แพร่กระจายไปในตัวคัปเปลอร์แบบมีทิศทางในกรณีที่ทำงานในโหนมคู่ และ โหนมคี่แสดงไว้ในรูปที่ 2.13

ค่าอินดักเต้นซึ่งองตัวคัปเปลอร์นี้สามารถหาได้เช่นเดียวกับกรณีของແນນไมโครสตริปเดี่ยวกับคือ สามารถคำนวณได้จากค่าอินดักเต้นซึ่งต่อหน่วยความยาวในแต่ละโหนม และ ค่าอิมพีเดนซ์ในโหนมคู่ และ โหนมคี่ແแทนด้วย Z_a และ Z_o ซึ่งหาได้จากค่าคากาป้าແแทนซ์ในແນນไมโครสตริปที่มีระนาบอยู่ในอากาศและสารไคลेकต्रิก ค่าอิมพีเดนซ์ในแต่ละโหนมนี้แสดงในรูปของอัตราส่วนแรงดันต่อกระแสของสัญญาณที่แพร่กระจายไปตามແນນไมโครสตริปในแต่ละແຕນ เมื่อແນນไมโครสตริปที่เกิดการเชื่อมนั้นต่อถูกกระตุ้นอย่างเหมาะสม

ในการวิเคราะห์แรงดันของตัวคัปเปลอร์แบบมีทิศทางนี้สามารถวิเคราะห์ได้เช่นเดียวกับการวิเคราะห์แรงดันในสายส่งสัญญาณทั่วๆไป เมื่อพิจารณาสายส่งสัญญาณซึ่งมีค่าลักษณะสมบัติทางอิมพีเดนซ์ Z_0 ตามที่ได้แสดงไว้ในรูปที่ 2.14 ให้สัมประสิทธิ์การสะท้อนของแรงดันที่โหลด และ แหล่งจ่ายที่ปลายของสายส่งสัญญาณ (Voltage Reflection Coefficients) ແแทนด้วย Γ_L และ Γ_s ตามลำดับ แรงดันที่ปลายของสายส่งสัญญาณเป็นดังต่อไปนี้



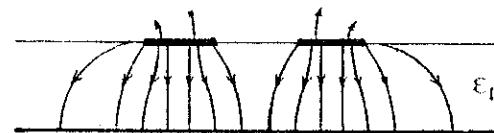
รูปที่ 2.12 พารามิเตอร์สำหรับແນບໄມໂຄຣສຕຣີປໍທີເກີດກາຮ່ອມຕ່ອ

ก) ພລຽມແຮງດັນທີ່ໜ້າໝໍເພວົດ 1 ຖຸກກະຊຸ່ນໂດຍ

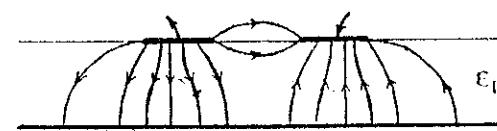
ຂ) ສ້າງສູງອິນພູດ ແຮງດັນໃນ ກ) ຈະຈໍາແນກອອກເປັນ 2 ຊຸດກື່ອ

ງ) ແຮງດັນໃນໂພນຄູ່

ຄ) ແຮງດັນໃນໂພນຄື່

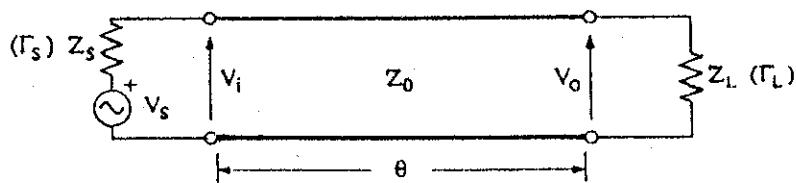


โหนดคู่



โหนดคี่

รูปที่ 2.13 สนามไฟฟ้าที่แพร่กระจายไปตามไมโครสตริปที่เกิดการเชื่อมต่อ กันของสัญญาณใน
โหนดคู่ และ โหนดคี่



รูปที่ 2.14 พารามิเตอร์ที่ขึ้นของสายส่งสัญญาณที่มีค่าลักษณะสมบัติทางอิมพีเดนซ์ Z_0

$$V_i = (V_s/2) \times [1 - (\Gamma_s - \Gamma_L e^{j2\theta}) / (1 - \Gamma_s \Gamma_L e^{j2\theta})] \quad (2.21)$$

$$V_o = (V_s/2) \times [(1 - \Gamma_s) \times (1 + \Gamma_L) e^{-j\theta} / (1 - \Gamma_s \Gamma_L e^{j2\theta})] \quad (2.22)$$

เมื่อ $\Gamma_s = \Gamma_L = \Gamma$ ดังนั้นสมการข้างต้น เทียนได้ใหม่ได้ดังนี้

$$V_i = (V_s/2)x[1 - \Gamma x(1 - e^{-j2\theta}) / (1 - \Gamma^2 e^{-j2\theta})] \quad (2.23)$$

$$\text{และ} \quad V_o = (V_s/2)x[(1 - \Gamma^2)e^{-j2\theta} / (1 - \Gamma^2 e^{-j2\theta})] \quad (2.24)$$

แรงดันของสายส่งสัญญาณจากสมการนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับแคนไมโครสตริปที่เกิดการคัปปิงในเทอมของโหนมคู่และโหนมคี่ในตัวคัปป์โลร์แบบมีทิศทางได้ สำหรับโหนมคู่ในรูปที่ 2.12 (ช) นี้ เมื่อให้ค่าอิมพีเดนซ์ของโหลดและแหล่งจ่าย แทนด้วย Z_0 และลักษณะสมบัติทางอินพีเดนซ์แทนด้วย Z_{0e} ดังนี้จะได้

$$\Gamma \rightarrow \Gamma_e = (Z_0 - Z_{0e}) / (Z_0 + Z_{0e}) \quad (2.25)$$

เมื่อค่า V_s ในรูปที่ 2.14 มีค่าเป็น $V_s/2$ ดังนั้นค่าแรงดันขาเข้า และ แรงดันขาออกในรูปที่ 2.11 (ช) จะเป็นดังต่อไปนี้

$$V_i^{(e)} = (V_s/4)x[1 - \Gamma_e x(1 - e^{-j2\theta}) / (1 - \Gamma_e^2 e^{-j2\theta})] \quad (2.26)$$

$$\text{และ} \quad V_o^{(e)} = (V_s/4)x[(1 - \Gamma_e^2)e^{-j2\theta} / (1 - \Gamma_e^2 e^{-j2\theta})] \quad (2.27)$$

ในทำนองเดียวกันค่าแรงดันขาเข้า และ แรงดันขาออกในรูปที่ 2.12 (ค) เป็นดังต่อไปนี้

$$\Gamma \rightarrow \Gamma_o = (Z_0 - Z_{0o}) / (Z_0 + Z_{0o}) \quad (2.28)$$

จะได้

$$V_i^{(o)} = (V_s/4)x[1 - \Gamma_o x(1 - e^{-j2\theta}) / (1 - \Gamma_o^2 e^{-j2\theta})] \quad (2.29)$$

$$V_o^{(o)} = (V_s/4)x[(1 - \Gamma_o^2)e^{-j2\theta} / (1 - \Gamma_o^2 e^{-j2\theta})] \quad (2.30)$$

เมื่อ θ ในสมการที่ (2.29) และ (2.30) คือตัวเดียวกันกับ θ ในสมการที่ (2.26) และ (2.27) โดยตั้งอยู่ในสมมติฐานที่ว่าความเร็วเฟสในโหนมคี่ และ โหนมคู่นั้นมีค่าเท่ากัน ในขั้นต่อไปจะทำการพิจารณาในส่วนของแต่ละพอร์ต

2.5.2 ສភາວະຂອງການແມ່ນຕີທີ່ຂາເຂົ້າທີ່ພອຣັດທີ່ 1

ໃຫ້ສັງຄູານາເຂົ້າປິ່ອນເຂົ້າທີ່ພອຣັດທີ່ 1 ເທົ່ານັ້ນ ຜຶ່ງຜລຮວມຂອງແຮງດັນນາເຂົ້າເປັ້ນດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

$$V_1 = V_i^{(c)} + V_i^{(o)} \text{ ດັ່ງນີ້}$$

$$V_i = (V_s/4) \times \{1+1-(1-e^{-j2\theta}) \times [\Gamma_e/(1-\Gamma_e^2 e^{-j2\theta}) + \Gamma_o/(1-\Gamma_o^2 e^{-j2\theta})]\} \quad (2.31)$$

ສភາວະສຳຫວັນການແມ່ນຕີທີ່ພອຣັດທີ່ 1 ໃນຮູບທີ່ 2.12 (ກ) ນັ້ນ ເມື່ອກຳທັນດໄໝ $V_1 = V_s / 2$ ຜຶ່ງຈະໄດ້ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

$$\Gamma_e/(1-\Gamma_e^2 e^{-j2\theta}) + \Gamma_o/(1-\Gamma_o^2 e^{-j2\theta}) = 0 \quad (2.32)$$

ຈາກສົມກາຣ (2.25) ແລະ (2.28) ຈະໄດ້ວ່າ

$$\Gamma_e = -\Gamma_o \rightarrow Z_0/Z_{0e} = Z_{0o}/Z_0$$

$$\text{ນີ້ນີ້ເວັບ} \quad Z_{0e} Z_{0o} = Z_0^2 \quad (2.33)$$

2.5.3 ສភາວະຂອງພອຣັດທີ່ 4 (Isolate Port)

ຜລຮວມຂອງແຮງດັນນາອອກທີ່ພອຣັດ 4 ຄື່ອ $V_o^{(e)} - V_o^{(o)}$ ເປັ້ນດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

$$V_4 = (V_s/4) \times \{[(1-\Gamma_e^2)e^{-j\theta}/(1-\Gamma_e^2 e^{-j2\theta})] - [(1-\Gamma_o^2)e^{-j\theta}/(1-\Gamma_o^2 e^{-j2\theta})]\} \quad (2.34)$$

ແລະເມື່ອກຳທັນດໄໝ $\Gamma_e = -\Gamma_o$ ແລ້ວຈະທຳໃຫ້ຄໍາ V_4 ໃນສົມກາຣ (2.34) ມີຄໍາທ່າກັນ 0

2.5.4 ສភາວະຂອງພອຣັດທີ່ 3 (Coupled Port)

ພອຣັດທີ່ 3 ຄື່ອ ພອຣັດທີ່ກາຣກັບປຶງຂອງສັງຄູານໃນຕັກປຶງເປົ້າໂລຣົນ ຜຶ່ງສາມາດເພີຍຜລຮວມຂອງແຮງດັນທີ່ພອຣັດທີ່ 3 ນີ້ໄດ້ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

$$V_3 = (V_s/4) \times \{1 - [\Gamma_e \times (1 - e^{-j2\theta}) / (1 - \Gamma_e^2 e^{-j2\theta})] - 1 + [\Gamma_o \times (1 - e^{-j2\theta}) / (1 - \Gamma_o^2 e^{-j2\theta})]\} \quad (2.35)$$

$$\text{ເມື່ອ} \quad V_3 = -(V_s/2) \times \{\Gamma_e \times (e^{j\theta} - e^{-j\theta}) / (e^{j\theta} - \Gamma_e^2 e^{-j\theta})\} \quad (2.36)$$

$$\text{จะได้ } V_3 = -(V_s/2)x(-2j\Gamma_e \sin\theta / [(1-\Gamma_e^2)\cos\theta + j\sin\theta(1+\Gamma_e^2)]) \quad (2.37)$$

$$= -(V_s/2)x[2\Gamma_e/(1+\Gamma_e^2)]xj\sin\theta / \{[(1-\Gamma_e^2)/(1+\Gamma_e^2)]\}\cos\theta + j\sin\theta$$

ดังนั้นจากสมการ (2.25) และ (2.33) สามารถเขียนได้ดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned} \text{โดยการนิยาม } -2\Gamma_e/(1+\Gamma_e^2) &= (Z_{0e} - Z_{0o}) / (Z_{0e} + Z_{0o}) \\ &= c \end{aligned} \quad (2.38)$$

เมื่อ c คือสัมประสิทธิ์ของการคัปปลิง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนของแรงดันดังต่อไปนี้

$$1 - c^2 = \{(1 - \Gamma_e^2) / (1 + \Gamma_e^2)\}^2 \quad (2.39)$$

$$\text{ดังนั้น } V_3 = (V_s/2)x(j\sin\theta / (1 - c^2 \cos\theta + j\sin\theta)) \quad (2.40)$$

2.5.5 สถานะของพอร์ตที่ 2 (Direct Port)

ในการพิจารณาถึงสถานะของพอร์ตที่ 2 นี้ยังคงวิเคราะห์ในสถานะเดิมกล่าวคือ กำหนดให้ $\Gamma_e = -\Gamma_o$ ดังนั้นผลรวมของแรงดันที่พอร์ตที่ 2 เป็นดังต่อไปนี้

$$V_2 = (V_s/2)x\{1 - c^2 / (-1 - c^2 \cos\theta + j\sin\theta)\} \quad (2.41)$$

โดยทั่วไปแล้วค่าของ การคัปปลิง (Coupling) แบบมีทิศทางจะแสดงในรูปของ dB เป็นดังนี้

$$\text{coupling , } C(\text{dB}) = -20 \log_{10}(c) \quad (2.42)$$

ดังนั้นจะได้ว่า

$$Z_{0e} = Z_0 \left\{ (1+c)/(1-c) \right\}^{1/2} = Z_0 \left\{ (1+10^{-C/20}) / (1-10^{-C/20}) \right\} \quad (2.43)$$

$$\text{และ } Z_{0o} = Z_0^2 / Z_{0e} = Z_0 \left\{ (1-10^{-C/20}) / (1+10^{-C/20}) \right\} \quad (2.44)$$

2.5.6 พารามิเตอร์ของແນບໄມໂຄຣສຕຣີປໍທ່ວາງໝານກັນແລະເກີດກາຮ່ອມຕ່ອຂອງສັນຍານເພື່ອ ພາຣາມີເຕົອຮ່ອງແນບໄມໂຄຣສຕຣີປໍທ່ວາງໝານກັນແລະເກີດກາຮ່ອມຕ່ອຂອງສັນຍານເພື່ອ ມີຄ່າພາຣາມີເຕົອຮ່ອງທີ່ສໍາຄັງດັ່ງຕ່ອໄປນີ້ ຄ່າຄວາມກ້ວາງຂອງແນບສຕຣີປໍທີ່ເກີດກາຮ່ອມຕ່ອຂອງສັນຍານຕ່ອງຄວາມໜານຂອງສັນສຕຣີ (w/h) ຄ່າຮະຍະຫ່າງຮ່ວາງແນບທ່ວາງໝານກັນທີ່ທຳໃຫ້ເກີດກາຮ່ອມຕ່ອຂອງສັນຍານ(s/h) ແລະ ສປາພຍອມສັນພັກທີ່ໄຟຟ້າປະສິທິພລຂອງໄດ້ເລັກຕົກ ສ່ວນຄ່າອິນີັດນີ້ຈະເສັນອີນຮູບປົງຂອງຄ່າອິນີັດນີ້ໃນໄອມຄູ່ Z_{∞} ແລະ ໄອມຄູ່ Z_0 ແລະ ຄ່າສປາພຍອມສັນພັກທີ່ໄຟຟ້າປະສິທິພລ (Effective Relative Permittivity) ຕ້ອງວິເກຣະໜີໃແຕ່ລະໄອມດ່ຽວກັນ ຜຶ່ງມີຄວາມສັນພັກທີ່ກັບຄວາມເຮົວເຟສດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

$$V_{\text{phase}}^{(e, o)} = c / \epsilon_{\text{eff}}^{(e, o)} \quad (2.45)$$

ຈາກກາຮັດການສັງເກດຫລັກກາຮອງ Kirschning ແລະ Jansen [4],[5] ຈະເຫັນວ່າ Z_{∞}, Z_0 ແລະ $\epsilon_{\text{eff}}^{(e, o)}$ ເປັນພິງກໍ່ຂັ້ນຂອງຄ່າ w/h , s/h ແລະ ຄວາມດີ (f) ດ້ວຍ ສູງໃນກາຮັດການສັງເກດຂອງ Kirschning ແລະ Jansen ຈະໃຊ້ສັນຍັກນີ້ w ແນຄວາມກ້ວາງຂອງແນບໄມໂຄຣສຕຣີປໍທ່ວາງໝານກັນແລະເກີດກາຮ່ອມຕ່ອຂອງສັນຍານ ແລະ ໃຊ້ສັນຍັກນີ້ s ແນຮະຍະຫ່າງຮ່ວາງແນບໄມໂຄຣສຕຣີປໍທ່ວາງໝານກັນແລະເກີດກາຮ່ອມຕ່ອຂອງສັນຍານ ແລະສູງຕ່າງໆ ໃນກາຮັດການສັງເກດຫລັກກາຮອງຕ່າງໆ ເຫັນ $\epsilon_{\text{eff}}^{(e)}$ ແລະ $\epsilon_{\text{eff}}^{(o)}$ ເປັນດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

$$u = w/h, \quad g = s/h$$

$$\text{ແລະ } 0.1 \leq u \leq 10.0 \quad 0.1 \leq g \leq 10.0 \quad 1.0 \leq \epsilon_r \leq 18.0$$

ຈຶ່ງຈາກເກີດການພິດພາດໄດ້ $< 0.7\%$ ສໍາຫວັນຄ່າ $\epsilon_{\text{eff}}^{(e)}$, $< 0.5\%$ ສໍາຫວັນຄ່າ $\epsilon_{\text{eff}}^{(o)}$, $< 0.6\%$ ສໍາຫວັນຄ່າ Z_{∞} ແລະ Z_0

ໃນກາຮັດການສັງເກດຫລັກກາຮອງສປາພຍອມສັນພັກທີ່ໄຟຟ້າປະສິທິພລໃນໄອມຄູ່ສາມາດກຳນວນໄດ້ຕາມສູງຕ່າງໆ

$$\epsilon_{\text{eff}}^{(e)} = (\epsilon_r + 1)/2 + (\epsilon_r - 1) \times \left\{ [1 + (10/v)]^{-a(v) \times b(\epsilon_r)} \right\} / 2 \quad (2.46)$$

ซึ่ง $v = u \times (20+g^2)/(10+g^2) + g \times \exp(-g)$

 $a_e(v) = 1+(1/49) \times \ln\{(v^4+(v/52)^2)/(v^4+0.432)\} + (1/18.7) \times \ln\{1+(v/18.1)^3\}$
 $b_e(\epsilon_r) = 0.564 \times \{(\epsilon_r - 0.9)/(\epsilon_r + 3.0)\}^{0.053}$

และการคำนวนหาค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ทางไฟฟ้าประสิทธิผลในโหนดคี่สามารถคำนวนได้ตามสูตรต่อไปนี้

$\epsilon_{eff}^{(o)} = \epsilon_{eff} + \{(\epsilon_r + 1)/2 + a_o(u, \epsilon_r) - \epsilon_{eff}\} \times \exp(-c_o \times g^d) \quad (2.47)$

ซึ่ง $a_o(u, \epsilon_r) = 0.7287 \times \{\epsilon_{eff} - (\epsilon_r + 1)/2\} \times (1 - \exp(-0.179u))$

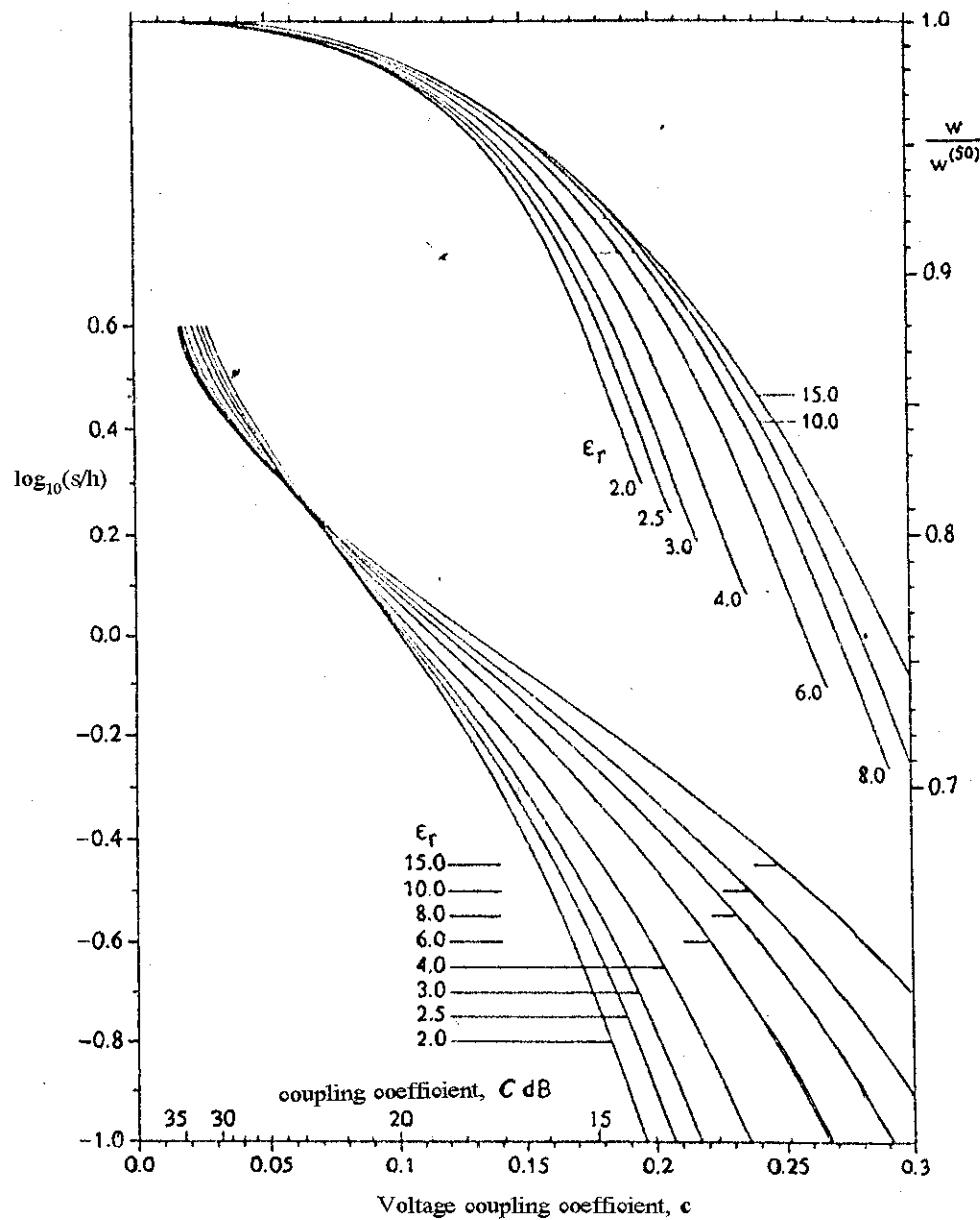
 $b_o(\epsilon_r) = 0.747 \times \epsilon_r / (0.15 + \epsilon_r)$
 $c_o = b_o(\epsilon_r) - (b_o(\epsilon_r) - 0.207) \times \exp(-0.414u)$
 $d_o = 0.593 + 0.694 \times \exp(-0.562u)$

สำหรับการแมตช์ระหว่างตัวคัปเปลอร์แบบมีทิศทางกับสายนำสัญญาณจากแหล่งจ่ายและโหนดโดยทั่วไปแล้วจะถูกออกแบบมาเพื่อต่อ กับลักษณะสมบัติทางอิมพีเดนซ์เท่ากับ 50Ω ซึ่งเป็นการรวมของค่า Z_{oe} และ Z_{oo} และสภาวะนี้ทำได้จากการ (2.33) ความกว้างของແຄນไมโครสตริปซึ่งແປรັດຕາມกับค่าสัมประสิทธิ์ของการคัปเปลิง

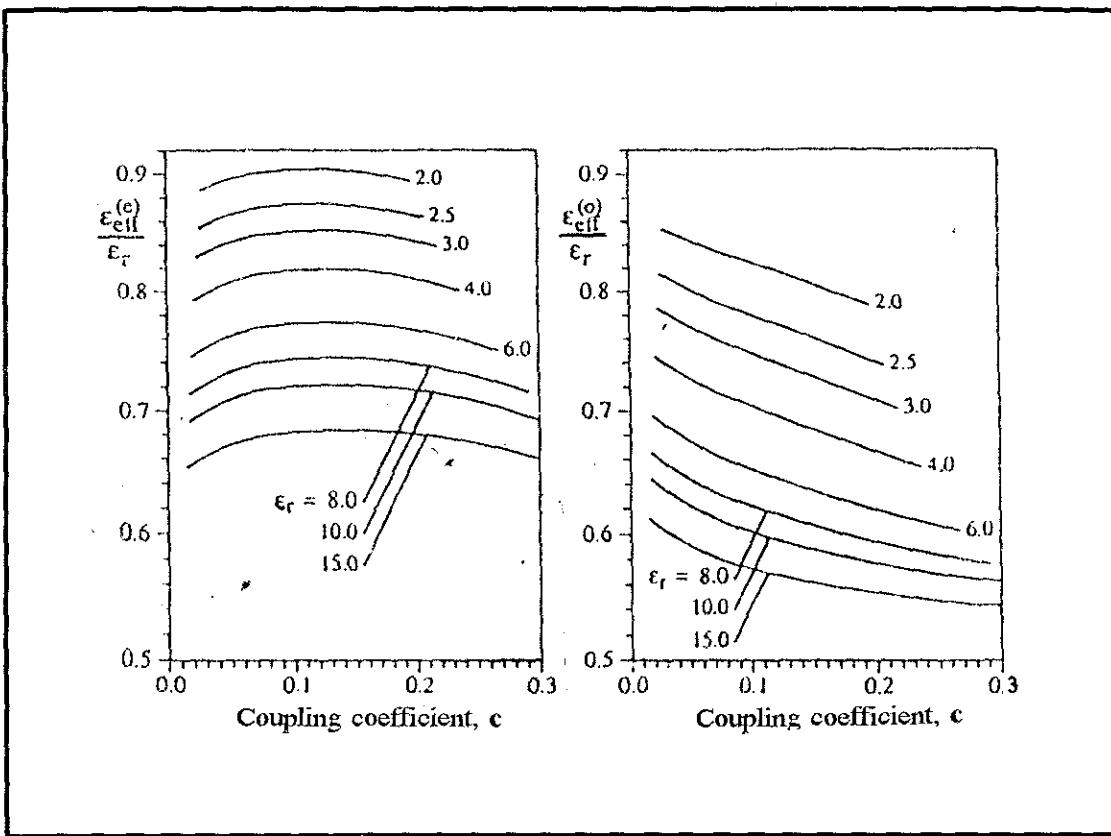
ในการออกแบบคัปเปลอร์แบบมีทิศทางนี้ก่อนที่จะพิจารณาพารามิเตอร์ของสาย จำเป็นต้องทราบถึงค่าสัมประสิทธิ์ของการคัปเปลิงของตัวคัปเปลอร์เสียก่อน ซึ่งเมื่อทราบค่าดังกล่าวแล้ว จึงหาค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของແຄນไมโครสตริปได้โดยใช้รูปที่ 2.15 ซึ่งเส้นกราฟทั้งหมดจะอยู่ในช่วง $0.1 < s/h < 4.0$ และแต่ละเส้นกราฟ จะให้ความกว้างของແຄນไมโครสตริปที่เกิดการเชื่อมต่อของสัญญาณ โดยแสดงความสัมพันธ์เป็นอตรำส่วนกับความกว้างของແຄນไมโครสตริปที่มีค่าลักษณะสมบัติทางอิมพีเดนซ์เท่ากับ 50Ω

เส้นกราฟที่แสดงถึงสภาพยอมสัมพัทธ์ทางไฟฟ้าประสิทธิผลในแต่ละโหนด ซึ่งได้แสดงไว้ในรูปที่ 2.16 จะเห็นได้ว่าเป็นฟังก์ชันของค่าสัมประสิทธิ์การคัปเปลิง และค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ทางไฟฟ้าประสิทธิผลที่นำໄปใช้ในการออกแบบตัวคัปเปลอร์แบบมีทิศทางนี้คำนวนได้จากค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ทางไฟฟ้าประสิทธิผลเฉลี่ยในโหนดคู่และโหนดคี่ดังต่อไปนี้

$\sqrt{\epsilon_{eff}} = (\sqrt{\epsilon_{eff}^{(e)}} + \sqrt{\epsilon_{eff}^{(o)}})/2 \quad (2.48)$



รูปที่ 2.15 แสดงค่าระยะห่างระหว่างແตนไมโครสตริปที่เกิดการคัปปลิงของสัญญาณ
และความกว้างของແตนสตริปที่เกิดการคัปปลิง



รูปที่ 2.16 แสดงค่าส่วนของสัมพัทธ์ทางไฟฟ้าประสิทธิผลในของโหนดคู่และโหนดคี่ที่ใช้ในการออกแบบคัปเพลอร์แบบมีทิศทาง

2.6 สรุป

ในบทนี้เป็นการศึกษาถึงโครงสร้างของไมโครสตริป และศึกษาถึงการส่งผ่านของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปตามไมโครสตริปว่ามีพฤติกรรมอย่างไร จากนั้นได้ทำการศึกษาทฤษฎีพื้นฐานที่นำไปใช้ในการออกแบบตัวกรองสัญญาณผ่านและความถี่ต่ำ และ ตัวคัปเพลอร์แบบมีทิศทาง ในส่วนของตัวกรองสัญญาณผ่านและความถี่ต่ำ เลือกศึกษาตามวิธีการออกแบบของ Butterworth หรือ Maximally-flat และในส่วนของตัวคัปเพลอร์แบบมีทิศทางได้ศึกษาถึงพฤติกรรมของคลื่นที่แพร่กระจายไปในโหนดคู่ และโหนดคี่ เมื่อทราบถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ของไมโครสตริป และค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญ ๆ ของไมโครสตริปแล้ว ในขั้นตอนต่อไปคือการนำทฤษฎีต่าง ๆ ที่ได้ศึกษาในบทนี้ไปทำการออกแบบตัวกรองสัญญาณผ่านและความถี่ต่ำในย่าน UHF และ ตัวคัปเพลอร์แบบมีทิศทางต่อไป

บทที่ 3

การออกแบบไมโครสตริปเพื่อประยุกต์ใช้งานและวิธีการทดลอง

3.1 ก่าว naï

การประยุกต์ไมโครสตริปเพื่อใช้งานของโครงงานที่เลือกศึกษานี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ตัวกรองสัญญาณผ่านแคนความถี่ต่ำในย่าน UHF และตัวคัปเปลอร์แบบมีทิกทาง ซึ่งจากทฤษฎีพื้นฐานในบทที่ 2 แสดงให้เห็นว่ารูปร่างของไมโครสตริปที่ประกอบด้วยความกว้างและความยาวนั้นมีผลในการออกแบบ เช่น ค่าลักษณะสมบัติทางอิมพีเดนซ์ จะใช้ในการคำนวณหาความกว้างของแคนไมโครสตริป และในรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบไมโครสตริป เช่น ความยาวของแคนไมโครสตริปและระยะห่างระหว่างแคนไมโครสตริปซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญอีกส่วนหนึ่ง ที่ประกอบให้ไมโครสตริปที่ออกแบบมีลักษณะที่ใช้งานได้สม่ำเสมอตัวกรองสัญญาณผ่านแคนความถี่ต่ำในย่าน UHF และตัวคัปเปลอร์แบบมีทิกทาง ซึ่งรายละเอียดได้แสดงไว้ในบทนี้รวมถึงวิธีการทดลองเพื่อแสดงให้เห็นว่าไมโครสตริปที่ประยุกต์นี้มีลักษณะการใช้งานสม่ำเสมอ เป็นตัวกรองสัญญาณผ่านแคนความถี่ต่ำในย่าน UHF และตัวคัปเปลอร์แบบมีทิกทางหรือไม่

3.2 ตัวกรองสัญญาณผ่านแคนความถี่ต่ำในย่าน UHF

3.2.1 การออกแบบตัวกรองสัญญาณผ่านแคนความถี่ต่ำในย่าน UHF

ตามวิธีการของ Butterworth หรือ Maximally-flat ใน การออกแบบตัวกรองสัญญาณผ่านแคนความถี่ต่ำในย่าน UHF ที่ได้ศึกษานี้ ค่าค่าปานาธิແຕນซ์และอินดักແຕນซ์ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวกรองสัญญาณผ่านแคนความถี่ต่ำในย่าน UHF สามารถหาได้จากสมการต่อไปนี้ [3]

$$L_k = k_k Z_0 / \omega ; H \quad (3.1)$$

$$C_k = k_k / \omega Z_0 ; F \quad (3.2)$$

ซึ่งค่า k_k สามารถหาได้จากสมการ (2.20) และค่าลักษณะสมบัติทางอิมพีเดนซ์เท่ากับ 50 โอห์ม โดยเลือกออกแบบให้มีค่าการลดตอนของสัญญาณมีค่าเท่ากับ 3 dB ที่ความถี่ 800 MHz และเลือกโอลเป็นจำนวน 5 โอล ดังนั้นเราสามารถคำนวณค่าค่าปานาธิແຕນซ์ และค่าอินดักແຕນซ์จากสมการข้างต้นดังที่ได้แสดงไว้ในตารางที่ 3.1

เนื่องจากความกว้างของແດບໄນໂຄຣສຕຣີປ (w) ຄວາມພານຂອງສາໄໄດເລື້ກຕຣິກ (h) ແລະ ຄວາມຍາວຂອງແດບໄນໂຄຣສຕຣີປ (l) ນັ້ນເປັນພາຣາມີເຕືອຮໍສໍາຄັນທີ່ໃຫ້ໃນກາຮອກແບນໄໝໄນໂຄຣສຕຣີປ ມີລັກຂະນະສົມບັດທາງອິນເປົ້າແດນ໌ເສີມອືນເປົ້າປາປັບແຕນ໌ທີ່ຮູ້ອິນດັກແຕນ໌ ດັ່ງນັ້ນຄ່າຄວາມກວ່າງ ຂອງແດບໄນໂຄຣສຕຣີປຫາໄດ້ຈາກສມການ (2.12) ແລະ (2.13) ສ່ວນຄວາມຍາວຂອງແດບໄນໂຄຣສຕຣີປນີ້ ແກ້ວຂອກເປັນ 2 ສ່ວນຄື່ອສ່ວນຂອງປາປັບແຕນ໌ແລະສ່ວນຂອງອິນດັກແຕນ໌ໂດຍໃຫ້ສມການຕ່ອໄປນີ້ [3]

$$l = (\lambda_L / 2\pi) \sin^{-1} (\omega C_k Z_L) \quad ; \text{ ປາປັບແຕນ໌ } \quad (3.3)$$

$$l = (\lambda_H / 2\pi) \sin^{-1} (\omega L_k / Z_H) \quad ; \text{ ອິນດັກແຕນ໌ } \quad (3.4)$$

ແລະໃນກາຮັນວຸນຫາຄວາມຍາວຂອງແດບໄນໂຄຣສຕຣີປນີ້ ຈຳເປັນຕ້ອງທຽບຄ່າສກາພຍອມສັນພັກທີ່ ທາງໄຟໄຟປະສິບິທີຜລ (ϵ_{eff}) ແລະ ຄວາມຍາວຄື່ນ (λ) ຜຶ່ງກຳນວນໄດ້ຈາກສມການ (2.14) (2.15) ແລະ ສມການ (2.16) ແລະ ໄດ້ແສດງຄ່າທີ່ກຳນວນໄດ້ໄວ້ໃນຕາງໆທີ່ 3.2

ຕາງໆທີ່ 3.1 ແສດງຄ່າປາປັບແຕນ໌ ແລະ ອິນດັກແຕນ໌ທີ່ໄດ້ຈາກກາຮັນວຸນ

k	k_k	L_k, nH	C_k, pF
1	0.618	-	2.458
2	1.618	16.09	-
3	2.000	-	7.958
4	1.618	16.09	-
5	0.618	-	2.458

ຕາງໆທີ່ 3.2 ແສດງຄ່າຂອງສ່ວນປະກອນຂອງໄນໂຄຣສຕຣີປທີ່ຄໍາອິນເປົ້າແດນ໌ຕ່າງໆ

Z_0, Ω	w / h	w, mm	ϵ_{eff}	$\lambda, \text{mm at 8 MHz}$
20	6.663	9.497	4.035	0.187
30	3.952	5.69	3.846	0.1912
50	1.79	2.58	3.584	0.1981
100	0.399	0.574	3.268	0.207

จากทฤษฎีที่ได้ศึกษาตามวิธีการของ Butterworth หรือ Maximally-flat ในการออกแบบตัวกรองสัญญาณผ่านแอนด์ความถี่ต่ำในย่าน UHF ให้แทนในโครงสร้างปมีความกว้างและความยาวจะได้ค่าลักษณะสมบัติทางอิมพีเดนซ์สมมูลเป็นค่าปาชิแทนชันน์ พนว่าที่ปลายของแอนนี้จะเกิดค่าลักษณะสมบัติทางอิมพีเดนซ์ที่สมมูลเป็นอินดักเต้นซ์เพิ่มขึ้นอีกด้วย และค่าอินดักเต้นซ์ที่เกิดเนื่องจากการตัดแอนน์ในโครงสร้างปดังกล่าว สามารถคำนวณได้จากสมการต่อไปนี้ [3]

$$L_c = (Z_L / \omega) \tan (\pi l / \lambda_L) \quad (3.5)$$

และในกรณีเดียวกันนี้ เมื่อออกแบบให้แอนน์ในโครงสร้างปมีความกว้างและความยาวจะได้ค่าลักษณะสมบัติทางอิมพีเดนซ์สมมูลเป็นอินดักเต้นชันน์ พนว่าที่ปลายของแอนนี้จะเกิดค่าลักษณะสมบัติทางอิมพีเดนซ์ที่สมมูลเป็นค่าปาชิแทนซ์เพิ่มขึ้นเช่นกัน และค่าค่าปาชิแทนซ์ที่เกิดเนื่องจากการตัดแอนน์ในโครงสร้างปดังกล่าว สามารถคำนวณได้จากสมการต่อไปนี้ [3]

$$C_L = (1 / \omega Z_H) \tan (\pi l / \lambda_H) \quad (3.6)$$

เริ่มออกแบบโดยกำหนดค่าลักษณะสมบัติทางอิมพีเดนซ์ให้มีค่าต่ำ (Z_L) ในการคำนวณเมื่อต้องการให้ค่าลักษณะสมบัติทางอิมพีเดนซ์นี้สมมูลเป็นค่าปาชิแทนซ์ เช่นเดียวกันกับวงจรของตัวกรองสัญญาณผ่านแอนด์ความถี่ต่ำในย่าน UHF และในโครงงานนี้กำหนดให้

$$Z_L = 30 \Omega \quad \text{เมื่อ } C_1 = C_s = 2.458 \text{ pF}$$

$$Z_L = 20 \Omega \quad \text{เมื่อ } C_3 = 2.458 \text{ pF}$$

และกำหนดค่าลักษณะสมบัติทางอิมพีเดนซ์ให้มีค่าสูง (Z_H) ในการคำนวณเมื่อต้องการให้ค่าลักษณะสมบัติทางอิมพีเดนซ์นี้สมมูลเป็นอินดักเต้นซ์เช่นเดียวกันกับวงจรของตัวกรองสัญญาณผ่านแอนด์ความถี่ต่ำในย่าน UHF และในโครงงานนี้กำหนดให้

$$Z_H = 100 \Omega \quad \text{เมื่อ } L_2 = L_s = 16.09 \text{ nH}$$

การคำนวณหาความยาวของแอนน์ในโครงสร้างปมีให้มีค่าลักษณะสมบัติทางอิมพีเดนซ์สมมูลเป็นค่าปาชิแทนซ์และสมมูลเป็นอินดักเต้นชันน์ใช้สมการ (3.3) และ (3.4) ในการคำนวณ

ตามลำดับ โดยเลือกออกแบบให้ค่าการลดตอนของสัญญาณมีค่าเท่ากับ 3 dB ที่ความถี่ 800 MHz ส่วนพารามิเตอร์อื่น ๆ ที่ใช้ในการคำนวณตามสมการดังกล่าวได้จากตารางที่ 3.1 และตารางที่ 3.2 ค่าความยาวที่ได้จากการคำนวณจะได้ดังต่อไปนี้

$$\text{ความยาวของ } C_1 \text{ และ } C_5 \Rightarrow l_1 = l_5 = 1.159 \text{ cm}$$

$$\text{ความยาวของ } C_3 \Rightarrow l_3 = 2.755 \text{ cm}$$

$$\text{ความยาวของ } L_2 \text{ และ } L_4 \Rightarrow l_2 = l_4 = 3.109 \text{ cm}$$

ส่วนค่าอินดักแทนซ์และค่าค่าปาราเซ็นเตอร์ที่เกิดขึ้นที่ปลายของแтенไมโครสตริปเมื่อแทนนี้ มีค่าลักษณะสนับติดทางอิมพีเดนซ์เสมือนเป็นค่าปาราเซ็นเตอร์และอินดักแทนซ์ตามลำดับนั้น จะใช้สมการ (3.5) และ (3.6) ในการคำนวณ และได้ค่าดังต่อไปนี้

$$\text{ค่าอินดักแทนซ์ที่เกิดขึ้น} \quad L_{C1} = L_{C5} = 1.1474 \text{ nH}$$

$$\text{ค่าอินดักแทนซ์ที่เกิดขึ้น} \quad L_{C3} = 1.989 \text{ nH}$$

$$\text{ค่าค่าปาราเซ็นเตอร์ที่เกิดขึ้น} \quad C_{L2} = C_{L4} = 1.0131 \text{ pF}$$

ค่าอินดักแทนซ์และค่าค่าปาราเซ็นเตอร์ ที่เกิดขึ้นที่ปลายของแтенไมโครสตริปดังกล่าวนี้ มีผลคือทำให้ค่าอินดักแทนซ์ และค่าค่าปาราเซ็นเตอร์ของวงจรตัวกรองสัญญาณผ่านแugen ความถี่ต่ำ ในย่าน UHF ซึ่งคำนวณไว้ในตารางที่ 3.1 มีค่าเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อทำให้ค่าอินดักแทนซ์เดิมและ ค่าค่าปาราเซ็นเตอร์เดิมในตารางที่ 3.1 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง จึงต้องชดเชยโดยการนำค่าที่เพิ่มขึ้นนี้ ไปหักออกจากของเดิมในตารางที่ 3.1 นั้นเองและค่าที่ทำการชดเชยแล้วจะได้ดังต่อไปนี้

$$C_1 = C_5 = 2.458 \text{ nF} - 1.031 \text{ nF} = 1.446 \text{ pF}$$

$$C_3 = 7.958 \text{ nF} - 2 \times (1.0131 \text{ nF}) = 5.932 \text{ pF}$$

$$L_2 = L_4 = 16.09 \text{ nH} - 1.1474 \text{ nH} - 1.989 \text{ nH} = 12.953 \text{ nH}$$

ค่าค่าปาราเซ็นเตอร์และค่าอินดักแทนซ์ที่ได้ตามข้างบนนั้น เมื่อนำไปคำนวณหาค่าความยาว ของแugen ไมโครสตริปแล้ว แugen ไมโครสตริปใหม่จะเป็นแugen ที่ถูกทำการชดเชยจากผลที่ปลายของ แugen ไมโครสตริปนี้มีค่าอินดักแทนซ์และค่าปาราเซ็นเตอร์ที่เกินมาตามลำดับ โดยที่การคำนวณ

ความยาวของແຄນໄມໂຄຣສຕຣີປໍໄທມີນີ້ຢັງໃຊ້ສາມາດ (3.3) ແລະ (3.4) ແກ້ວມືອນເດີມ ແລະ ຄວາມຍາວ
ໄໝ່ທີ່ຄໍານວນໄດ້ຈະເປັນດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

$$\text{ຄວາມຍາວຂອງ } C_1 \text{ ແລະ } C_5 \Rightarrow l_1 = l_5 = 0.6688 \text{ cm}$$

$$\text{ຄວາມຍາວຂອງ } C_3 \Rightarrow l_3 = 1.898 \text{ cm}$$

$$\text{ຄວາມຍາວຂອງ } L_2 \text{ ແລະ } L_4 \Rightarrow l_2 = l_4 = 2.34 \text{ cm}$$

ເນື່ອງຈາກທີ່ບໍລິຫານຂອງການຕ່ອແບບສະເຕປະຫວ່າງແຄນໄມໂຄຣສຕຣີປໍທີ່ໃຫ້ແມຕ່ຈີ່ (w⁵⁰) ແລະ
ແຄນໄມໂຄຣສຕຣີປໍທີ່ມີຄໍາລັກນະສົມບັດທາງອິນພີແດນໜີເສມືອນເປັນຄາປາຈີແຕນໜີ (C₁, C₅) ນີ້ຈະເກີດ
ສານາມຟຣີກິ່ງຄາປາຈີແຕນໜີນີ້ສິ່ງໄດ້ກ່າວຮາຍລະເລີຍໄວ້ໃນນັກທີ່ 2 ດັ່ງນັ້ນກາຮັດເຫຍສານາມຟຣີກິ່ງ
ຄາປາຈີແຕນໜີສາມາດຄໍານວນໄດ້ໂດຍໃຊ້ສາມາດ (2.18) ໄດ້ແກ່

$$\Delta l_{oo} / h = 0.412 \times [(\varepsilon_{eff} + 3)/(\varepsilon_{eff} - 0.258)] \times [(w/h + 0.262)/(w/h + 0.813)]$$

ເມື່ອແທນແລ້ວຈະໄດ້

$$\Delta l_{oo} / h = 0.3793$$

$$\Delta l_{oo} = 0.546$$

ດັ່ງນັ້ນຄວາມຍາວທີ່ເກີນມາສາມາດຄໍານວນໄດ້ຈາກສາມາດ (2.17) ໄດ້ແກ່

$$\Delta l = [1 - (w_1 / w_2)] \times \Delta l_{oo} ; w_1 < w_2$$

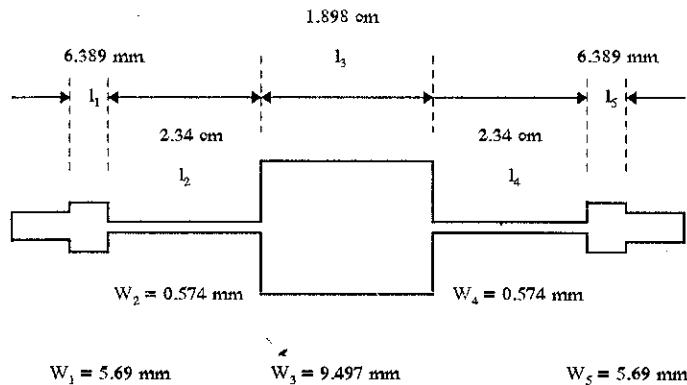
ເມື່ອແທນຄໍາແລ້ວໄດ້

$$\Delta l = 0.2995 \text{ mm}$$

ເມື່ອນຳຄ່າ Δl ທີ່ໄດ້ນີ້ ລບອອກຈາກຄວາມຍາວຂອງແຄນໄມໂຄຣສຕຣີປໍທີ່ມີຄໍາລັກນະສົມບັດ
ທາງອິນພີແດນໜີເສມືອນເປັນຄາປາຈີແຕນໜີ C₁ ແລະ C₅ ຈະໄດ້ຄວາມຍາວໄໝ່ເປັນດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

$$l_1 = l_5 = 6.688 \text{ mm} - 0.2995 \text{ mm} = 6.389 \text{ mm}$$

ດັ່ງນັ້ນຄໍາຄວາມກວ້າງແລະ ຄວາມຍາວຂອງແຄນໄມໂຄຣສຕຣີປໍ ທີ່ອອກແບບເພື່ອໃຊ້ຈານເສມືອນ
ເປັນດ້ວກຮອງສັງຄູານຜ່ານແບບຄວາມຄືຕໍ່ໃນຢ່ານ UHF ໂດຍສມນຽຸນແລ້ວ ຜຶ່ງຈະມີຮູປ່ງປ່າງດັ່ງທີ່ໄດ້ແສດງ
ໄວ້ໃນຮູບທີ່ 3.1 ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້



รูปที่ 3.1 ตัวกรองสัญญาณผ่านແດນຄວາມຄື່ຕໍ່ທີ່ມີຄ່າກາລດທອນເທົ່າກັນ 3 dB ທີ່ຄວາມຄື່ 800 MHz

เนื่องจากผลการทดลอง ที่ทำการทดสอบบนทางຄວາມຄື່ຂອງตัวกรองสัญญาณ ผ่านແດນຄວາມຄື່ຕໍ່ໃນຢ່ານ UHF ໄນໄກສະເໜີກັບທຸງຖູກທີ່ກຳນົດໄວ້ ຈຶ່ງທດລອງເພີ່ມເຕີມໂດຍ ทำการອອກແນບຕัวกรองสัญญาณผ่านແດນຄວາມຄື່ຕໍ່ໃນຢ່ານ UHF ຂຶ້ນອີກແລະເລືອກໄມ້ຄ່າຂອງ ກາລດທອນສัญญาณເທົ່າກັນ 3 dB ທີ່ຄວາມຄື່ 600 MHz ແລະ ວິທີໃນການຄໍານວນຍັງຄົງໃຫ້ຮັດເດີມ ດັ່ງທີ່ກ່າວໄວ້ແລ້ວ ແຕ່ໄດ້ເລືອກຄ່າລັກນະສົມບັດທາງອິນພີແດນໜີແຕກຕ່າງໄປຈາກກາຮອກແນບກວັງແຮກ ຕັ້ງຕ່ອໄປນີ້

ເລືອກຄ່າລັກນະສົມບັດທາງອິນພີແດນໜີຕໍ່ (Z_L) ເທົ່າກັນ 20 Ω ໃນການຄໍານວນເພື່ອໃຫ້ຫາ ຄວາມຍາວຂອງແດນໄນໂຄຣສຕຣີປີ ທີ່ມີຄ່າລັກນະສົມບັດທາງອິນພີແດນໜີເສມືອນເປັນຄາປາຊີແຕນໜີ C₁ ແລະ C₅ ຊື່ງມີຄ່າເທົ່າກັນ 3.28 pF

ເລືອກຄ່າລັກນະສົມບັດທາງອິນພີແດນໜີຕໍ່ (Z_L) ເທົ່າກັນ 15 Ω ໃນການຄໍານວນຫາຄວາມຍາວ ຂອງແດນໄນໂຄຣສຕຣີປີ ທີ່ມີຄ່າລັກນະສົມບັດທາງອິນພີແດນໜີເສມືອນເປັນຄາປາຊີແຕນໜີ C₁ ຊື່ງມີຄ່າ ເທົ່າກັນ 10.61 pF

ແລະ ໄດ້ເລືອກຄ່າລັກນະສົມບັດທາງອິນພີແດນໜີສູງ (Z_H) ເທົ່າກັນ 110 Ω ສໍາຫຼັບການຄໍານວນ ຫາຄວາມຍາວຂອງແດນໄນໂຄຣສຕຣີປີ ທີ່ມີຄ່າລັກນະສົມບັດທາງອິນພີແດນໜີເສມືອນເປັນອິນດັກແຕນໜີ L₂ ແລະ L₄ ຊື່ງມີຄ່າເທົ່າກັນ 21.46 nH

ຈາກຄ່າທີ່ໜີມີຄ່າລ່າວຂ້າງດັ່ນນີ້ ສາມາດຄໍານວນຫາຄ່າກວາມຍາວຂອງແດນໄນໂຄຣສຕຣີປີ ທີ່ມີຄ່າລັກນະສົມບັດທາງອິນພີແດນໜີເສມືອນເປັນຄາປາຊີແຕນໜີ ແລະ ອິນດັກແຕນໜີ ທີ່ໄດ້ທຳກາຮັດເຊຍ ທີ່ໜີມີຄ່າລ່າວຂ້າງດັ່ນນີ້ ໄດ້ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

$$\text{ความยาวของ } C_1 \text{ และ } C_5 \Rightarrow l_1 = l_5 = 0.6276 \text{ cm}$$

$$\text{ความยาวของ } C_3 \Rightarrow l_3 = 1.956 \text{ cm}$$

$$\text{ความยาวของ } L_2 \text{ และ } L_4 \Rightarrow l_2 = l_4 = 3.232 \text{ cm}$$

เนื่องจากผลการทดลองที่ทำการหาผลตอบสนองทางความถี่ของตัวกรองสัญญาณผ่านແตนความถี่ต่ำในย่าน UHF ยังคงมีค่าค่าลดเคลื่อนจากทฤษฎีที่ทำการศึกษาไว้จึงทำการทดลองเพิ่มเติมโดยทำการออกแบบตัวกรองสัญญาณผ่านແตนความถี่ต่ำในย่าน UHF ขึ้นอีกและเลือกให้มีค่าการลดตอนของสัญญาณเท่ากับ 3 dB ที่ความถี่ 500 MHz และใช้วิธีเดินในการคำนวณโดย

เลือกค่าลักษณะสมบัติทางอิมพีเดนซ์ต่ำ (Z_L) เท่ากับ 20Ω ใน การคำนวณเพื่อใช้ทำความยาวของແตนไมโครสตริป ที่มีค่าลักษณะสมบัติทางอิมพีเดนซ์เดิมมีอยู่ค่าปัจจิแตนซ์ C_1 และ C_5 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 3.93 pF

เลือกค่าลักษณะสมบัติทางอิมพีเดนซ์ต่ำ (Z_L) เท่ากับ 15Ω ใน การคำนวณหาความยาวของແตนไมโครสตริป ที่มีค่าลักษณะสมบัติทางอิมพีเดนซ์เดิมมีอยู่ค่าปัจจิแตนซ์ C_1 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 12.73 pF

และได้เลือกค่าลักษณะสมบัติทางอิมพีเดนซ์สูง (Z_H) เท่ากับ 110Ω สำหรับการคำนวณหาความยาวของແตนไมโครสตริป ที่มีค่าลักษณะสมบัติทางอิมพีเดนซ์เดิมมีอยู่ค่าปัจจิแตนซ์ L_2 และ L_4 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 25.75 nH

จากค่าห้องหมอดักล่าวข้างต้นนี้ สามารถคำนวณหาค่าความยาวของແตนไมโครสตริป ที่มีค่าลักษณะสมบัติทางอิมพีเดนซ์เดิมมีอยู่ค่าปัจจิแตนซ์และอินดักแตนซ์ ที่ได้ทำการซัดเชยห้องหมอดแล้วนั้น ได้ดังต่อไปนี้

$$\text{ความยาวของ } C_1 \text{ และ } C_5 \Rightarrow l_1 = l_5 = 0.759 \text{ cm}$$

$$\text{ความยาวของ } C_3 \Rightarrow l_3 = 2.3468 \text{ cm}$$

$$\text{ความยาวของ } L_2 \text{ และ } L_4 \Rightarrow l_2 = l_4 = 3.8789 \text{ cm}$$

เมื่อได้ขนาดของແตนไมโครสตริปที่ต้องการนำไปใช้งานเสร็จมีอยู่ค่าความยาวของสัญญาณผ่านແตนความถี่ต่ำในย่าน UHF และ ต่อไปคือการตัดແตนไมโครสตริป ซึ่งโครงงานเลือกใช้แผ่นวงจรพิมพ์สองหน้า ที่มีสารไดเล็กตริกเป็นสารอิฟิอคซ์ในการกัดลายเป็นແตนไมโครสตริป ตามที่ออกแบบไว้ เมื่อได้แผ่นวงจรไมโครสตริปที่ให้มีลักษณะการใช้งานเป็นตัวกรองสัญญาณ

ผ่านແຕນຄວາມຄືຕໍ່ໃນຢ່ານ UHF ຕາມທີ່ອອກແບນແລ້ວ ຕ່ອໄປຄືກາຣທດລອງເພື່ອຫາພລຕອນສນອງທາງ
ຄວາມຄືຂອງຕັວຮອງສັງຄູານີ້

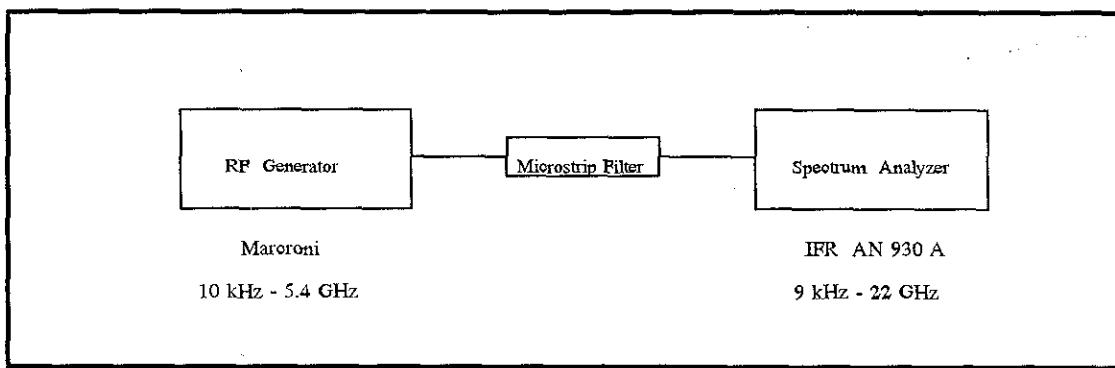
3.2.2 ວິທີກາຣທດລອງເພື່ອຫາພລຕອນສນອງທາງຄວາມຄື

ອຸປະກຣົນທີ່ໃຊ້ໃນກາຣທດລອງ ຄືອ ຕັວຮອງສັງຄູານີ້ ຜ່ານແຕນຄວາມຄືຕໍ່ໃນຢ່ານ UHF ທີ່ໄດ້
ອອກແບນໄວ້ ເກື່ອງ Spectrum Analyzer ແລະເກື່ອງ RF Generator ແລະທຳກາຣທດລອງດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

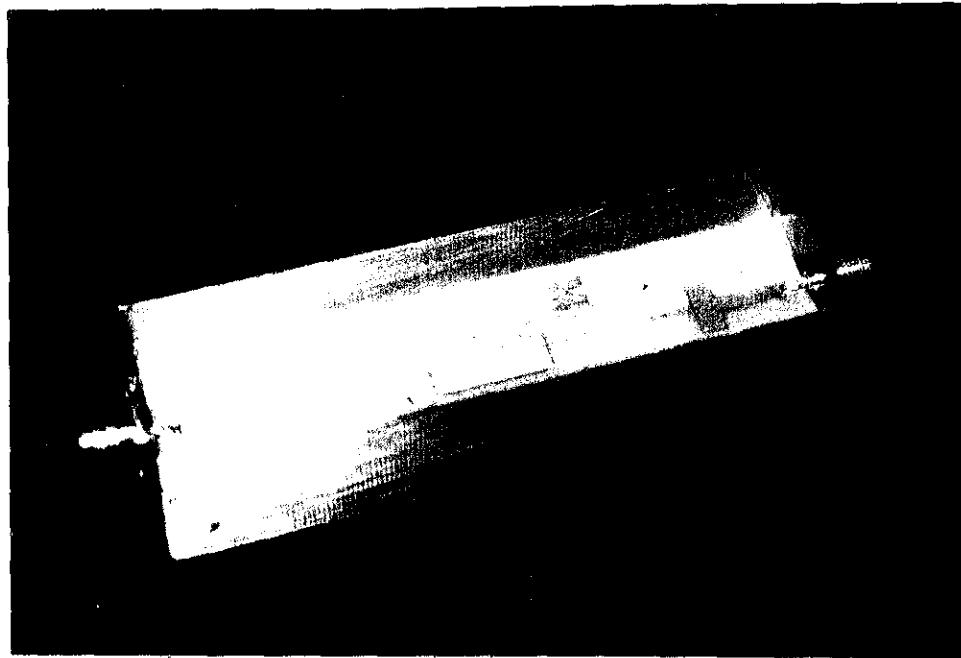
1. ນຳຕັວຮອງສັງຄູານີ້ ຜ່ານແຕນຄວາມຄືຕໍ່ໃນຢ່ານ UHF ມາທຳກວາມສະອາດໂດຍໃຊ້ຍາງລົນ
ລົນກ່ອນທີ່ຈະນຳໄປບັດກີ່ເກົ້າກັບສາຍສ່າງສັງຄູານີ້ ແລະສາຍສ່າງສັງຄູານີ້ຈະໃຊ້ສາຍແບນກົ່ງແບ່ງເພົະ
ສາມາຄຮອງຮັບສັງຄູານີ້ ໃນຢ່ານຄວາມຄືຂຶ້ນຕົ້ນ UHF ໄດ້ ຈາກນີ້ຕ່ອງຕັວຮອງສັງຄູານີ້ ຜ່ານແຕນ
ຄວາມຄືຕໍ່ໃນຢ່ານ UHF ນີ້ເກົ້າກັບເກື່ອງ RF Generator ແລະເກື່ອງ Spectrum Analyzer ດັ່ງຮູບທີ່ 3.2

2. ທຳກາຣທດລອງຫາພລຕອນສນອງທາງຄວາມຄື ຂອງຕັວຮອງສັງຄູານີ້ ຜ່ານແຕນຄວາມຄືຕໍ່ໃນຢ່ານ
UHF ໂດຍເປີ່ອນຄວາມຄືທາງດ້ານເກື່ອງ RF generator ຕັ້ງແຕ່ 150 MHz ຈາກ 2000 MHz
(ເຫຼຸ້ມທີ່ເຮື່ອມບັນທຶກພລຕອນສນອງທາງຄວາມຄືທີ່ 150 MHz ເພະຄວາມຄືທີ່ຕໍ່າກວ່ານີ້ ຈະໜ້າມເກື່ອງໄປ
ໂດຍໄປຜ່ານຕັວຮອງສັງຄູານີ້ ຜ່ານແຕນຄວາມຄືຕໍ່ໃນຢ່ານ UHF ເພະເກື່ອງ RF Generator ແລະ
ເກື່ອງ Spectrum Analyzer ອູ້ໄກລັກນຳມາກ ເນື່ອງຈາກສາຍສ່າງສັງຄູານີ້ແບນກົ່ງແບ່ງສັນມາກນັ້ນອອງ)
ປຽບໄທ້ຄ່າລົດທອນທີ່ເກື່ອງ RF Generator ໄທ່ເກົ້າກັບ 40 dB ເພື່ອໄທ້ເກື່ອງ Spectrum Analyzer
ສາມາຄອານຄໍາກໍລັງຈາກດ້ານຫາອອກໄດ້ ແລ້ວທຳກາຣບັນທຶກຄໍາກໍລັງຈາກຫາອອກ ພ ທີ່ແຕ່ລະຄວາມຄື
ທີ່ເປີ່ອນໄປ

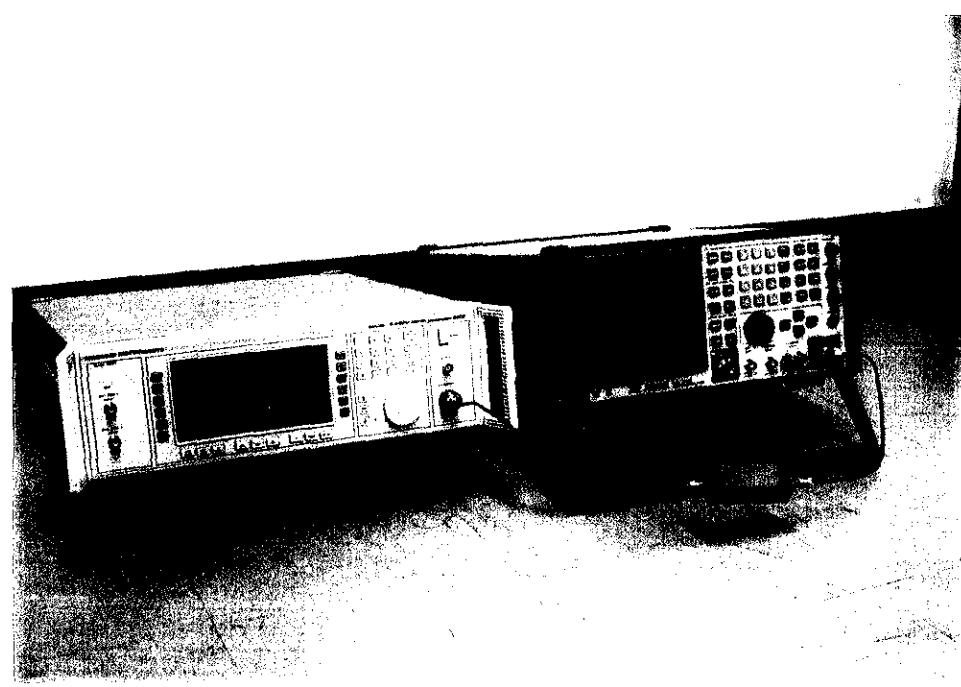
3. ນຳຄ່າທີ່ບັນທຶກໄວ້ໄປພລືອຕກຮາຟແສດງພລຕອນສນອງທາງຄວາມຄື ເພື່ອໄທ້ແກນແນວອນ
ແສດງຄວາມຄືທີ່ທຳກາຣທດລອງ ແລະແກນແນວຕັ້ງແສດງພລຕອນສນອງທາງຄວາມຄື



ຮູບທີ່ 3.2 ແສດງອຸປະກຣົນແລະກາຣທດລອງທີ່ອຸປະກຣົນໃນກາຣທດລອງຫາພລຕອນສນອງທາງຄວາມຄື
ຂອງຕັວຮອງສັງຄູານີ້ ຜ່ານແຕນຄວາມຄືຕໍ່ໃນຢ່ານ UHF



รูปที่ 3.3 รูปร่างของไมโครสติปท์ออกแบบให้มีลักษณะเลมีອนเป็นตัวกรองสัญญาณ
ผ่านแทนความถี่ต่ำในย่าน UHF



รูปที่ 3.4 แสดงการต่อเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองหาผลตอบสนองทางความถี่
ของตัวกรองสัญญาณผ่านแทนความถี่ต่ำในย่าน UHF

3.3 ตัวคัปเปลอร์แบบมีทิศทาง

3.3.1 การออกแบบตัวคัปเปลอร์แบบมีทิศทาง

โครงการนี้เลือกออกแบบให้ค่าสัมประสิทธิ์ของการเชื่อมต่อมีค่าเท่ากับ 15 dB ดังนั้นค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบตัวคัปเปลอร์แบบมีทิศทางสามารถหาได้จากกราฟในรูปที่ 2.15 แต่เนื่องจากค่าสภาพยอมทางไฟฟ้าของสารไดเล็กตริก ที่เลือกใช้ในโครงการคือสารอิฟอคซี ซึ่งค่าโดยประมาณคือ 4.8 ซึ่งไม่ได้แสดงไว้ในกราฟ ดังนั้นจึงใช้วิธีการเทียบค่าโดยการอ่านค่าที่สภาพยอมทางไฟฟ้าคือ 4 และ 6 ก่อน แล้วเทียบหาค่าสภาพยอมทางไฟฟ้า 4.8 จาก 2 ค่าข้างต้นซึ่งได้ผลดังนี้

$$\varepsilon_r^4 \Rightarrow \log(s/h) = -0.43$$

$$\varepsilon_r^6 \Rightarrow \log(s/h) = -0.32$$

จากค่าที่ได้ในข้างต้นนี้ สามารถหาค่าของ $\log(s/h)$ เมื่อ $\varepsilon_r = 4.8$ ได้ดังนี้

$$\varepsilon_r^{4.8} \Rightarrow \log(s/h) = -0.386$$

เพราะนั้น $s/h = 0.411$

และเมื่อ $h = 1.44 \text{ mm} \Rightarrow s = 0.59184 \text{ mm}$

และจากกราฟในรูปที่ 2.15 ยังสามารถหาค่าความกว้างของแอบไมโครสเตริปได้ ซึ่งใช้วิธีการเทียบเช่นเดิมดังต่อไปนี้

$$\varepsilon_r^4 \Rightarrow w/w^{(50)} = 0.909$$

$$\varepsilon_r^6 \Rightarrow w/w^{(50)} = 0.92$$

จากค่าดังกล่าว สามารถหาค่าของ $w/w^{(50)}$ เมื่อ $\varepsilon_r = 4.8$ ได้ดังนี้

$$\varepsilon_r^{4.8} \Rightarrow w/w^{(50)} = 0.9142$$

เนื่องจาก $w^{(50)}/h = 1.79$ และ $w^{(50)} = 2.577 \text{ mm}$

ดังนั้นจะได้ว่า $w = 2.3564 \text{ mm}$

จากสมการ (2.46), (2.47) และ (2.48) ตามทฤษฎีซึ่งกล่าวไว้ในบทที่ 2 สามารถหาค่าพารามิเตอร์ของตัวปั๊บลอร์เบนเมทิกทางได้ดังนี้

$$\varepsilon_{\text{eff}}^{(e)} = 3.812$$

$$\varepsilon_{\text{eff}}^{(o)} = 3.08$$

$$\varepsilon_{\text{eff}} = 3.436$$

และสามารถหาค่าความยาวคลื่นได้ดังนี้

$$\begin{aligned}\lambda &= \lambda_0 / \sqrt{\varepsilon_{\text{eff}}} \\ &= 0.2023\end{aligned}$$

ดังนั้นค่าความยาวของแถบไมโครสตริปที่เกิดการเชื่อมต่อของคลื่นมีค่าดังนี้

$$\lambda/4 = 0.05058 \text{ m}$$

โดยยุมที่ตัดออกสามารถคำนวณได้จากสูตรดังต่อไปนี้

$$y = (1.04 + 1.3 \times \exp(-1.35w/h)) \times w \quad (3.7)$$

เมื่อ $w = 2.3564 \text{ mm}$ และ $h = 1.44 \text{ mm}$

จะได้ $y = 2.787 \text{ mm}$

$$m = 52 + 65 \times \exp(-1.35 \times w/h) \quad (3.8)$$

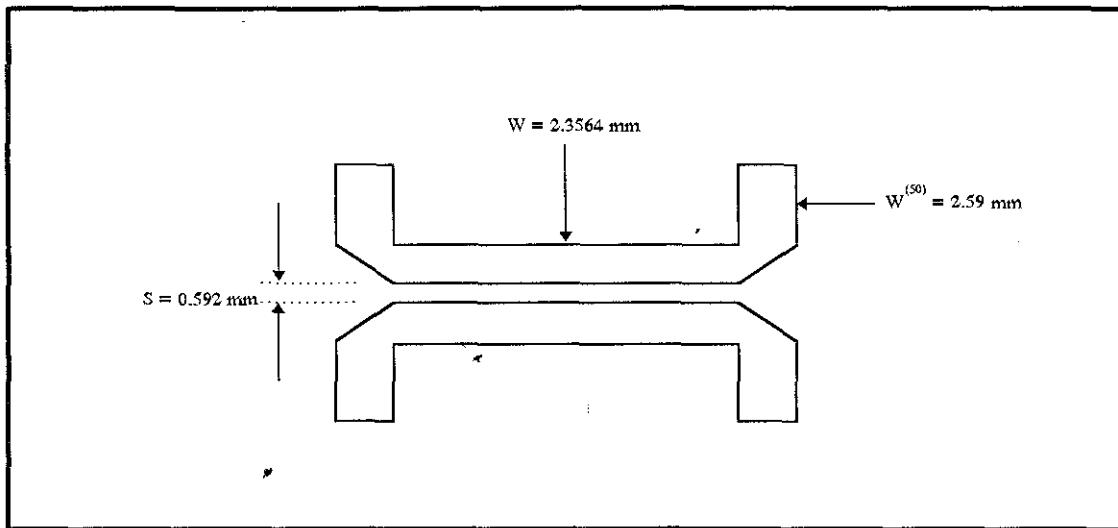
แทนค่าจะได้ $m = 59.13678$

เมื่อ $m = (x \times 100\%)/d$ (3.9)

แล้ว $d = (2.3564^2 + 2.577^2) = 3.49206$

ดังนั้นจะได้ $x = 2.0451$

รูปร่างของตัวคัปเพลอร์แบบมีทิศทางที่ได้ออกแบบไว้ จะแสดงให้เห็นในรูปที่ 3.5



รูปที่ 3.5 แสดงรูปร่างของตัวคัปเพลอร์แบบมีทิศทางที่ใช้งานที่ความถี่ 800 MHz และมีค่าสัมประสิทธิ์ของการเชื่อมต่อเท่ากับ 15 dB

เมื่อได้ขนาดของແตนໄນໂຄຣສຕຣີປ ທີ່ດອງການນຳໄປໃຊ້ຈະແນວອືນເປັນຕົວຕັບປັບປຸລົມ ປີເລີກຕົກເປັນຕົວຕັບປັບປຸລົມ ຕ່ອໄປກີ່ການຕັດແຕນໄນໂຄຣສຕຣີປ ຈຶ່ງໂຄຮງຈານເລືອກໃຫ້ແຜ່ນວົງຈະພິມພໍສອງໜັນທີ່ມີສາງໄດ້ເລີກຕົກເປັນຕົວຕັບປັບປຸລົມ ອີກຕົກຕົວຕັບປັບປຸລົມ ພົມມີກັບຄະການໃຊ້ຈະເປັນຕົວຕັບປັບປຸລົມມີທີ່ການຕັດແຕນໄວ້ ຕ່ອໄປກີ່ການທົດລອງເພື່ອຫາພົດຕອນສູນອົງກໍາລັງງານການຕັບປັບປຸລົມຂອງຕົວຕັບປັບປຸລົມນີ້

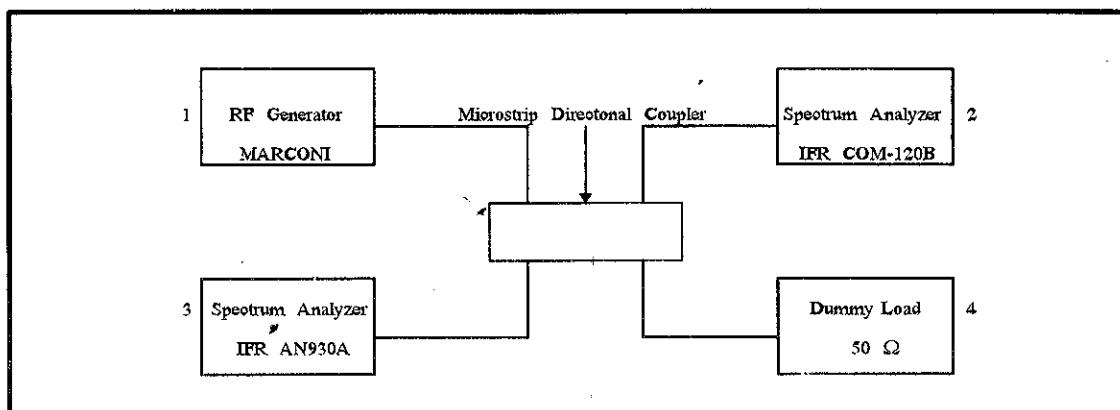
3.3.2 ວິທີການທົດລອງເພື່ອຫາພົດຕອນສູນອົງກໍາລັງງານການຕັບປັບປຸລົມ

ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໃນການທົດລອງ ຄື່ອ ຕົວຕັບປັບປຸລົມມີທີ່ການຕັດແຕນໄວ້ ເກື່ອງ Spectrum Analyzer ແລະ ເກື່ອງ RF Generator ແລະ ທຳການທົດລອງດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

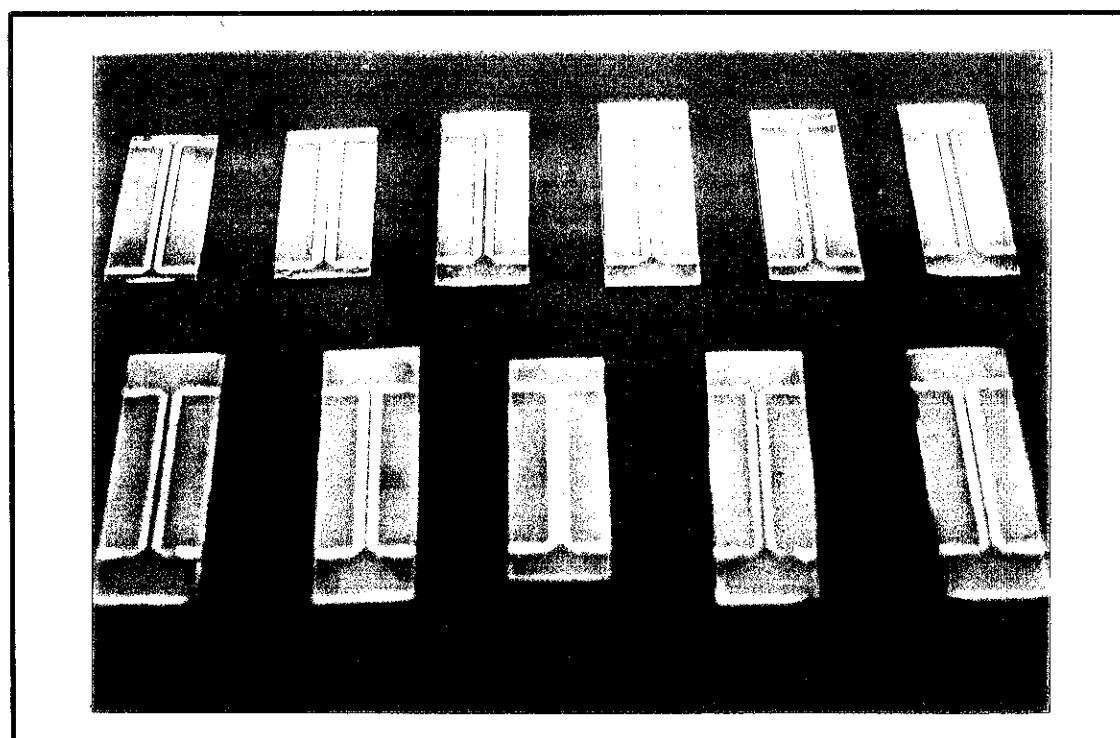
1. ນຳຕົວຕັບປັບປຸລົມມີທີ່ການຕັດແຕນໄວ້ ມາທຳຄວາມສະອາດ ໂດຍໃໝ່ຢາງລົບ ລົບກ່ອນນຳໄປບັດກີ່ເຫັກັນສ່າງສັນຍາ ແລະ ສ່າງສັນຍານີ້ຈະໃຊ້ສ່າຍແນບກົ່ງເໜິ່ງພະສາມາດຮອງຮັບສັນຍານໃນຍ່ານຄວາມຖື່ນາດ UHF ໄດ້. ຈາກນີ້ຕ້ອງຕົວຕັບປັບປຸລົມມີທີ່ການນີ້ເຫັກັນເກື່ອງ RF Generator ແລະ ເກື່ອງ Spectrum Analyzer ດັງຮູບທີ່ 3.6

2. ທຳການທົດລອງຫາພົດຕອນສູນອົງກໍາລັງງານການຕັບປັບປຸລົມ ຂອງຕົວຕັບປັບປຸລົມມີທີ່ການຕັດແຕນໄວ້ ໂດຍໃໝ່ຄວາມຖື່ການຕໍ່ກຳນົດຕົວຕັບປັບປຸລົມ ເກື່ອງ RF Generator ເທົ່ານັ້ນ 800 MHz ແລະ ສ່າງດ້ວຍກໍາລັງ 0 dB ຂະນະທີ່

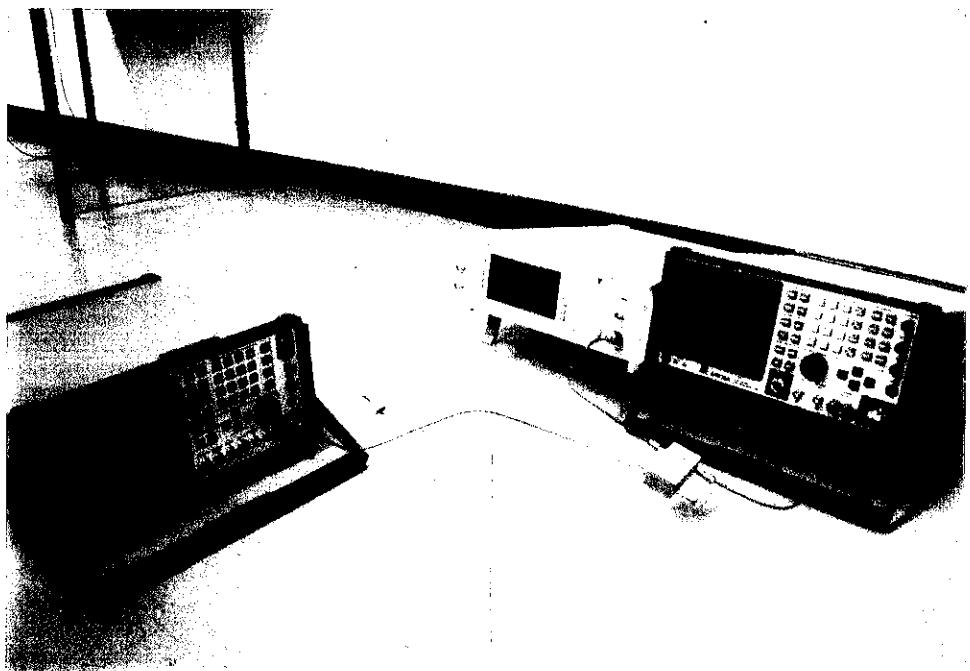
เครื่อง Spectrum Analyzer รับด้วยค่าการลดทอน 30 dB เพื่อให้อ่านกำลังด้านขาออกได้ แล้วบันทึกผลของผลตอบสนองกำลังงานการคัปปลิ่งที่พอร์ต 2 และ 3 ส่วนที่พอร์ต 4 ใส่ดัมมี่โหลด ขณะทำการทดลอง



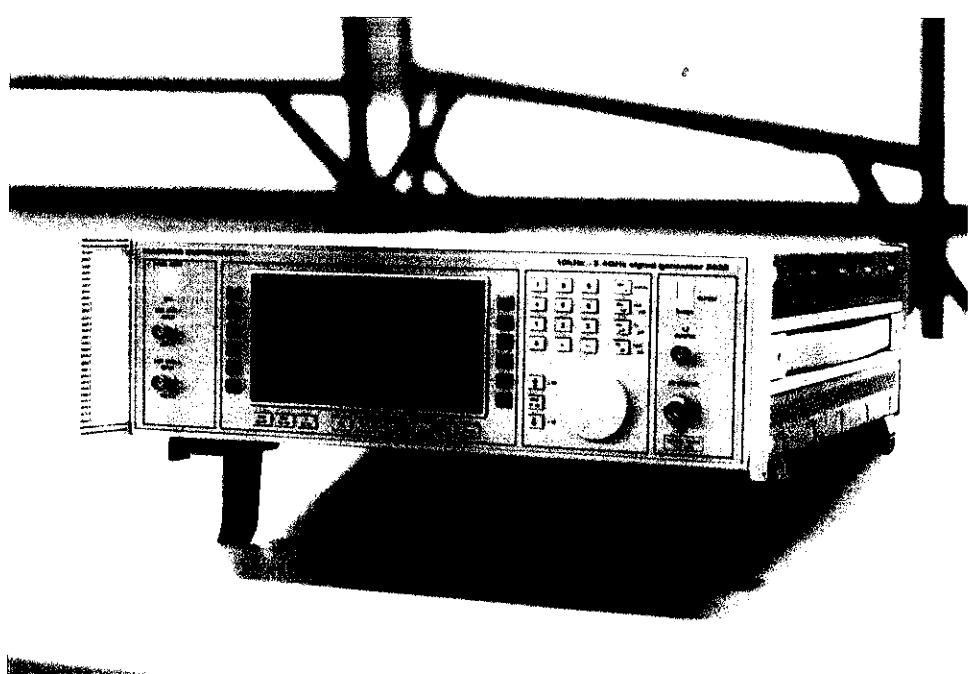
รูปที่ 3.6 แสดงอุปกรณ์และการต่ออุปกรณ์ในการทดลองหาผลตอบสนองกำลังงานการคัปปลิ่งของตัวคัปปลิ่งแบบมีทิศทาง



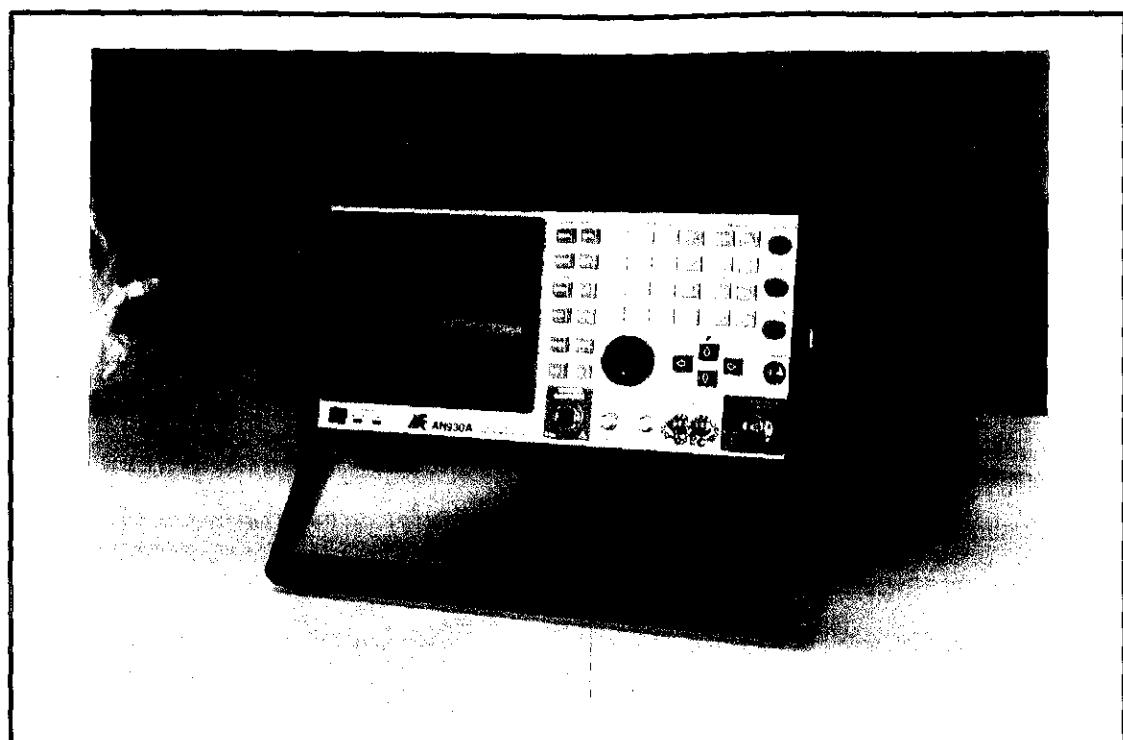
รูปที่ 3.7 รูปร่างของไมโครสตริปที่ออกแบบให้มีลักษณะเดเมื่อเป็นตัวคัปปลิ่งแบบมีทิศทางขนาดต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดลอง



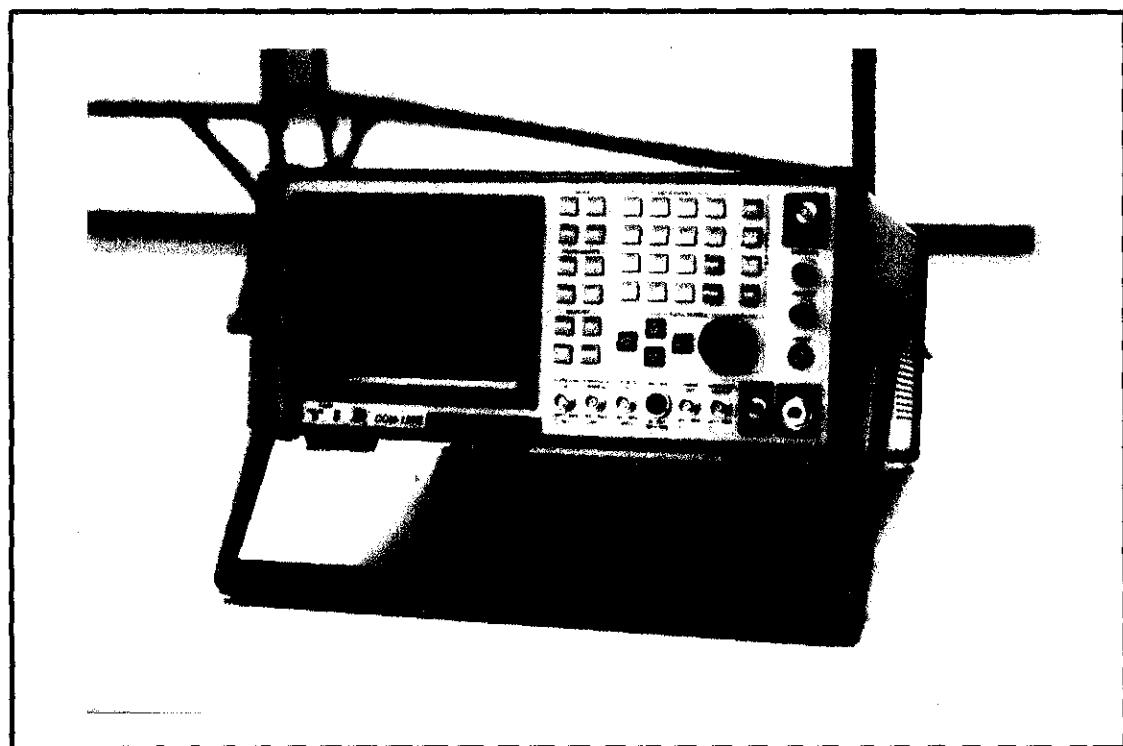
รูปที่ 3.8 แสดงการต่อเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองหาผลตอบสนองกำลังงานการกันปลิงของตัวคัปเปโลร์แบบมีทิกทาง



รูปที่ 3.9 เครื่อง RF Generator 10 kHz-5.4 GHz ของ MARCONI



รูปที่ 3.10 เครื่อง Spectrum Analyzer 9 kHz-22 GHz รุ่น AN930A ของ IFR



รูปที่ 3.11 เครื่อง Spectrum Analyzer รุ่น COM-120B ของ IFR

3.4 สรุป

การออกแบบไมโครสตริปเพื่อให้มีลักษณะการใช้งานที่สมบูรณ์เป็นตัวรองสัญญาณ ผ่านแอนด์ความถี่ต่ำในย่าน UHF นั้น อันดับแรกที่ต้องทราบคือค่าค่าปาร์เซนต์และค่าอินดักเต้นซ์ ที่ต้องการในวงจรของตัวรองสัญญาณผ่านแอนด์ความถี่ต่ำในย่าน UHF ซึ่งมีความถี่ในการลดthon ของสัญญาณเท่ากับ 3 dB และจำนวนโพลเย็นพารามิเตอร์สำคัญในการหาค่าดังกล่าว อันดับต่อไป คือการหาความกว้างและความยาวของแอนด์ไมโครสตริป เพื่อให้มีค่าลักษณะสมบัติทางอิมพีเดนซ์ สมบูรณ์เป็นค่าค่าปาร์เซนต์และค่าอินดักเต้นซ์ที่หาไว้ในอันดับแรกของการออกแบบ นอกจากนั้น ต้องทำการซัดเชยค่าอินดักเต้นซ์และค่าค่าปาร์เซนต์ที่เพิ่มมา ซึ่งเกิดที่ปลายของแอนด์ไมโครสตริป เมื่อตัดແตนไมโครสตริปตามที่ออกแบบนั้นจากค่าค่าปาร์เซนต์และค่าอินดักเต้นซ์ในอันดับแรก ตามลำดับ จากนั้นจึงหาความยาวใหม่ของค่าค่าปาร์เซนต์และค่าอินดักเต้นซ์ที่ผ่านการซัดเชยแล้ว ส่วนอันดับสุดท้าย คือ บริเวณที่มีการเชื่อมต่อระหว่างແตนไมโครสตริปเพื่อการแมตช์ของวงจร กับແตนไมโครสตริปที่มีลักษณะสมบัติทางอิมพีเดนซ์สมบูรณ์เป็นค่าปาร์เซนต์ตัวที่ 1 และ ตัวที่ 2 เพราะบริเวณนี้จะเกิดสนามฟริงกิ้งค่าปาร์เซนต์ขึ้น ในส่วนของการออกแบบไมโครสตริปเพื่อ ให้มีลักษณะการใช้งานสมบูรณ์เป็นตัวกับปลอร์แบบมีหีบทางนั้น อันดับแรก คือ ต้องกำหนด ค่าสัมประสิทธิ์ของการเชื่อมต่อที่ต้องการ แล้วนำไปหาความกว้างของแอนด์ไมโครสตริปที่เกิดการ เชื่อมต่อและหาความกว้างของระยะห่างระหว่างແตนไมโครสตริปที่เกิดการเชื่อมต่อ ซึ่งสามารถ หาได้จากการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ระยะห่างระหว่างແตนไมโครสตริปและความกว้าง ของแอนด์ไมโครสตริปที่เกิดการเชื่อมต่อซึ่งเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ของการเชื่อมต่อ กับค่า สภาพยอดทางไฟฟ้าต่างๆ ของสารไดเล็กติก อันดับต่อไป คือการหาความยาวแคนไมโครสตริป ที่เกิดการเชื่อมต่อ และอันดับสุดท้าย คือการตัดมนุน ระยะห่างແตนไมโครสตริปเพื่อการแมตช์ของ วงจร และແตนไมโครสตริปที่เกิดการเชื่อมต่อ

บทที่ 4

ผลการทดลอง

4.1 กล่าวว่า

ผลการทดลองในโครงการนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ตามการออกแบบและวิธีการทดลอง ในบทที่ 3 คือ ผลการทดลองหาผลตอบสนองทางความถี่ของตัวกรองสัญญาณผ่านແນกความถี่ต่ำ ในย่าน UHF และผลการทดลองเพื่อที่หาผลตอบสนองกำลังงานการคัปปัลิงของตัวคัปเปลอร์แบบ มีทิศทาง

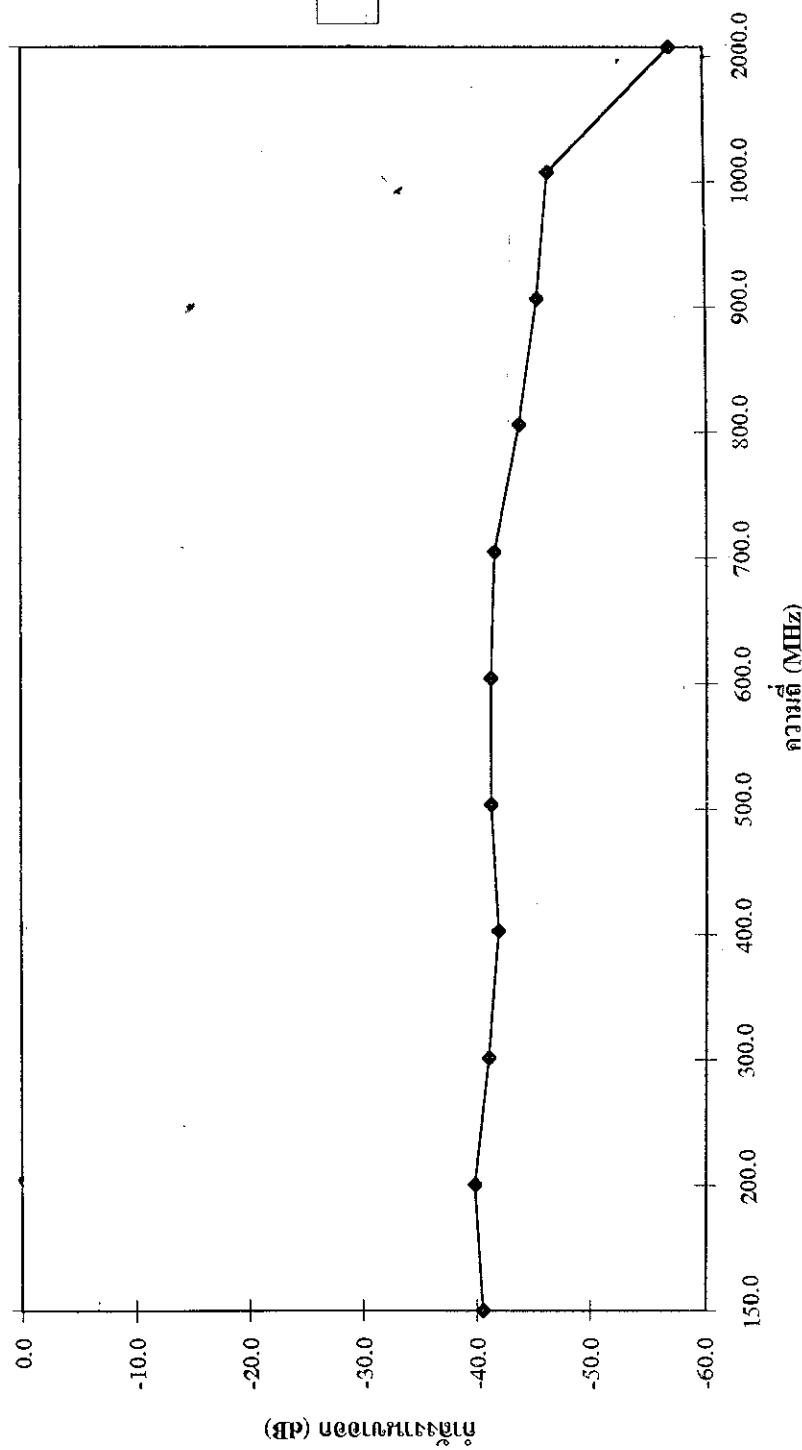
4.2 ผลการทดลองหาผลตอบสนองทางความถี่ของตัวกรองสัญญาณผ่านແນกความถี่ต่ำ ในย่าน UHF

เมื่อทำการทดลองตามวิธีการทดลองเพื่อหาผลตอบสนองทางความถี่ของตัวกรองสัญญาณ ผ่านແນกความถี่ต่ำที่มีค่าการลดthonของสัญญาณเท่ากับ 3 dB ที่ความถี่ 800 MHz ที่ได้ออกแบบไว้ โดยการเปลี่ยนค่าความถี่ตั้งแต่ 150 MHz ถึง 2000 MHz แล้วบันทึกผลการทดลองได้ดังนี้

ตารางที่ 4.1 ผลตอบสนองทางความถี่ เมื่อค่าการลดthonของสัญญาณเท่ากับ 3 dB
ที่ความถี่ 800 MHz

ความถี่ (MHz)	กำลังงานขาออก
150.0	-40.6
200.0	-39.9
300.0	-41.2
400.0	-42.1
500.0	-41.5
600.0	-41.5
700.0	-41.8
800.0	-44.0
900.0	-45.6
1000.0	-46.5
2000.0	-57.1

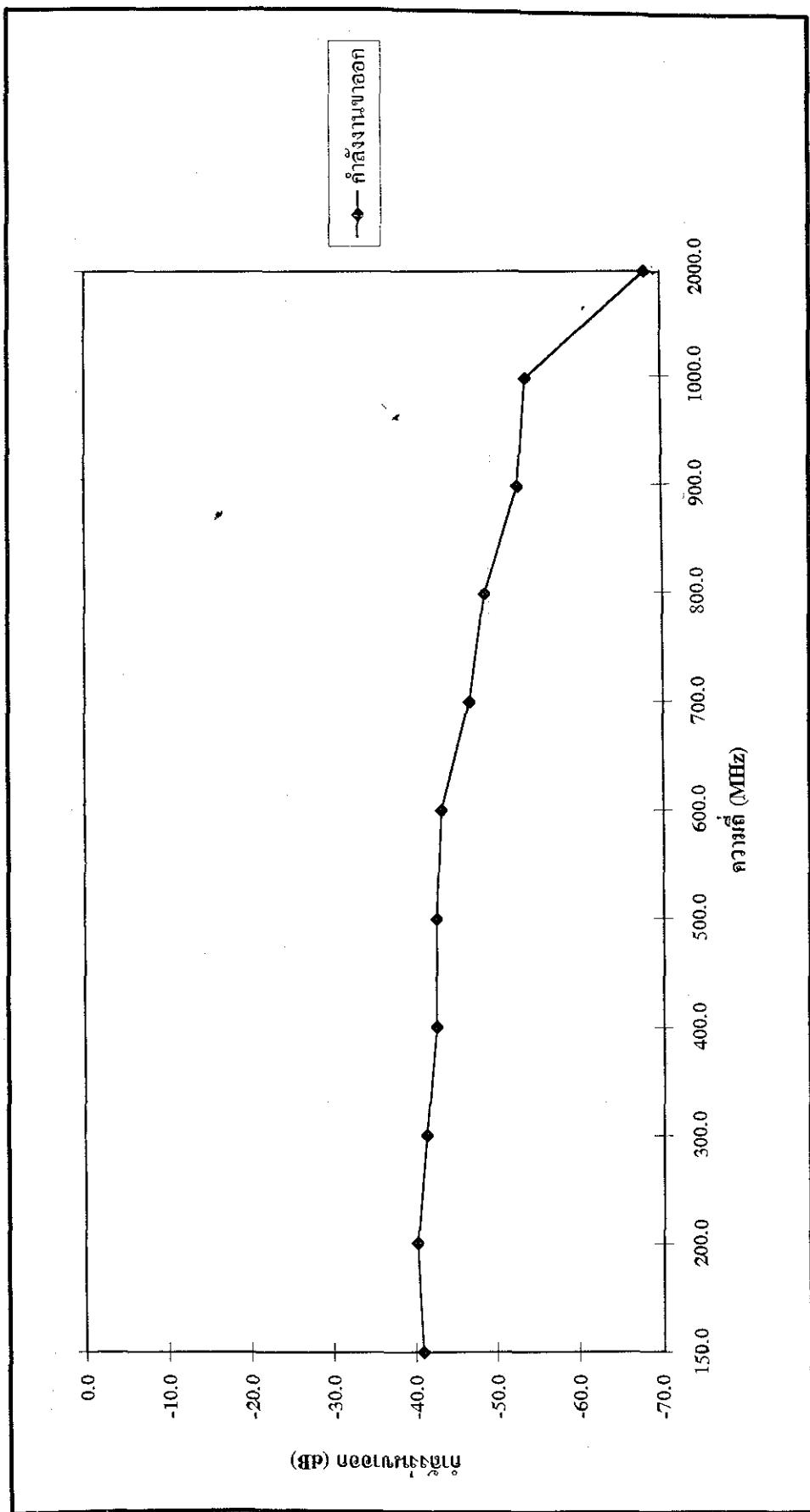
รูปที่ 4.1 ค่าความสัมด้วยความถี่ของความถี่ต่ำที่สุดของอุปกรณ์สำหรับ 3 dB ที่ความถี่ 800 MHz



จากผลการทดลองเมื่อออคแบบให้ตัวกรองสัญญาณผ่านແນບความถี่ต่ำในย่าน UHF มีค่าการลดTHONของสัญญาณเท่ากับ 3 dB ที่ความถี่ 800 MHz พนวจกำลังงานขาออกยังคงลดลงเรื่อยๆ จนถึงที่ความถี่ 1000 MHz กำลังงานขาออกจึงลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งในการใช้งานตัวกรองสัญญาณผ่านແນບความถี่ต่ำนี้ควรมีการลดTHONของสัญญาณลงอย่างรวดเร็ว เมื่อถึงความถี่ที่ออคแบบให้มีการลดTHONของสัญญาณเท่ากับ 3 dB ไว้นั่นคือ ควรมีการลดTHONของสัญญาณลงอย่างรวดเร็วเมื่อถึงความถี่ 800 MHz ดังนั้นผลที่ได้จากการทดลองจึงคาดเคลื่อนไปจากทฤษฎีมาก จึงทดลองเพิ่มโดยทำการออคแบบตัวกรองสัญญาณผ่านແນບความถี่ต่ำในย่าน UHF ให้มีค่าการลดTHONของสัญญาณเท่ากับ 3 dB ที่ความถี่ 600 MHz แล้วทำการทดลองและบันทึกผลการทดลองด้วยวิธีเดิม เพื่อหาผลตอบสนองทางความถี่ของตัวกรองสัญญาณตัวนี้ซึ่งได้ผลดังนี้

ตารางที่ 4.2 ผลตอบสนองทางความถี่ เมื่อค่าการลดTHONของสัญญาณเท่ากับ 3 dB
ที่ความถี่ 600 MHz

ความถี่ (MHz)	กำลังงานขาออก
150.0	-40.9
200.0	-40.3
300.0	-41.5
400.0	-42.8
500.0	-42.8
600.0	-43.4
700.0	-46.8
800.0	-48.7
900.0	-52.8
1000.0	-53.7
2000.0	-68.1



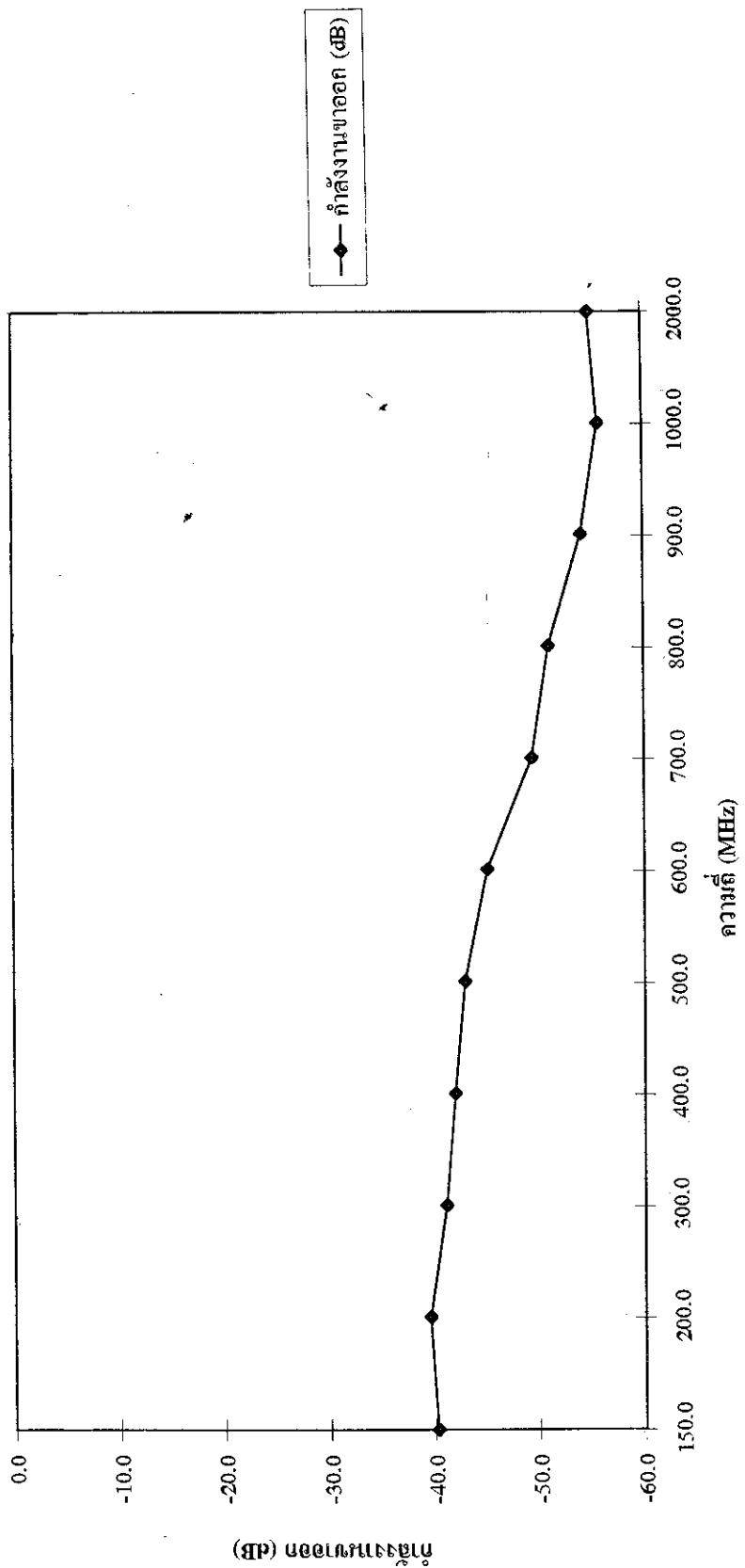
รูปที่ 4.2 กราฟแสดงผลตอบสนองทางความถี่เมื่อออกแบบแนวโน้มการลดทอนของสัญญาณทำก้าม 3 dB ที่ความถี่ 600 MHz

จากผลการทดลองเมื่อออคแบบให้ตัวกรองสัญญาณผ่านแทนความถี่ต่ำในย่าน UHF มีค่าลดตอนของสัญญาณเท่ากับ 3 dB ที่ความถี่ 600 MHz พนว่ากำลังงานข้ออกคงคลงเรื่อย ๆ จนถึงที่ความถี่ 700 MHz กำลังงานข้ออกจึงลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งในการใช้งานตัวกรองสัญญาณผ่านแทนความถี่ต่ำนี้ควรมีการลดตอนของสัญญาณลงอย่างรวดเร็วเมื่อถึงความถี่ที่ออคแบบให้มีการลดตอนของสัญญาณเท่ากับ 3 dB ไว้นั้นคือ ความมีการลดตอนของสัญญาณลงอย่างรวดเร็ว เมื่อถึงความถี่ 600 MHz ดังนั้นผลที่ได้จากการทดลองจึงยังคงคลาดเคลื่อนไปจากทุนฐานอยู่บ้าง จึงทำการออกแบบตัวกรองสัญญาณผ่านแทนความถี่ต่ำในย่าน UHF เพิ่มโดยให้มีค่าการลดตอนของสัญญาณเท่ากับ 3 dB ที่ความถี่ 500 MHz และทำการทดลองและบันทึกผลการทดลอง ด้วยวิธีเดิม เพื่อหาผลตอบสนองทางความถี่ของตัวกรองสัญญาณตัวนี้ซึ่งได้ผลดังนี้

ตารางที่ 4.3 ผลตอบสนองทางความถี่ เมื่อค่าการลดตอนของสัญญาณเท่ากับ 3 dB
ที่ความถี่ 500 MHz

ความถี่ (MHz)	กำลังงานข้อก (dB)
150.0	-40.3
200.0	-39.6
300.0	-41.2
400.0	-42.1
500.0	-43.1
600.0	-45.3
700.0	-49.6
800.0	-51.2
900.0	-54.3
1000.0	-55.9
2000.0	-55.0

จากผลการทดลองพบว่า ผลตอบสนองทางความถี่ตัวกรองสัญญาณผ่านแทนความถี่ต่ำในย่าน UHF เมื่อออคแบบให้ค่าการลดตอนของสัญญาณเท่ากับ 3 dB ที่ความถี่ 500 MHz มีการลดตอนของสัญญาณอย่างรวดเร็วที่ความถี่ประมาณ 500 MHz ซึ่งใกล้เคียงกับทุนฐาน



รูปที่ 4.3 กราฟแสดงผลตอบสนองทางความถี่ ของวงจรกรีดหอนช่องเสียงยูฟาน้ำทึบ 3 dB ที่ความถี่ 500 MHz

4.3 ผลการทดลองหากผลตอบสนองกำลังงานการคัปป์ลิ่งของตัวคัปเปลอร์แบบมีทิศทาง

เมื่อทำการทดลองหากผลตอบสนองกำลังงานการคัปป์ลิ่งของตัวคัปเปลอร์แบบมีทิศทางตามวิธีการทดลองในบทที่ 3 โดยตั้งความถี่ไว้ที่ 800 MHz และวันที่กผลการทดลองได้ดังนี้

เมื่อออคแบบให้ค่าสัมประสิทธิ์ของการเชื่อมต่อ มีค่าเท่ากับ 15 dB, $\xi_r = 4.8$ และระยะห่างระหว่างแคนในโครงสร้างที่เกิดการคัปป์ลิ่ง $S = 0.547 \text{ mm}$

กำลังงานข้ออ กของพอร์ตที่ 2 = .26.3 dB

กำลังงานข้ออ กของพอร์ตที่ 3 = 18.0 dB

จากผลการทดลองพบว่ากำลังงานข้ออ กทั้ง 2 พอร์ต ไม่เป็นไปตามทฤษฎีจึงออคแบบการทดลองเพิ่มโดยใช้หลักการคัปป์ลิ่งของคลื่นที่เกี่ยวกับระยะห่างระหว่างการคัปป์ลิ่งซึ่งมีผลต่อการคัปป์ลิ่งของคลื่นในตัวคัปเปลอร์แบบมีทิศทางดังนี้

เมื่อออคแบบให้ค่าสัมประสิทธิ์ของการเชื่อมต่อ มีค่าเท่ากับ 15 dB, $\xi_r = 4.8$ และระยะห่างระหว่างแคนในโครงสร้างที่เกิดการคัปป์ลิ่ง $S = 1.00 \text{ mm}$

กำลังงานข้ออ กของพอร์ตที่ 2 = 24.2 dB

กำลังงานข้ออ กของพอร์ตที่ 3 = 15.1 dB

จากผลการทดลองพบว่ากำลังงานข้ออ กพอร์ตที่ 2 ยังไม่เป็นไปตามทฤษฎี จึงทดลองออคแบบตัวคัปเปลอร์แบบมีทิศทางอีกรอบโดยเปลี่ยนค่าสภาพย้อมทางไฟฟ้า ξ_r จากเดิมเป็น 4.8 ให้เปลี่ยนเป็น $\xi_r = 4$ แทน เนื่องจากค่าสภาพย้อมทางไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงตามความถี่ที่ใช้งานและสารไดเล็กตริกที่เป็นสารอิฟือกซิซซิ่งถูกเลือกใช้ในโครงงานนี้ และไม่ทราบค่าที่แน่นอนของสภาพย้อมทางไฟฟ้าของอิฟือกซิซนี้ ณ ความถี่ที่เลือกใช้งาน 800 MHz จึงทดลองโดยการสุ่มค่าสภาพย้อมทางไฟฟ้าที่ใกล้เคียงมาใช้ในการทดลองดังนี้

เมื่อออคแบบให้ค่าสัมประสิทธิ์ของการเชื่อมต่อ มีค่าเท่ากับ 15 dB, $\xi_r = 4.0$ และระยะห่างระหว่างแคนในโครงสร้างที่เกิดการคัปป์ลิ่ง $S = 1.00 \text{ mm}$

กำลังงานข้ออ กของพอร์ตที่ 2 = 20.5 dB

กำลังงานข้ออ กของพอร์ตที่ 3 = 13.0 dB

จากผลการทดลองพบว่ากำลังงานข้ออ กของพอร์ตทั้ง 2 ลดลงจากเดิมเมื่อ $\xi_r = 4.8$ ดังนั้นจึงทดลองเพิ่มโดยการเพิ่มค่าสภาพย้อมทางไฟฟ้าจากเดิมเป็น $\xi_r = 5.0$ จะได้ผลดังนี้

เมื่อออคแบบให้ค่าสัมประสิทธิ์ของการเชื่อมต่อวีค่าเท่ากับ 15 dB, $\xi_r = 5.0$ และระยะห่างระหว่างແຕບໄนໂຄຣສຕຣີປໍທີ່ເກີດກາຮັບປັບລິງ $S = 1.0 \text{ mm}$

ກຳລັງຈານຂາອົກຂອງພວັດທີ່ 2 = 27.5 dB

ກຳລັງຈານຂາອົກຂອງພວັດທີ່ 3 = 14.6 dB

ຈາກຜລກກາຮັບປັບລິງພູນວ່າກຳລັງຈານຂາອົກຂອງພວັດທີ່ 2 ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກເດີມ ແຕ່ໃນພວັດທີ່ 3 ໄມ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ເມື່ອເຫັນກັນພລຂອງກາຮັບປັບລິງທີ່ $\xi_r = 4.8$

4.4 ສຽງ

ເມື່ອນຳແຜ່ນໄນໂຄຣສຕຣີປໍທີ່ອອກແຕບໃຫ້ມີລັກຍະກາຮັບປັບລິງພູນເປັນຕົວກອງສັງຢານຝາກພູນແຕບຄວາມຄືດໍາໃນຍ່ານ UHF ນາທຳກາຮັບປັບລິງຕາມວິທີກາຮັບປັບລິງໃນບທີ່ 3 ພລຕອນສານອງທາງຄວາມຄືດໍາໃດໆ ຈະເກີດຄວາມຄລາດເກລື່ອນໄປໄປ່ຕຽງຕາມທຖ່ງໝູງ ເມື່ອອອກແຕບໃຫ້ມີກຳລັງຈານຂາອົກຂອງສັງຢານເທົ່າກັນ 3 dB ທີ່ຄວາມຄື 800 MHz ແລະ ທີ່ຄວາມຄື 600 MHz ແລະ ເມື່ອອອກແຕບໃຫ້ມີກຳລັງຈານຂາອົກຂອງສັງຢານເທົ່າກັນ 3 dB ທີ່ຄວາມຄື 500 MHz ພລກາຮັບປັບລິງທີ່ຈະໄດ້ໄກສໍເຕີຍກັນທຖ່ງໝູງ ສ່ວນກາຮັບປັບລິງທາພລຕອນສານອງກຳລັງຈານກາຮັບປັບລິງຂອງຕົວກັບເປົລອົງແບບມີທີ່ກາຮັບປັບລິງນີ້ ພລກາຮັບປັບລິງເມື່ອອອກແຕບຕາມຫລັກກາຮັບປັບລິງທີ່ເສັນອນນີ້ ໄມເປັນໄປຕາມທຖ່ງໝູງ ແລະ ເມື່ອທຳກາຮັບປັບລິງໄດ້ໃຊ້ຫລັກກາຮັບປັບລິງ ແລະ ຫລັກກາຮັບປັບລິງ ແລ້ວ ພລກາຮັບປັບລິງຍັງ ຄົງໄມ່ເປັນໄປຕາມທຖ່ງໝູງເຫັນເດີມ

บทที่ 5

สรุป และวิเคราะห์ผลที่ได้จากการทดลอง

5.1 กล่าวว่า

ในบทที่ 3 ได้กล่าวถึงการออกแบบและวิธีการทดลองหาผลตอบสนองของไมโครสตริปที่ออกแบบเพื่อประยุกต์ใช้งาน 2 งาน คือ ให้สมอ่อนเป็นตัวกรองสัญญาณผ่านແบนความถี่ต่ำในย่าน UHF ซึ่งออกแบบให้มีค่าการลดthonของสัญญาณเท่ากับ 3 dB ที่ความถี่ 500 MHz 600 MHz และ 800 MHz และให้สมอ่อนเป็นตัวคัปเปลอร์แบบมีพิเศษ ซึ่งได้ออกแบบให้มีค่าสัมประสิทธิ์ของการเข้ามต่อของสัญญาณเท่ากับ 15 dB และใช้งานได้ที่ความถี่ 800 MHz ส่วนในบทที่ 5 นี้กล่าวถึงการสรุปผลที่ได้จากการทดลอง โดยแบ่งการสรุปเป็น 2 หัวข้อตามที่ได้ทำการออกแบบและการทำการทดลอง งานนี้ได้ทำการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการทดลอง ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ผลโดยรวมตั้งแต่การออกแบบ การสร้างอุปกรณ์และการทดลอง งานนี้ในขั้นสุดท้ายก็การสรุปประโยชน์ที่ได้จากการทำโครงการในครั้งนี้

5.2 สรุปผลที่ได้จากการทดลอง

5.2.1 ตัวกรองสัญญาณผ่านແบนความถี่ต่ำในย่าน UHF

ตัวกรองสัญญาณผ่านແบนความถี่ต่ำในย่าน UHF ที่ได้ทำการสร้างขึ้นจากไมโครสตริปซึ่งการออกแบบนี้ใช้วิธีการของ Butterworth หรือ Maximally-flat ในขั้นแรกได้ทำการออกแบบให้ตัวกรองสัญญาณผ่านແบนความถี่ต่ำในย่าน UHF มีค่าการลดthonของสัญญาณเท่ากับ 3 dB ที่ความถี่ 800 MHz เริ่มทำการทดลองที่ความถี่ 150 MHz เมื่อจากที่ความถี่ต่ำกว่า 150 MHz คลื่นจะถูกเหนี่ยวนำเข้าไปที่เครื่องรับโดยไม่ผ่านตัวกรองสัญญาณผ่านແบนความถี่ต่ำนี้เลยและจากผลการทดลองที่ความถี่ 150 MHz จะเห็นได้ว่ากำลังงานของอุบลร่องขึ้นไปเกลี้ยงกับกำลังงานขาเข้า ซึ่งผลต่างของค่ากำลังงานทั้งสองนี้ ณ ที่ความถี่นี้คือค่า Insertion Loss ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.3 dB และเมื่อทำการทดลองที่ความถี่สูงขึ้น ค่ากำลังงานของอุบลร่องลดลงไปเรื่อยๆ ซึ่งเห็นได้ว่าที่ความถี่ 800 MHz กำลังงานของอุบลร่องมีค่าการลดthonของสัญญาณเท่ากับ 3 dB ยังคงลดลงอย่างสม่ำเสมอถึงที่ความถี่ 1000 MHz กำลังงานของอุบลร่องลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งการนำไปใช้งานจริงนั้นค่ากำลังงานของอุบลร่องที่ความถี่มากกว่า 800 MHz เป็นต้นไป ควรที่จะมีค่ากำลังงานของอุบลร่องลดลงอย่างรวดเร็ว แสดงให้เห็นว่าตัวกรองสัญญาณผ่านແบนความถี่ต่ำในย่าน UHF ที่มีค่าการลดthonของสัญญาณเท่ากับ 3 dB ที่ความถี่ 800 MHz นี้ให้ผลตอบสนองทางความถี่ที่คลาดเคลื่อนອอกไป

ดังนั้นจึงได้ทำการทดสอบเพิ่มเติม โดยการออกแบบตัวกรองสัญญาณผ่านແນບຄວາມถີ່ຕໍ່າໃນຢ່ານ UHF ให้มีຄ່າการลดທອນຂອງສัญญาณເທົ່າກັນ 3 dB ທີ່ຄວາມຖີ່ 600 MHz เพื่ອດູພລຕອບສນອງທາງຄວາມຖີ່ເປົ້າຍນເທື່ອນກັນຕັ້ງກອງສัญญาณຜ່ານແນບຄວາມຖີ່ຕໍ່າທີ່ໄດ້ທົດລອງໃນຫັງຕັ້ນ ໂດຍໃຊ້ຫລັກຄາຣເດີມໃນກາຣອອກແບນ ແລະ ໃຊ້ວິທີກາຣເຊັ່ນເດີມໃນກາຣທົດລອງ ພລຈາກກາຣທົດສອບຈະເກີນໄດ້ວ່າຄ່າກໍາລັງງານຫາອອກທີ່ຄວາມຖີ່ປະມານ 700 MHz ມີຄ່າລົດລອຍ່າງຮວດເຮົວ ຜຶ່ງໃນການນໍາໄປໃຊ້ງານຈົງນີ້ ຄ່າກໍາລັງງານຫາອອກທີ່ຄວາມຖີ່ນຳກວ່າ 600 MHz ເປັນຕັ້ນໄປຄວາທີ່ຈະມີກໍາລັງງານຫາອອກລົດລອຍ່າງຮວດເຮົວ ແສດງວ່າຕັ້ງກອງສัญญาณຜ່ານແນບຄວາມຖີ່ຕໍ່າຈຶ່ງມີຄ່າກາຣลดທອນຂອງສัญญาณເທົ່າກັນ 3 dB ທີ່ຄວາມຖີ່ 600 MHz ນີ້ໃຫ້ພລຕອບສນອງທາງຄວາມຖີ່ທີ່ຍັງຄົກຄາດເກລື່ອນອອກໄປ

ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ກຳກາຣອອກແບນແລ້ວສ້າງຕັ້ງກອງສัญญาณຜ່ານແນບຄວາມຖີ່ຕໍ່າໃນຢ່ານ UHF ເພີ່ມເຕີມ ໂດຍອອກແບນໃໝ່ມີຄ່າກາຣลดທອນຂອງສัญญาณເທົ່າກັນ 3 dB ທີ່ຄວາມຖີ່ 500 MHz ເພື່ອດູພລຕອບສນອງທາງຄວາມຖີ່ເປົ້າຍນເທື່ອນກັນຕັ້ງກອງສัญญาณຜ່ານແນບຄວາມຖີ່ຕໍ່າໃນຢ່ານ UHF 2 ຕັ້ງຫັງຕັ້ນ ໂດຍໃຊ້ຫລັກຄາຣເດີມໃນກາຣອອກແບນແລະ ໃຊ້ວິທີກາຣເດີມໃນກາຣທົດລອງ ພລຈາກກາຣທົດລອງຈະເກີນວ່າຄ່າກໍາລັງງານຫາອອກທີ່ຄວາມຖີ່ປະມານ 500 MHz ມີຄ່າກາຣลดທອນຂອງສัญญาณເທົ່າກັນ 3 dB ແລະ ຄ່າກໍາລັງງານຫາອອກທີ່ຄວາມຖີ່ນຳກວ່າ 500 MHz ເປັນຕັ້ນໄປມີຄ່າລົດລອຍ່າງຮວດເຮົວ ຜຶ່ງເປັນຄ່າທີ່ໄກລ້າເກີຍກັນທຸນ໌ນີ້

5.2.2 ຕັ້ວັກປັບປຸງແບນມີທິກາທາງ

ຕັ້ວັກປັບປຸງແບນມີທິກາທາງທີ່ທຳກາຣສ້າງຈາກໄນ້ໂຄຣສຕຣີປີ ໄດ້ອອກແບນໃໝ່ມີກາຣໃຊ້ງານທີ່ຄວາມຖີ່ 800 MHz ແລະ ມີຄ່າສັນປະລິທີກາຣເຊື່ອມຕ່ອເທົ່າກັນ 15 dB ພລທີ່ໄດ້ຈາກກາຣທົດລອງກືອຄ່າກໍາລັງງານຫາອອກທີ່ພອຣີ 3 ມີຄ່າເທົ່າກັນ 18 dB ແລະ ຄ່າກໍາລັງງານຫາອອກທີ່ພອຣີ 2 ມີຄ່າເທົ່າກັນ 26.3 dB ຜຶ່ງຈະເກີນໄດ້ວ່າໄໝເນື່ອນໄປຕາມທຸນ໌ນີ້ ຈຶ່ງໄດ້ກຳກາຣເປົ້າຍແປ່ງກ່າວພາຣາມີເຕେວົງທີ່ຄາດວ່າຈະມີຜລຕ່ອກເຮື່ອມຕ່ອບອງຄລື່ນກາຍໃນຕັ້ວັກປັບປຸງແບນມີທິກາທາງດັ່ງນີ້ ຈາກກາຣສຶກນາທຸນ໌ນີ້ ກາຣອອກແບນຕັ້ວັກປັບປຸງໃນຫຊວໜ້ວ 2.4 ທ່ານໄທການວ່າພາຣາມີເຕେວົງທີ່ມີຜລຕ່ອກເຮື່ອມຕ່ອບອງຄລື່ນກາຍໃນຕັ້ວັກປັບປຸງແບນມີທິກາທາງ ໄດ້ແກ່ ຮະຍະໜ່າງຮ່ວງແນບໄນ້ໂຄຣສຕຣີປີທີ່ເກີດກາຣເຊື່ອມຕ່ອບອງຄລື່ນ (S) ແລະ ຄ່າສກາພຍອມສັນພັກທີ່ທາງໄຟຟ້າປະລິທີຜລ (E_{sl}) ດັ່ງນັ້ນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ກໍາລັງຫາອອກທີ່ພອຣີ 3 ແລະ ພອຣີ 2 ມີຄ່າເທົ່າກັນ 15 dB ຕາມທີ່ໄດ້ອອກແບນໄວ້ ຈຶ່ງທຳກາຣເລື່ອນຮະຍະໜ່າງຮ່ວງແນບໄນ້ໂຄຣສຕຣີປີທີ່ເກີດກາຣເຊື່ອມຕ່ອບອງຄລື່ນໃຫ້ກໍາລັງງານທີ່ພອຣີ 3 ມີຄ່າໄກລ້າເກີຍ 15 dB ນາກທີ່ສຸດເທົ່າກັນ 1 ມີລັບແມຕຣ ແຕ່ຈະເກີນໄດ້ວ່າຄ່າກໍາລັງງານຫາອອກທີ່ພອຣີ 2 ມີຄ່າໄໝເທົ່າກັນ 15 dB

ดังนั้นจึงได้ทำการเปลี่ยนค่าสภาพย้อมส้มพันธุ์ เมื่อจากว่าค่าสภาพย้อมส้มพันธุ์ทางไฟฟ้าประสิทธิผลมีค่าเปลี่ยนแปลงตามความถี่ และไม่ทราบแน่ว่าที่ความถี่ 800 MHz นั้นค่าสภาพย้อมส้มพันธุ์ทางไฟฟ้าประสิทธิผลมีค่าเท่าไหร่ ดังนั้นจึงทดลองใช้ค่าสภาพย้อมส้มพันธุ์ทางไฟฟ้าประสิทธิผลที่น้อยกว่า 4.8 คือ 4.0 และที่มากกว่า 4.8 คือ 5.0 ในกรอบแบบแทน แต่ผลที่ได้จากการทดลองยังคงให้ค่ากำลังงานข้ออกรีต 3 และพรอร์ต 2 มีค่าไม่เท่ากับ 15 dB อยู่เช่นเดิม

5.3 วิเคราะห์ผลที่ได้จากการทดลอง

จากผลการทดลอง จะเห็นได้ว่าผลตอบสนองของไมโครสตริปที่ออกแบบเพื่อประยุกต์ใช้งานนั้นมีค่าคลาดเคลื่อนไปจากทฤษฎี ซึ่งสามารถวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดความคลาดเคลื่อนได้ดังต่อไปนี้

5.3.1 ค่าสภาพย้อมส้มพันธุ์ทางไฟฟ้าประสิทธิผล ซึ่งค่าดังกล่าวเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญในการคำนวณหาค่าพารามิเตอร์อื่น ๆ ในโครงงานนี้ และค่านี้มีการเปลี่ยนแปลงค่าตามความถี่ที่ใช้งาน เนื่องจากตัวกรองสัญญาณผ่านແตนความถี่ต่ำในย่าน UHF นั้น ต้องทำการเปลี่ยนแปลงความถี่ที่ใช้ในการทดลองเพื่อผลตอบสนองทางความถี่ โดยเริ่มตั้งแต่ที่ความถี่ 150 MHz ถึง 2000 MHz ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของค่าสภาพย้อมส้มพันธุ์ทางไฟฟ้าประสิทธิผลที่ใช้ในการคำนวณในโครงงานนี้ นอกจากนั้นสารไดเล็กตริกที่เลือกใช้ในโครงงานนี้คือ สารอีพ็อกซีนั้น ไม่มีรายละเอียดของค่าสภาพย้อมส้มพันธุ์ทางไฟฟ้าประสิทธิผลอ้างอิงเลย

5.3.2 จากการสังเกตผลการทดลองของตัวกรองสัญญาณผ่านແตนความถี่ต่ำในย่าน UHF ที่ได้สร้างขึ้นนั้น พบว่าตัวกรองสัญญาณผ่านແตนความถี่ต่ำที่ออกแบบให้มีค่าการลดTHONของสัญญาณเท่ากับ 3 dB ณ ความถี่ 500 MHz ให้ผลตอบสนองทางความถี่ต่ำกว่าตัวกรองสัญญาณผ่านແตนความถี่ต่ำที่ออกแบบให้มีค่าการลดTHONของสัญญาณเท่ากับ 3 dB ณ ความถี่ 600 MHz และ 800 MHz นั้นอาจเป็นเพราะว่าสารไดเล็กตริก คือ อีพ็อกซีที่ใช้ในโครงงาน มีการกำหนดช่วงความถี่ที่ใช้งาน แต่เนื่องจากไม่ทราบถึงช่วงความถี่ที่ใช้งานของอีพ็อกซีนี้ จึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ตัวกรองสัญญาณผ่านແตนความถี่ต่ำที่ออกแบบให้มีค่าการลดTHONของสัญญาณเท่ากับ 3 dB ณ ความถี่ 600 MHz และ 800 MHz ให้ผลตอบสนองทางความถี่มีค่าคลาดเคลื่อนออกไป ส่วนในกรณีของตัวคัปเปลอร์แบบมีทิศทางที่ออกแบบการใช้งานที่ความถี่ 800 MHz อาจเกิดจากสาเหตุในกรณีเดียวกัน

5.3.3 ในการสร้างอุปกรณ์จากไมโครสตริปนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความชำนาญและความประณีตอย่างสูงในการทำลายบนแผ่นพิมพ์สองหน้า การพ่นสเปรย์เพื่อไม่ให้เกิดสนิม

และ การบัดกรีระหว่างสายส่งสัญญาณกับอุปกรณ์ไมโครสตริป ในแต่ละครั้งของการแก้ไข ซึ่งจะทำการบัดกรีข้ามแล้วข้ามอีก ทำให้หัวต่อที่ถูกบัดกรีปอยครั้งเกิดการชำรุดหรือเสื่อมสภาพได้ และถ้าไม่มีความระมัดระวังในการบัดกรี ความร้อนจากหัวแร้งอาจทำให้สารไดเล็กตริกเกิดความเสียหายได้ ดังนั้นในการทำแต่ละครั้งควรตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของอุปกรณ์ต่าง ๆ และการมีความระมัดระวังอย่างสูง

5.3.4 สาเหตุอีกประการหนึ่งซึ่งสำคัญมากนั้นคือ เนื่องจากห้องปฏิบัติการยังขาดเครื่องมือที่ใช้ในการวัดค่าพารามิเตอร์ภายในของอุปกรณ์ในโครงงานนี้ ดังนั้นจึงไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า ค่าพารามิเตอร์ภายในที่แท้จริงของอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นนั้นมีค่าตรงตามทฤษฎีที่ใช้ในการออกแบบ หรือไม่ ซึ่งถ้าค่าพารามิเตอร์ภายในมีค่าคลาดเคลื่อนไปจากทฤษฎีที่ได้ออกแบบไว้ จะไม่สามารถทราบและทำการแก้ไขได้เลย ค่าพารามิเตอร์ภายในที่คลาดเคลื่อนไปนี้ มีผลกระทบอย่างมาก ต่อผลตอบสนองของอุปกรณ์ที่ได้สร้างขึ้น เพราะว่า อุปกรณ์ที่ออกแบบไว้นี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งาน ที่ความถี่สูง

5.4 ประโยชน์ที่ได้จากการโครงงาน

ในปัจจุบัน ไมโครสตริปถูกนำไปใช้กับระบบการสื่อสารมาก ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวกับ อุปกรณ์ต่าง ๆ ทางการสื่อสาร เช่น สายอากาศ สายนำสัญญาณ และอุปกรณ์อื่น ๆ ดังนั้น ประโยชน์ที่ได้รับโดยตรงจากโครงงานนี้ คือ ความรู้ในเรื่องของไมโครสตริป และความรู้ในเรื่อง ของการออกแบบไมโครสตริปเพื่อประยุกต์ใช้งานให้สามารถใช้ได้สมอ่อนเป็นตัวรองสัญญาณ ผ่านแทนความถี่ต่างในย่าน UHF และตัวคัปเปลอร์แบบมีทิศทาง จากการศึกษาเรื่องไมโครสตริป ทำให้ทราบว่าพารามิเตอร์สำคัญของไมโครสตริป ได้แก่ ค่าอัตราส่วนระหว่างความกว้างของ แบบไมโครสตริปกับความหนาของสาร ไดเล็กตริก และความยาวของแบบไมโครสตริป เพราะว่า ค่าลักษณะสมบัติทางอิมพีเดนซ์ของไมโครสตริปนั้น ถูกกำหนดด้วยพารามิเตอร์ดังกล่าว และ จากการศึกษาการออกแบบไมโครสตริปเพื่อประยุกต์ให้สามารถใช้งานได้สมอ่อนเป็นตัวรอง สัญญาณผ่านแทนความถี่ต่างในย่าน UHF และตัวคัปเปลอร์แบบมีทิศทางนั้น นอกจากหลักการ พื้นฐานของไมโครสตริปเกี่ยวกับพารามิเตอร์ดังกล่าวที่เป็นตัวสำคัญในการออกแบบแล้ว เรื่องของการซัดเซย์ที่เป็นสิ่งสำคัญอีกส่วนหนึ่ง เพราะรูปร่างของไมโครสตริปที่ออกแบบมาเพื่อ ประยุกต์ใช้งานนั้นแตกต่างไปจากลักษณะของไมโครสตริปที่เป็นสายส่งสัญญาณธรรมด้า ดังนั้น การเดินทางของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงได้มีอีกเดินทางผ่านแบบไมโครสตริป เช่น ตัวรองสัญญาณผ่านแทนความถี่ต่างในย่าน UHF นั้นจะมีรูปร่างเป็นสเตป และตัวคัปเปลอร์ แบบมีทิศทางนั้นจะมีช่วงที่เกิดการหักงออย่างกระทันหัน ดังนั้นการซัดเซย์จึงจำเป็นต้องคำนึงถึง

ในการออกแบบ เพื่อให้การเดินทางของคลื่นแม่เหล็กที่เปลี่ยนไปนั้น มีผลต่อค่าลักษณะสมบัติทางอิมพีเดนซ์โดยรวมของไมโครสตริปที่ออกแบบมาเพื่อประยุกต์ใช้งานน้อยที่สุด

นอกจากความรู้ที่ได้จากการศึกษาแล้ว ในการทดลองยังให้ประสบการณ์ ความเข้าใจ และความคิดในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอีกด้วย เนื่องจากการกัดแผ่นวงจรพิมพ์สองหน้าให้ได้ขนาดของแอมไมโครสตริปตามที่ออกแบบไว้ทั้ง 2 อุปกรณ์นั้น ต้องทำด้วยมือทึ้งหมดทำให้ได้ความชำนาญในเรื่องของการกัดลายแผ่นวงจรพิมพ์สองหน้า และเมื่อผลการทดลองที่ได้ไม่ตรง กับทฤษฎี ทำให้ต้องคิดหาทางแก้ไขเพื่อให้ผลออกมากกว่าเดิม ซึ่งต้องอาศัยความรู้ที่ได้จาก การศึกษา การประมวลผลและประมวลสารเหตุ มาใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นการฝึกให้คิดอย่าง มีเหตุมีผล และสุดท้ายได้มีโอกาสใช้เครื่องมือที่สำคัญอย่างเครื่อง RF Generator และเครื่อง Spectrum Analyser จึงได้ความรู้ในเรื่องของการใช้เครื่องมือเหล่านี้อีกด้วย

เอกสารอ้างอิง

- [1] คณะอนุกรรมการปรับปรุงศักยภาพนิคทางวิศวกรรมไฟฟ้าในคณะกรรมการวิชาการสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย. ศักยภาพนิคทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร,
กรุงเทพมหานคร : คณะอนุกรรมการปรับปรุงศักยภาพนิคทางวิศวกรรมไฟฟ้า
- [2] บัณฑิต ใจน้อ อารยานนท์, วิศวกรรมไมโครเวฟ. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลง
กรณ์
มหาวิทยาลัย , 2536
- [3] Fook, E.H., and Zakarevicius, R.A. Microwave Engineering Using Microstrip Circuit ,
New York : Prentice Hall, 1990
- [4] Jansen, R.H., "High-speed computation of single and couples microstrip parameters
including dispersion, high-order modes, loss and finite strip thickness", IEEE Trans.
Microwave Theory and Techniques, Vol. MTT-26 No. 2, February 1978, pp. 75-82.
- [5] Kirschning, M. and Jansen, R.H., "Accurate wide-range design equation for the
frequency-
dependent characteristic of parallel coupled microstrip lines". IEEE Trans. Microwave
Theory and Techniques, Vol. MTT-32, No. 1, January 1984, pp.83-90. Corrections: IEEE
Trans. Microwave Theory and Techniques, Vol.MTT-33, No. 3, March 1985,p. 288.
- [6] The American Radio Relay League. The ARRL UHF/Microwave Experimenter's
Manual Antennas, Components and Design. America : Newington, 1990
- [7] Young, H. Paul, "Microstrip Design Laboratory", IEEE Trans. Microwave Theory and
Techniques, Vol. MTT-34, No. 1, February 1991

ประวัติผู้เขียน



ชื่อ นางสาวนันทิพย์ภา อินทราวาช
เกิดวันที่ 29 เมษายน 2518
ภูมิลำเนา จังหวัดอุตรธานี
การศึกษา ระดับประถม โรงเรียนเซ็นเมรี จังหวัดอุตรธานี
ระดับมัธยมต้น โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุตรธานี
ระดับมัธยมปลาย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุตรธานี
ปัจจุบันกำลังศึกษา สาขาวิชาศิลกรรมโถรคณากาศ ปีที่ 4
สำนักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่อยู่ปัจจุบัน
74 ถ.บ้านโนน อ.เมือง จ.อุตรธานี 41000



ชื่อ นางสาวเนตรนภา สุขวงศ์
เกิดวันที่ 28 มีนาคม 2518
ภูมิลำเนา จังหวัดชัยภูมิ
การศึกษา ระดับประถม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ระดับมัธยมต้น โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ระดับมัธยมปลาย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ปัจจุบันกำลังศึกษา สาขาวิชาศิลกรรมโถรคณากาศ ปีที่ 4
สำนักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ที่อยู่ปัจจุบัน

134/1-4 บ้านหนองหลอด ต.ชัยภูมิ-บ้านเขว้า ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

